

股票简称：东微半导

股票代码：688261



苏州东微半导体股份有限公司

Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited

(江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋)

向不特定对象发行可转换公司债券

募集说明书

(申报稿)

保荐机构（主承销商）



中国国际金融股份有限公司

(住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

二零二六年九月

声 明

本公司及全体董事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。

重大事项提示

本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文内容，并特别关注以下重要事项。

一、不满足投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持本次可转债不能转股的风险

公司为科创板上市公司，本次向不特定对象发行可转债，参与可转债转股的投资者，应当符合科创板股票投资者适当性要求。如可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求的，可转债持有人将不能将其所持的可转债转换为公司股票。

公司本次发行可转债设置了赎回条款，包括到期赎回条款和有条件赎回条款，到期赎回价格由公司股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，有条件赎回价格为面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在所持可转债面临赎回的情况下，考虑到其所持可转债不能转换为公司股票，如果公司按事先约定的赎回条款确定的赎回价格低于投资者取得可转债的价格（或成本），投资者存在因赎回价格较低而遭受损失的风险。

公司本次发行可转债设置了回售条款，包括有条件回售条款和附加回售条款，回售价格为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有人不符合科创板股票投资者适当性要求，在满足回售条款的前提下，公司可转债持有人要求将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司，公司将面临较大可转债回售兑付资金压力并存在影响公司生产经营或募投项目正常实施的风险。

二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级

本次可转换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《苏州东微半导体股份有限公司 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：中鹏信评【2026】第 Z【1460】号 01），发行人主体信用评级为 AAst_i，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA。

本次发行的可转换公司债券存续期内，评级机构将每年至少进行一次跟踪评级。如

果由于外部经营环境、公司自身情况或评级标准变化等因素，导致本次可转换公司债券信用评级降低，将会增大投资者的投资风险，对投资者的利益产生一定影响。

三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项

本次向不特定对象发行可转债不设担保。敬请投资者注意本次可转换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。

四、特别风险提示

本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书“第三节 风险因素”全文，并特别注意以下风险。

（一）业绩大幅下滑甚至亏损的风险

半导体行业具有较强的周期性特征，其景气周期与宏观经济、下游应用需求及产能库存等因素紧密相关。报告期各期，公司主营业务收入分别为 97,285.03 万元、100,258.96 万元、125,242.67 万元和 73,137.85 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 14,002.50 万元、4,023.51 万元、4,621.04 万元和 10,630.18 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 11,941.51 万元、231.93 万元、789.71 万元和 68.92 万元。2024 年度，公司保持了主要产品销量的同比上升，整体销售规模较上年同期小幅增加，但由于产品销售价格下降、期间费用增加等因素的影响，公司 2024 年度净利润情况出现较大幅度下滑。

功率器件广泛应用于工业制造、新能源、汽车电子、通信运输、消费电子等领域，若宏观经济波动较大或长期低迷，将导致行业市场需求萎缩、客户对成本和库存更趋谨慎，产品销售价格和销量均可能受到不利影响，进而影响公司经营业绩和盈利能力。此外，高效算力服务器、高速通信等新兴赛道虽为功率器件带来广阔空间，但也存在产业政策调整、下游需求不及预期、技术迭代和产品落地进展不顺等不确定性，若公司相关布局推进不畅，则公司业绩可能出现持续下滑甚至亏损的风险。

（二）经营性现金流量为负的风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,054.72 万元、-8,831.32 万元、-19,172.92 万元和-12,930.39 万元，2024 年以来，公司经营性现金流量持续为负。报告期内，公司经营活动现金流入主要来自功率器件、晶圆和数模混合控制芯片的销售，

经营活动现金流出主要用于原材料采购及职工薪酬支付。未来随着公司业务规模持续扩大，若公司经营业绩不及预期、储备的存货无法及时实现销售、客户未能及时支付货款，将导致公司面临一定的流动性风险，进而给公司的生产经营和本次可转债的本息兑付带来一定不利影响。

（三）应收账款回收风险

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 11,549.41 万元、16,294.43 万元、15,514.40 万元和 25,405.32 万元，占流动资产的比例分别为 4.18%、5.82%、5.81%及 10.30%。未来随着公司销售业务规模的扩大和销售收入的增长，应收账款存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出现经营不善或其他重大不利变化情形，从而不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（四）存货减值的风险

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 34,035.05 万元、36,060.22 万元、54,789.84 万元和 68,442.21 万元，占流动资产的比例分别为 12.32%、12.87%、20.53%及 27.76%。公司存货的可变现净值受到下游市场情况变动的影响，未来，如果公司下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，可能导致存货无法顺利实现销售，公司或将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

（五）毛利率波动的风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 22.73%、14.29%、16.23%和 17.40%。公司综合毛利率受产品售价、产品成本以及产品结构等因素影响。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司需要根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化、或公司技术实力停滞不前、或公司未能有效控制产品成本、或公司产品市场竞争格局发生变化等都将导致公司发生产品售价和成本预期外波动等不利情形。在该等不利情况下，公司综合毛利率水平未来可能会持续波动甚至出现下降，从而对公司的经营带来一定风险。此外，公司的产品规格数量较多，不同规格的产品销售结构的变化亦会对公司的毛利率造成影响。

（六）募投项目实施相关风险

1、募投项目实施进度不及预期的风险

公司本次募投项目新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金是在发行人主营业务基础上依据业务发展规划和发行人发展战略制定。虽然公司根据行业发展现状和趋势对本次募投项目可行性进行了深入研究和充分论证，并在技术、人员、市场等方面作了较为充分的准备，但若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司募投项目存在不能全部按期建设完成的风险。

2、募投项目研发成果不达预期及产业化进程受阻的风险

本次募投项目是围绕公司主营业务，在当前产品的基础上进行的升级、迭代及拓展，并在 IC 产品领域研发并推出新产品，与公司现有业务高度关联并具有较强的协同效应，但若公司未能准确把握技术发展方向，研发过程中未能突破关键技术难点，流片或验证结果不达预期，产品性能、良率、可靠性或成本无法满足客户及量产要求，可能导致未来募投项目实施、新产品的市场开拓、以及相关产品验证进度不及预期或下游客户的采购需求不及预期，可能存在募投项目短期内无法盈利的风险，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

3、募投项目研发费用、新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

公司本次募投项目新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目，包含规模较大的研发费用支出和一定的资本性支出。随着项目实施，公司研发费用及新增资产折旧摊销预计将有所增加，而研发成果形成、客户验证及产业化放量需要一定周期。尽管公司已对相关项目进行了审慎论证，但受技术迭代、下游需求变化及市场竞争等因素影响，项目实施效果及收益释放仍存在不确定性。若项目新增收益无法及时覆盖相关费用，公司未来将可能面临净利润水平下滑、净资产收益率下降和毛利率水平下降的风险，从而对公司的盈利能力造成一定的负面影响。

4、募集资金投资项目效益低于预期的风险

公司已对新型功率器件技术和产品研发及产业化项目和新一代功率管理控制芯片

研发及产业化项目进行了效益测算，相关测算基于项目按期实施、产品顺利完成研发验证并实现销售，以及依据可研报告编制当时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息测算得出。若未来项目实施或产品研发验证进度滞后，行业技术路线、下游市场需求或竞争格局发生不利变化，客户导入及销售放量不及预期，可能导致项目效益释放晚于预期，实际收入、利润及投资回报低于预期，进而对公司经营业绩造成不利影响。

（七）宏观环境风险

近年来，国际经贸环境持续变化，国际贸易政策仍存在一定不确定性。若因国际贸易摩擦导致公司业务开展受限、供应商供货中断或客户采购受到约束，公司正常的生产经营活动将受到不利影响。若全球贸易摩擦进一步升级，境外供应商亦可能面临限制甚至被禁止向公司供货。上述情形一旦发生，均可能对公司经营造成不利影响。

（八）其他风险

1、本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，将对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑能力。

2、可转债到期未能转股的风险

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临较大的资金压力。

3、可转债发行摊薄即期回报的风险

本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。本次可转债发行有助于公司增强盈利能力、提高抗风险能力。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产

将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

4、可转债交易价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、本公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现波动，从而影响投资者的投资收益。为此，本公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇到的风险，以便作出正确的投资决策。

5、可转债存续期内转股价格向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价格将向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数量也将相应增加。这将导致原有股东股本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。

6、可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，由于修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的

实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案可能未能通过公司股东会审议。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。

7、可转债提前赎回的风险

本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。如果公司行使上述有条件赎回的条款，可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

8、可转债转换价值降低的风险

公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

9、不可抗力的风险

在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但不排除包括政治、政策、经济、自然灾害等在内的不可控因素可能会对本公司的正常生产经营产生不利影响，提示投资者关注相关风险。

五、关于公司的股利分配政策

（一）公司现行利润分配政策

根据公司现行有效的《公司章程》，公司的利润分配政策如下：

“第一百五十八条 公司的利润分配政策及其决策程序

（一）公司的利润分配政策

1.利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

2.利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。

3.中期利润分配：在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

4.现金利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%。

5.股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

6.如公司董事会作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露。

7.公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（二）公司的差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第 3 项规定处理。

（三）公司的利润分配政策决策程序

1.公司的利润分配政策由董事会本章程规定、公司盈利情况、资金供给和需求等提出、拟定，经董事会审议通过后，提请股东会审议。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

2.独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。在股东会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

3.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整方案供股东会审议。

4.存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

（1）公司 2023 年度利润分配方案

2024 年 5 月 20 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利 1.786 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 3 股，不送红股，合计派发现金红利 16,805,375.39 元（含税），合计转增 28,228,514 股。

2024 年 6 月 13 日，公司发布《关于调整 2023 年度利润分配方案每股现金分红金额及资本公积金转增股本总额的公告》，因公司新增回购股份，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，也不参与资本公积金转增股本，公司调整实际参与利润分配的股本总数，按照现金分红分配总额不变、每股转增比例不变的原则，每 10 股现金红利金额调整为 1.7875 元（含税），合计派发现金红利 16,805,200.20 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计转增股本总额调整为 28,204,532 股。

（2）公司 2024 年度利润分配方案

2025 年 5 月 20 日，公司召开了 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，每 10 股派发现金红利 0.3955 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利 4,828,920.09 元（含税）。

（3）公司 2025 年度利润分配方案

2026 年 5 月 20 日，公司召开了 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.7540 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股，合计拟派发现金红利 9,242,153.12 元（含税）。

2、最近三年现金股利分配情况

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	4,621.04	4,023.51	14,002.50
现金分红（含税）	924.22	482.89	1,680.52
当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例	20.00%	12.00%	12.00%
最近三年累计现金分配合计	3,087.63		
最近三年年均可分配利润	7,549.02		
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	40.90%		

（三）公司未来三年分红规划

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2026年7月1日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《苏州东微半导体股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，并于2026年7月20日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《苏州东微半导体股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施和承诺

（一）公司应对本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取的措施

由于本次发行可能导致公司每股收益有所下降，为有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司持续回报股东的能力，公司将采取多项措施，具体如下：

1、提升公司的盈利能力和发展潜力，扩大公司业务规模

公司将继续立足于高性能功率器件和控制驱动 IC 相关核心关键技术的研发，并加快推动技术产业化应用工作，一方面，公司将持续增强现有产品竞争力，拓展优质客户，提高公司的市场地位、盈利能力和综合实力；另一方面，公司也将继续加强对新产品的研发力度，加快推动新产品的产业化进程。

2、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理办法，

对募集资金的专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行了明确的规定，公司将根据相关法律法规和募集资金管理办法的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。

本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

3、完善公司治理结构，提升经营和管理效率

公司将严格遵循相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权；为公司发展提供制度保障，提升经营和管理效率。

4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司已制定了健全有效的利润分配政策和股东回报机制。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的实施和落实，不等于对公司未来利润做出保证。

（二）公司的实际控制人及其一致行动人、全体董事、高级管理人员关于本次发行摊薄即期回报填补措施的承诺

1、公司实际控制人及其一致行动人的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人及其一致行动人作如下承诺：

- （1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）本人将切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及本承诺。若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

（3）自本承诺出具之日起至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

2、公司董事、高级管理人员的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）公司未来如实施股权激励计划，本人承诺股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺。若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

（7）本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

目 录

声 明	1
重大事项提示	2
一、不满足投资者适当性要求的投资者进入转股期后所持本次可转债不能转股的风险.....	2
二、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用评级.....	2
三、关于公司本次发行可转换公司债券的担保事项.....	3
四、特别风险提示.....	3
五、关于公司的股利分配政策.....	9
六、向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的应对措施和承诺.....	12
目 录	15
第一节 释义	19
第二节 本次发行概况	24
一、发行人基本情况.....	24
二、本次发行的背景和目的.....	25
三、本次发行的基本情况.....	26
四、本次发行有关机构.....	38
五、发行人与本次发行相关机构的关系.....	40
第三节 风险因素	41
一、与发行人相关的风险.....	41
二、其他风险.....	45
第四节 发行人基本情况	48
一、发行人股本结构及前十名股东持股情况.....	48
二、科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施.....	48
三、公司组织结构及重要权益投资情况.....	51
四、控股股东及实际控制人的基本情况.....	52
五、发行人、实际控制人以及发行人董事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况以及与本次发行相关的承诺事项.....	54

六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况.....	57
七、公司的特别表决权股份或类似安排.....	67
八、协议控制架构.....	67
九、公司所处行业基本情况.....	67
十、公司主营业务的具体情况.....	81
十一、与公司产品有关的技术情况.....	89
十二、公司主要固定资产、无形资产情况.....	93
十三、公司拥有的特许经营权情况.....	95
十四、发行人报告期内重大资产重组情况.....	95
十五、公司的境外经营情况.....	96
十六、报告期内的分红情况.....	96
十七、最近三年公开发行的债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形.....	100
十八、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况.....	100
十九、本次发行符合理性融资，合理确定融资规模.....	100
第五节 财务会计信息与管理层分析	102
一、最近三年及一期财务报表审计情况.....	102
二、最近三年及一期财务报表.....	102
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况.....	107
四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表.....	108
五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正.....	111
六、财务状况分析.....	112
七、经营成果分析.....	137
八、现金流量分析.....	151
九、资本性支出分析.....	153
十、技术创新分析.....	154
十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及重要期后事项.....	157
十二、本次发行的影响.....	157
第六节 合规经营与独立性	159
一、公司报告期内受到的行政处罚情况.....	159

二、公司及其董事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况	159
三、资金占用和对控股股东、实际控制人的担保情况	159
四、同业竞争	159
五、关联交易	160
第七节 本次募集资金运用	169
一、本次募集资金投资项目计划	169
二、本次募集资金投资项目的具体情况	170
三、本次募集资金用于研发投入的情况	189
四、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式	192
五、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响	194
六、本次募集资金投资项目的资本性投入情况	194
第八节 历次募集资金运用	196
一、最近五年内募集资金基本情况	196
二、前次募集资金实际使用情况	197
三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用	202
四、会计师对前次募集资金运用所出具的专项报告结论	203
五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况	203
第九节 声明	204
一、发行人及全体董事、审计委员会、高级管理人员声明	204
二、发行人实际控制人声明	207
三、保荐人（主承销商）声明	208
四、发行人律师声明	211
五、会计师事务所声明	212
六、资信评级机构声明	213
七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺	214
第十节 备查文件	217
附录一：发行人及其子公司拥有的境内注册商标	218

附录二：发行人及其子公司拥有的境外注册商标	221
附录三：发行人及其子公司拥有的境内专利	222
附录四：发行人及其子公司拥有的境外专利	230
附录五：发行人及其子公司拥有的软件著作权	236
附录六：发行人及其子公司拥有的集成电路布图设计专有权	237
附录七：债券持有人会议规则主要内容	242
一、债券持有人行使权利的形式.....	242
二、债券持有人会议规则的主要条款.....	242

第一节 释义

本募集说明书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

一、一般释义		
公司、本公司、发行人、东微半导	指	苏州东微半导体股份有限公司
东微有限	指	苏州东微半导体有限公司，系苏州东微半导体股份有限公司前身
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
财政部	指	中华人民共和国财政部
工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
科技部	指	中华人民共和国科学技术部
英飞凌	指	Infineon Technologies AG
安森美	指	ON Semiconductor Corporation
意法半导体	指	ST Microelectronics N.V.
瑞萨	指	Renesas Electronics Corporation
日本东芝	指	株式会社东芝
华润微	指	华润微电子有限公司
宏微科技	指	江苏宏微科技股份有限公司
新洁能	指	无锡新洁能股份有限公司
士兰微	指	杭州士兰微电子股份有限公司
南芯科技	指	上海南芯半导体科技股份有限公司
比亚迪	指	比亚迪股份有限公司
思格新能源	指	思格新能源(上海)股份有限公司
麦格米特	指	深圳麦格米特电气股份有限公司
德州仪器	指	Texas Instruments Incorporated
三菱电机	指	三菱电机株式会社
富士电机	指	富士电机株式会社
日立制作所	指	株式会社日立制作所
华虹宏力	指	华虹宏力半导体有限公司
粤芯半导体	指	粤芯半导体技术股份有限公司
深圳慧能泰	指	深圳慧能泰半导体科技有限公司
上海慧能泰	指	上海慧能泰半导体科技有限公司
香港慧能泰	指	慧能泰半导体科技（香港）有限公司

美国慧能泰	指	Hynetek Semiconductor Technology Inc.
可转债	指	可转换公司债券
本次可转债	指	苏州东微半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
本次发行	指	本公司拟向持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币143,588.00万元（含143,588.00万元）的行为
尽职调查报告	指	《中国国际金融股份有限公司关于苏州东微半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》
律师工作报告	指	《浙江天册律师事务所关于苏州东微半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》
法律意见书	指	《浙江天册律师事务所关于苏州东微半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》
本次募集资金投资项目、募投项目	指	新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
保荐机构、主承销商、受托管理人、中金公司	指	中国国际金融股份有限公司
发行人律师、天册律师事务所	指	浙江天册律师事务所
审计机构	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	本公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、首席技术官
《审计报告》	指	致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2026）第332A034478号审计报告
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《上市规则》	指	《上海证券交易所科创板股票上市规则（2026年4月修订）》
《公司章程》	指	《苏州东微半导体股份有限公司章程》
募集说明书、本募集说明书	指	《苏州东微半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》
股东会	指	苏州东微半导体股份有限公司股东会
董事会	指	苏州东微半导体股份有限公司董事会
报告期各期末	指	2023年12月31日、2024年12月31日、2025年12月31日、2026年6月30日
报告期	指	2023年度、2024年度、2025年度、2026年1-6月
最近三年	指	2023年度、2024年度、2025年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

二、专业释义

功率器件	指	已经封装好的MOSFET、IGBT等产品。晶圆制作完成后，需要封装才可以使用，封装外壳可以给芯片提供支撑、保护、散热以及电气连接和隔离等作用，以便使器件与其他电容、电阻等无源器件和有源器件构成完整的电路系统
SiC	指	Silicon Carbide的缩写，碳化硅，碳和硅的化合物，是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高和击穿电场高等性质，特别适用于高压、大功率半导体功率器件领域
GaN	指	Gallium Nitride的缩写，氮化镓，氮和镓的化合物，是第三代宽禁带半导体材料的代表之一，具有禁带宽度大、热导率高、电子饱和迁移速率高、直接带隙、击穿电场高等性质
IBC	指	Intermediate Bus Converter的缩写，中间总线转换器，是分布式电源架构中将前端较高直流母线电压转换为较低中间母线电压的功率变换单元，主要应用于数据中心、通信电源及服务器供电系统
MOSFET	指	Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor的缩写，金属-氧化物-半导体场效应晶体管，是一种可以广泛使用在模拟电路与数字电路的场效应晶体管
TGBT	指	Tri-gate IGBT，一种公司采用独立知识产权Tri-gate器件结构的创新型IGBT产品系列
集成电路、芯片、IC	指	按照特定电路设计，通过特定的集成电路加工工艺，将电路中所需要的晶体管、电感、电阻和电容等元件集成于一小块半导体（如硅、锗等）晶片或介质基片上的具有所需电路功能的微型结构
功率半导体、半导体功率器件	指	又称电力电子功率器件，主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是进行电能（功率）处理的核心器件，弱电控制和强电运行间的桥梁。半导体功率器件是半导体分立器件中的主要组成部分
超级结功率MOSFET、超级结MOS、超结MOSFET、Super Junction MOSFET	指	基于电荷平衡技术理论，在传统的功率MOSFET中加入p-n柱相互耗尽来提高耐压和降低导通电阻的器件结构，具有工作频率高、导通损耗小、开关损耗低、芯片体积小等特点
屏蔽栅MOSFET、屏蔽栅结构MOSFET、SGT	指	基于电荷平衡技术理论，在传统的功率MOSFET中加入额外的多晶硅场板进行电场调制从而提高耐压和降低导通电阻的器件结构，具有导通电阻低、开关损耗小、频率特性好等特点
功率模块	指	将分立器件或分立器件和集成电路按一定的电路拓扑封装在一起，形成整体模块化产品。该类产品集成度高、功率密度高、功率控制能力强，往往应用于大功率或小体积的电力电子产品
HEMT	指	High Electron Mobility Transistor的缩写，高电子迁移率晶体管，是一种异质结场效应晶体管
晶圆	指	硅半导体集成电路制作所用的硅晶片，又称Wafer、圆片，在硅晶片上可加工制作各种电路元件结构，成为有特定电性功能的集成电路产品
封装测试	指	封装和测试，首先把已制造完成的半导体芯片进行封装，再对元器件进行结构及电气功能的确认，以保证半导体元件符合系统的需求，整个过程被称为封装测试
宽禁带半导体	指	禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料，禁带宽度指导带的最低能级和价带的最高能级之间的能量差，主要包括碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor的缩写，绝缘栅双极型晶体管。该晶体管同时具备MOSFET和双极性晶体管的优点，如输入阻抗高、易于驱动、电流能力强、功率控制能力高、工作频率高等特点
AGI	指	Artificial General Intelligence，人工通用智能
IDM	指	垂直整合模式，该模式下企业能够独立完成芯片设计、晶圆制造、封装测试的所有环节

SBD	指	肖特基（Schottky）二极管，又称肖特基势垒二极管，在通信电源、变频器等中比较常见。是以金属和半导体接触形成的势垒为基础的二极管芯片，具有反向恢复时间极短、正向导通压降更低的特点
JFET	指	Junction Field-Effect Transistor 的缩写，结型场效应晶体管，一种通过对栅极端子使用反向偏置电压进行控制的电压控制器件
PFC	指	Power Factor Correction的缩写，功率因数校正，通过控制电路使输入电流波形跟踪输入电压波形，从而提高电源输入端功率因数并抑制电流谐波畸变的技术，广泛应用于开关电源、充电桩、逆变器、服务器电源及LED驱动等领域
CPU	指	Central Processing Unit的缩写，中央处理器，是一块超大规模的集成电路，是电子产品的运算核心和控制核心
SoC	指	System-on-Chip的缩写，系统级芯片，是在单个芯片上集成多个具有特定功能的集成电路所形成的电子系统
IPM、智能功率模块	指	Intelligent Power Module的缩写，即智能功率模块，一种将功率器件和驱动电路等集成在一起的半导体模块
MCU	指	Micro Controller Unit的缩写，微控制单元，是把中央处理器的频率与规格作适当缩减，并将内存、计数器、USB等周边接口甚至驱动电路整合在单一芯片中，形成芯片级的计算机
Fabless	指	半导体行业中流行的业务形态，指公司“没有制造业务、只专注于研发设计”的一种运作模式，也用来指未拥有芯片制造工厂的IC或功率器件设计公司
CopperClip	指	铜片夹扣键合工艺，指用铜块替代打线的一种新型封装工艺，类似的有铝带/铜丝/金丝键合工艺
DBC	指	Direct Bond Copper的缩写，直接覆铜，是一种陶瓷表面金属化技术
AMB	指	Active Metal Brazing的缩写，指采用活性金属钎焊工艺制作的覆铜陶瓷载板
LED	指	Light Emitting Diode的缩写，发光二极管
UPS	指	Uninterruptible Power Supply的缩写，不间断电源
FOM	指	Figure of merit的缩写，优值系数，是用来描述设备或系统相对于其替代品的性能的量，在功率器件中特指传导损耗及开关损耗的乘积
TCAD	指	Technology Computer Aided Design的缩写，工艺计算机辅助设计，是指利用计算机模拟来开发和优化半导体加工工艺和器件功能
DSP	指	一种专用于数字信号处理的可编程芯片。它通过对数字信号进行快速计算和转换，实现对声音、图像、视频、通信信号等多种信号的处理
eFuse	指	Electronic Fuse的缩写，电子保险丝，通过集成电路快速、精准地保护汽车电路（例如防止过流或短路），并通过车载网络上报故障、远程复位，无需人工更换，从而实现对电源的智能管理和保护
DrGaN	指	一种基于氮化镓的高性能功率晶体管集成技术，用于提升电源效率和功率密度
PMIC	指	Power Management Integrated Circuits的缩写，电源管理芯片，是在电子设备系统中担负起对电能的变换、分配、检测及其他电能管理的职责的芯片
ADC/DAC	指	Analog-to-Digital Converter/Digital-to-Analog Converter的缩写，数/模转换器，是将连续变化的模拟信号转换为离散的数字信号或实现逆向过程的器件
CNAS	指	中国合格评定国家认可委员会

DHTOL	指	Dynamic High Temperature Operating Life的缩写，动态高温工作寿命测试，在高温环境下对器件施加动态开关应力以模拟实际工况，评估器件在热应力与电应力交织下的长期可靠性，主要应用于功率半导体及宽禁带半导体器件的可靠性验证
HTFB	指	High Temperature Forward Bias的缩写，高温正偏测试系统，在高温环境下对半导体器件施加正向偏压以加速老化，评估器件在高温偏置条件下的可靠性及失效机理，主要应用于功率半导体器件及集成电路的可靠性验证
PC	指	Power Cycling的缩写，功率循环测试，通过在负载下反复开启和关闭器件使结温周期性变化，评估芯片粘接、焊点及键合线等封装互连结构的热疲劳耐久性，主要应用于功率模块、IGBT及MOSFET等功率半导体器件的可靠性验证
H3TRB	指	High Humidity High Temperature Reverse Bias的缩写，高温高湿反偏测试，在高温高湿环境下对半导体器件施加反向偏置电压，加速湿气渗透、电化学腐蚀及钝化层退化，评估器件在潮湿环境下的长期可靠性及封装密封性，主要应用于分立器件及功率模块的可靠性验证
HAST	指	Highly Accelerated Stress Test的缩写，高加速应力测试系统，是一种在高温、高湿、高压及外加电偏置条件下加速模拟湿热环境对电子器件的侵蚀效应的可靠性测试方法，用于评估封装材料抗吸湿渗透、抗腐蚀及抗电介质失效的能力

注：本募集说明书中若出现表格内合计数与实际所列数值总和不符的情况，均为四舍五入所致；本募集说明书中第三方数据不存在专门为本次发行准备的情形，发行人不存在为此支付费用或提供帮助的情形。

第二节 本次发行概况

一、发行人基本情况

中文名称：苏州东微半导体股份有限公司

英文名称：Suzhou Oriental Semiconductor Company Limited

注册地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋

通讯地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋

法定代表人：龚轶

注册资本：12,257.4975 万元

有限责任公司设立时间：2008 年 9 月 12 日

股份有限公司设立时间：2020 年 11 月 27 日

邮政编码：215123

电话号码：+86 512 62668198

传真号码：+86 512 62534962

互联网网址：<http://www.orientalsemi.com>

电子信箱：enquiry@orientalsemi.com

股票简称：东微半导

股票代码：688261.SH

股票上市交易所：上海证券交易所

统一社会信用代码：91320594680506522G

经营范围：半导体器件、集成电路、芯片、半导体耗材、电子产品的设计、开发、销售、进出口业务及相关技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、本次发行的背景和目的

（一）本次向不特定对象发行的背景

1、算力服务器和数据中心的快速发展带动高性能功率器件和控制芯片需求增长

根据弗若斯特沙利文预测，2030 年全球服务器规模将达到约 1,950 万台，其中传统服务器未来规模预计基本保持稳定，算力服务器 2025 年至 2030 年预计将以 21.2% 的年复合增长率快速增长，成为服务器市场增长的重要驱动力。随着当前算力需求的大幅提升，服务器机柜功率量级大幅攀升，传统低压供电架构面临传输电流较大、铜耗较高及多级转换损耗等问题，数据中心供电系统逐步向高压直流、高频化、高效率和高功率密度方向演进，800V 高压直流等新型供电架构逐步成为重要演进方向，高压整流、高频降压、固态保护及固态变压器等环节对高性能功率器件尤其是 SiC、GaN 等第三代半导体功率器件的需求相应增加。而在中低压控制、驱动、辅助电源、信号处理等基础模块，成熟硅基芯片依靠规模化、高性价比优势保障服务器整机基础供电与控制系统稳定运行，未来需求量也将同步增长。第三代半导体和成熟硅基产品相互配套、共同受益于算力基础设施扩张红利。

在当前算力走向高密度、连续满载、强瞬态冲击之后，高压架构是数据中心供电系统发展的确定方向，高压供电系统对 IBC 控制器、数字热插拔控制器、高压固态断路器控制芯片等配套控制芯片需求将持续增加。根据 QYResearch 数据，2025 年全球服务器电源芯片市场销售额达到了 3.26 亿美元，预计 2032 年将达到 7.91 亿美元，市场需求有望持续增长。

2、新能源汽车产业持续发展，为功率半导体提供长期市场需求

新能源汽车电动化、智能化及高压化趋势持续深化，车载充电机、直流变换器、主驱逆变器、热管理系统及直流充电桩等应用场景对功率器件的数量、性能及可靠性要求不断提升。根据国际能源署数据，2025 年全球电动汽车销量已突破 2,000 万辆，预计 2026 年将达到 2,300 万辆；根据中国汽车工业协会数据，2025 年我国新能源汽车产量和销量分别达到 1,662.60 万辆和 1,649.00 万辆，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的比例达到 47.90%。新能源汽车的渗透率增长以及高压平台不断普及，也推动功率器件向更高耐压、更低损耗及更高可靠性方向升级，SiC MOSFET、TGBT 及功率模块在新能源汽车主驱逆变器、车载充电机、直流变换器和充电桩等环节具有广泛应用空间。

3、国产替代趋势明显，政策支持显著

功率半导体作为实现电能转换、电路控制和能源管理的核心基础元器件，广泛应用于数据中心及服务器电源、新能源汽车、光伏发电、储能、工业电源、通信电源等重要领域，其技术水平和供应能力直接影响下游产业的能效水平、运行可靠性及产业链安全。

近年来，国家先后出台多项产业政策，鼓励集成电路、先进半导体材料及功率半导体领域加强关键核心技术攻关，推动产业基础高级化和产业链现代化。如《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》、2026 年政府工作报告、《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《制造业可靠性提升实施意见》《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》等政策文件，从财税、投融资、研究开发等多维度对集成电路及功率半导体企业给予系统性支持。中国是全球最大的功率半导体消费国，在政策扶持和市场需求的驱动下，本土企业快速崛起，在关键领域不断取得技术突破，市场份额持续提升，国产替代进程深化。

（二）本次向不特定对象发行的目的

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金。本次募集资金投资计划是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，是公司把握行业发展机遇，加强核心业务优势的重要举措。本次募投项目建成投产后，将有利于提升公司研发能力，进一步拓展产品类别，完善公司产品矩阵。公司技术积累将进一步增加，公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力将进一步增强。

三、本次发行的基本情况

（一）本次发行的证券类型

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次可转债及未来经本次可转债转换的公司股票将在上交所科创板上市。

（二）发行规模和发行数量

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转债发行总额不

超过 143,588.00 万元（含 143,588.00 万元），具体发行规模由公司股东会授权董事会及其授权人士根据发行时相关法律法规、公司财务状况在上述额度范围内确定。

本次可转债拟发行数量为不超过 14,358,800 张（含本数）。

（三）票面金额和发行价格

本次可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

（四）预计募集资金量（含发行费用）及募集资金净额

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 143,588.00 万元（含 143,588.00 万元），募集资金净额将扣除发行费用后确定。

（五）募集资金专项存储的账户

公司已经制定募集资金使用管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

（六）募集资金投向

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过 143,588.00 万元（含 143,588.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额
1	新型功率器件技术和产品研发及产业化项目	54,772.31	54,772.30
2	新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目	45,897.87	45,897.70
3	研发中心建设项目	32,918.00	32,918.00
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		143,588.18	143,588.00

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施

进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（七）发行方式与发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东会授权董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（八）向原股东配售的安排

本次可转债可向原股东优先配售。具体优先配售数量由股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由保荐机构包销。

（九）承销方式及承销期

本次发行由保荐机构（主承销商）中金公司以余额包销方式承销。承销期的起止时间：【】年【】月【】日-【】年【】月【】日。

（十）发行费用

本次发行费用总额预计为【】万元，具体包括：

单位：万元

项目	金额
承销保荐费用	【】
律师费用	【】
审计及验资费用	【】
资信评级费用	【】
信息披露及发行手续等费用	【】
合计	【】

（十一）证券上市的时间安排、申请上市的证券交易所

本次可转换公司债券及未来转换的公司股票将在上海证券交易所科创板上市。本次发行的主要日程安排如下表所示：

日期	发行安排
【】年【】月【】日（T-2）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告、网上路演公告
【】年【】月【】日（T-1）	网上路演；原股东优先配售股权登记日
【】年【】月【】日（T）	刊登发行提示性公告；原股东优先配售认购日；网上、网下申购日
【】年【】月【】日（T+1）	刊登网上中签率及网下发行配售结果公告；进行网上申购的摇号抽签
【】年【】月【】日（T+2）	刊登网上申购的摇号抽签结果公告；网上投资者根据中签结果缴款；网下投资者根据配售结果缴款；网上、网下到账情况分别验资
【】年【】月【】日（T+3）	根据网上网下资金到账情况确认最终配售结果
【】年【】月【】日（T+4）	刊登发行结果公告

以上日期均为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发事件影响发行，公司将及时公告并修改发行日程。

本次可转债发行承销期间公司股票正常交易，不进行停牌。

（十二）本次发行证券的上市流通

本次发行结束后，公司将尽快办理本次可转债在上交所挂牌上市交易，具体上市时间将另行公告。

（十三）投资者持有期的限制或承诺

本次可转债上市流通，所有投资者均无持有期限限制。

（十四）本次可转债基本发行条款

1、债券期限

本次可转债期限为自发行之日起六年。

2、票面金额和发行价格

本次可转债按面值发行，每张面值为人民币 100 元。

3、债券利率

本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，由公司股东会授权董事会及其授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

4、转股期限

本次可转债转股期自本次可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

5、评级情况

本次可转债经中证鹏元资信评估股份有限公司评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《苏州东微半导体股份有限公司 2026 年向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：中鹏信评【2026】第 Z【1460】号 01），发行人主体信用评级为 AAst_i，评级展望为稳定，本次可转换公司债券信用评级为 AA。

本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中证鹏元资信评估股份有限公司将对本次可转债的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

6、债券持有人会议相关事项

（1）本次可转债持有人的权利

- 1) 依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- 2) 根据《募集说明书》约定的条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
- 3) 根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- 4) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；
- 5) 依照法律、行政法规及《公司章程》的规定获得有关信息；
- 6) 按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- 7) 依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使

表决权；

8) 法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

(2) 本次可转债持有人的义务

1) 遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；

2) 依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

3) 遵守债券持有人会议形成的有效决议；

4) 除法律、行政法规及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；

5) 法律、行政法规及《公司章程》规定应当由本次可转债持有人承担的其他义务。

(3) 在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

1) 拟变更《募集说明书》的约定；

2) 拟修改债券持有人会议规则；

3) 拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；

4) 公司不能按期支付本次可转债本息；

5) 公司发生减资（因实施股权激励或员工持股计划回购股份、业绩承诺回购股份或者公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；

6) 公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；

7) 担保人或担保物（如有）发生重大变化；

8) 公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人及债券受托管理人书面提议召开；

9) 公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；

10) 公司提出重大债务重组方案的；

11) 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

12) 根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当召开债券持有人会议的其他情形。

(4) 下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

- 1) 公司董事会；
- 2) 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人；
- 3) 债券受托管理人；
- 4) 法律、法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

7、转股价格的确定及其调整

(1) 初始转股价格的确定依据

本次可转债的初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正，具体初始转股价格由公司股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场状况与保荐机构（主承销商）协商确定。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

(2) 转股价格的调整方式及计算公式

在本次可转债发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本： $P_1 = P_0 / (1+n)$ ；

增发新股或配股： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+k)$ ；

上述两项同时进行： $P_1 = (P_0 + A \times k) / (1+n+k)$ ；

派送现金股利： $P_1 = P_0 - D$ ；

上述三项同时进行： $P_1 = (P_0 - D + A \times k) / (1+n+k)$

其中： P_0 为调整前转股价， n 为送股或转增股本率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价， D 为每股派送现金股利， P_1 为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体（以下简称“符合条件的信息披露媒体”）上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次可转债持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

8、转股价格向下修正条款

（1）修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85% 时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

（2）修正程序

如公司股东会审议通过向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

9、转股数量确定方式

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： $Q=V/P$ ，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V 为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P 为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的本次可转债余额及对应的当期应计利息。

10、赎回条款

（1）到期赎回条款

在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债的票面面值上浮一定比例（含最后一期年度利息）的价格向本次可转债持有人赎回全部未转股的本次可转债。具体上浮比率由股东会授权董事会及其授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

（2）有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

当期应计利息的计算公式为： $IA = B \times i \times t / 365$

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

此外，当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。

11、回售条款

（1）附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在《募集说明书》中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

（2）有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见第 10 条赎回条款的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

12、还本付息的期限和方式

本次可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债持有人按持有的本次可转债票面总金额自本次可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为： $I=B\times i$

I：指年利息额；

B：指本次可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率。

（2）付息方式

①本次可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次可转债发行首日。

②付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④本次可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

13、构成可转债违约的情形、违约责任及其承担方式以及可转债发生违约后的诉讼、仲裁或其他争议解决机制

（1）债券违约情形

以下事件构成本次可转债项下的违约事件：

1）发行人已经或预计不能按期支付本次可转债的本金或者利息；

2) 发行人已经或预计不能按期支付除本次可转债以外的其他有息负债，未偿金额超过 2,000 万元，且可能导致本次可转债发生违约的；

3) 发行人合并报表范围内的重要子公司（指最近一期经审计的单体口径总资产、净资产、营业收入、净利润任意指标占发行人合并报表对应财务数据 5%以上的子公司，及本募集说明书披露的重要子公司）已经或预计不能按期支付有息负债，未偿金额超过 2,000 万元，且可能导致本次债券发生违约的；

4) 发行人发生减资、合并、分立、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证且导致发行人偿债能力面临严重不确定性的，或其被托管/接管、解散、申请破产或者依法进入破产程序的；

5) 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

6) 发行人或其控股股东、实际控制人因无偿或以明显不合理对价转让资产或放弃债权、对外提供大额担保等行为导致发行人偿债能力面临严重不确定性的；

7) 增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施（如有）发生重大不利变化的；

8) 本次可转债存续期内，发行人违反《受托管理协议》项下的陈述与保证、未能按照规定或约定履行信息披露义务、通知义务等义务与职责以致对发行人对本次可转债的还本付息能力产生重大不利影响，且一直持续二十(20)个连续工作日仍未得到纠正；

9) 发行人发生其他对债券持有人权益有重大不利影响的事项。

（2）针对公司违约的违约责任及其承担方式

发行人保证按照本次可转债发行条款约定的还本付息安排向债券持有人支付本次可转债利息及兑付本次可转债本金，若不能按时支付本次可转债利息或本次可转债到期不能兑付本金，对于延迟支付的本金或利息，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本次可转债票面利率上浮百分之二十（20%）。

当发行人未按时支付本次可转债的本金、利息和/或逾期利息，或发生其他违约情况时，债券持有人有权直接依法向发行人进行追索。债券受托管理人将依据相应约定在必要时根据债券持有人会议的授权，代表债券持有人提起、参加民事诉讼或参与整顿、和解、重组或者破产的法律程序。

（3）争议解决方式

受托管理协议项下所产生的或与受托管理协议有关的任何争议，双方均有权向江苏省苏州工业园区人民法院提起诉讼解决。

14、转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

15、担保事项

本次可转债不提供担保。

16、本次发行方案的有效期

公司本次可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东会审议通过之日起计算。

四、本次发行有关机构

（一）发行人：苏州东微半导体股份有限公司

法定代表人：龚轶

联系人：李麟

办公地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋

电话：+86 512 62668198

传真：+86 512 62534962

（二）保荐人、主承销商、受托管理人：中国国际金融股份有限公司

法定代表人：陈亮

保荐代表人：王竹亭、李扬

项目协办人：李冰

项目组成员：赵天浩、叶建冬、金桢栋、杨妍、过泽森

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

电话：010-6505 1166

传真：010-6505 1156

（三）发行人律师：浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

经办律师：熊琦、赵龙廷

办公地址：杭州市三新路 118 号国际金融中心汇西办公楼一座 12 楼

电话：0571-87901111

传真：0571-87901500

（四）审计机构：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：李惠琦

经办注册会计师：傅智勇、王强

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层

电话：010-85665588

传真：010-85665120

（五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司

法定代表人：张剑文

经办人员：董斌、伏美亦

办公地址：深圳市南山区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心东塔 42 楼

电话：0755-82872897

传真：0755-82872090

（六）收款银行：【】

账户名称：【】

账号：【】

开户行：【】

（七）申请上市的交易所：上海证券交易所

办公地址：上海市浦东新区杨高南路 388 号

电话：021-6880 8888

传真：021-6880 4868

（八）证券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 36 楼

电话：021-6887 0204

传真：021-5889 9400

五、发行人与本次发行相关机构的关系

截至 2026 年 6 月 30 日，保荐机构、主承销商和受托管理人中金公司及其子公司持有发行人 25,553 股股票，合计占发行人总股本的 0.02%。保荐机构已建立并执行严格的信息隔离墙制度，上述情形不会影响保荐机构正常履行保荐及承销职责。

除前述情形外，发行人与本次发行有关的保荐机构、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利益关系。

第三节 风险因素

一、与发行人相关的风险

（一）业绩大幅下滑甚至亏损的风险

半导体行业具有较强的周期性特征，其景气周期与宏观经济、下游应用需求及产能库存等因素紧密相关。报告期各期，公司主营业务收入分别为 97,285.03 万元、100,258.96 万元、125,242.67 万元和 73,137.85 万元，归属于母公司股东的净利润分别为 14,002.50 万元、4,023.51 万元、4,621.04 万元和 10,630.18 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 11,941.51 万元、231.93 万元、789.71 万元和 68.92 万元。2024 年度，公司保持了主要产品销量的同比上升，整体销售规模较上年同期小幅增加，但由于产品销售价格下降、期间费用增加等因素的影响，公司 2024 年度净利润情况出现较大幅度下滑。

功率器件广泛应用于工业制造、新能源、汽车电子、通信运输、消费电子等领域，若宏观经济波动较大或长期低迷，将导致行业市场需求萎缩、客户对成本和库存更趋谨慎，产品销售价格和销量均可能受到不利影响，进而影响公司经营业绩和盈利能力。此外，高效算力服务器、高速通信等新兴赛道虽为功率器件带来广阔空间，但也存在产业政策调整、下游需求不及预期、技术迭代和产品落地进展不顺等不确定性，若公司相关布局推进不畅，则公司业绩可能出现持续下滑甚至亏损的风险。

（二）产品研发及技术创新风险

1、技术迭代与研发升级风险

全球能源结构转型与数字经济浪潮叠加，功率半导体作为电能转化和电路控制的核心器件，下游应用十分广泛，包括数据中心电源、新能源汽车、光伏储能、消费电子、智能电网、轨道交通等，公司需要根据技术发展趋势和终端客户需求不断优化现有产品并研发新技术、新产品，从而保持技术创新性和产品竞争力。若公司不能正确把握市场动态和行业发展趋势，保持核心技术优势并根据客户需求及时进行技术迭代并推出具有竞争力的新产品，则公司的行业地位、市场份额、经营业绩等可能受到不利影响。

2、核心技术泄密与人才流失风险

功率半导体具有技术密集型的显著特征，其核心技术与人才是支撑企业竞争力的关

键资产。在激烈的人才竞争下，核心人员的流失可能导致企业技术发展受阻、创新能力断层。此外，尽管已有保密协议和专利保护作为防护屏障，但核心工艺、设计方法等关键技术泄密的风险依然存在，一旦发生，将严重削弱企业的竞争优势。

（三）经营风险

1、供应商集中度较高的风险

公司不直接从事晶圆制造和封装测试等生产和加工环节，该环节委托代工厂完成。由于公司的晶圆供应商集中度较高，若出现晶圆代工行业产能紧张或双方关系恶化的情况，则可能导致公司产品无法按时、足量交付，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、供应链管理风险

公司专注于高性能功率半导体的研发与设计，晶圆制造和封装等主要生产环节由专业的晶圆制造和封装厂商完成。报告期内，公司与行业内知名的晶圆制造厂商和封装厂商均建立了长期稳定的合作关系，但由于功率器件交期长、多环节外包导致链条长、协调难等情况，且公司产品的终端应用涵盖了工业、汽车相关应用及消费等多个行业，行业内客户均具有较高的供应商认证要求，如果公司对供应链及生产环节管理不善，导致产品质量、交付及时性等问题，则会影响公司产品销售和品牌声誉，对公司的经营造成不利影响。

（四）经营性现金流量为负的风险

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,054.72 万元、-8,831.32 万元、-19,172.92 万元和-12,930.39 万元，2024 年以来，公司经营性现金流量持续为负。报告期内，公司经营活动现金流入主要来自功率器件、晶圆和数模混合控制芯片的销售，经营活动现金流出主要用于原材料采购及职工薪酬支付。未来随着公司业务规模持续扩大，若公司经营业绩不及预期、储备的存货无法及时实现销售、客户未能及时支付货款，将导致公司面临一定的流动性风险，进而给公司的生产经营和本次可转债的本息兑付带来一定不利影响。

（五）应收账款回收风险

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 11,549.41 万元、16,294.43 万元、15,514.40 万元和 25,405.32 万元，占流动资产

的比例分别为 4.18%、5.82%、5.81%及 10.30%。未来随着公司销售业务规模的扩大和销售收入的增长，应收账款存在进一步增长和波动的可能。若公司客户出现经营不善或其他重大不利变化情形，从而不能及时还款，公司发生坏账损失的可能性将增加，将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

（六）存货减值的风险

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 34,035.05 万元、36,060.22 万元、54,789.84 万元和 68,442.21 万元，占流动资产的比重分别为 12.32%、12.87%、20.53%及 27.76%。公司存货的可变现净值受到下游市场情况变动的影响，未来，如果公司下游客户需求、市场竞争格局发生变化，或者公司不能有效拓宽销售渠道、优化库存管理，可能导致存货无法顺利实现销售，公司或将面临存货减值的风险，进而会给公司经营造成一定的不利影响。

（七）毛利率波动的风险

报告期各期，公司综合毛利率分别为 22.73%、14.29%、16.23%和 17.40%。公司综合毛利率受产品售价、产品成本以及产品结构等因素影响。随着行业技术的发展和市场竞争的加剧，公司需要根据市场需求不断进行技术的迭代升级和创新，若公司未能正确判断下游需求变化、或公司技术实力停滞不前、或公司未能有效控制产品成本、或公司产品市场竞争格局发生变化等都将导致公司发生产品售价和成本预期外波动等不利情形。在该等不利情况下，公司综合毛利率水平未来可能会持续波动甚至出现下降，从而对公司的经营带来一定风险。此外，公司的产品规格数量较多，不同规格的产品销售结构的变化亦会对公司的毛利率造成影响。

（八）募投项目实施相关风险

1、募投项目实施进度不及预期的风险

公司本次募投项目新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目及补充流动资金是在发行人主营业务基础上依据业务发展规划和发行人发展战略制定。虽然公司根据行业发展现状和趋势对本次募投项目可行性进行了深入研究和充分论证，并在技术、人员、市场等方面作了较为充分的准备，但若出现募集资金不能及时到位、项目延期实施、市场或产业环境出现重大变化等情况，可能导致项目实施过程中的某一环节出现延误或停滞，公司募投项目存在

不能全部按期建设完成的风险。

2、募投项目研发成果不达预期及产业化进程受阻的风险

本次募投项目是围绕公司主营业务，在当前产品的基础上进行的升级、迭代及拓展，并在 IC 产品领域研发并推出新产品，与公司现有业务高度关联并具有较强的协同效应，但若公司未能准确把握技术发展方向，研发过程中未能突破关键技术难点，流片或验证结果不达预期，产品性能、良率、可靠性或成本无法满足客户及量产要求，可能导致未来募投项目实施、新产品的市场开拓、以及相关产品验证进度不及预期或下游客户的采购需求不及预期，可能存在募投项目短期内无法盈利的风险，进而对公司整体经营业绩产生不利影响。

3、募投项目研发费用、新增折旧摊销影响公司盈利能力的风险

公司本次募投项目新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目，包含规模较大的研发费用支出和一定的资本性支出。随着项目实施，公司研发费用及新增资产折旧摊销预计将有所增加，而研发成果形成、客户验证及产业化放量需要一定周期。尽管公司已对相关项目进行了审慎论证，但受技术迭代、下游需求变化及市场竞争等因素影响，项目实施效果及收益释放仍存在不确定性。若项目新增收益无法及时覆盖相关费用，公司未来将可能面临净利润水平下滑、净资产收益率下降和毛利率水平下降的风险，从而对公司的盈利能力造成一定的负面影响。

4、募集资金投资项目效益低于预期的风险

公司已对新型功率器件技术和产品研发及产业化项目和新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目进行了效益测算，相关测算基于项目按期实施、产品顺利完成研发验证并实现销售，以及依据可研报告编制当时的市场即时和历史价格以及相关成本等预测性信息测算得出。若未来项目实施或产品研发验证进度滞后，行业技术路线、下游市场需求或竞争格局发生不利变化，客户导入及销售放量不及预期，可能导致项目效益释放晚于预期，实际收入、利润及投资回报低于预期，进而对公司经营业绩造成不利影响。

（九）宏观环境风险

近年来，国际经贸环境持续变化，国际贸易政策仍存在一定不确定性。若因国际贸易摩擦导致公司业务开展受限、供应商供货中断或客户采购受到约束，公司正常的生产

经营活动将受到不利影响。若全球贸易摩擦进一步升级，境外供应商亦可能面临限制甚至被禁止向公司供货。上述情形一旦发生，均可能对公司经营造成不利影响。

二、其他风险

（一）本息兑付风险

在可转债存续期限内，公司需对未转股的可转债偿付利息及到期时兑付本金。此外，在可转债触发回售条件时，若投资者提出回售，公司将在短时间内面临较大的现金支出压力，将对企业生产经营产生负面影响。本次发行的可转债未提供担保。因此，若公司经营活动出现未达到预期回报的情况，可能影响公司对可转债本息的按时足额兑付，以及在投资者回售时的承兑能力。

（二）可转债到期未能转股的风险

本次可转债在转股期内是否转股取决于转股价格、公司股票价格、投资者偏好等因素。如果本次可转债未能在转股期内转股，公司则需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而增加公司的财务费用负担和资金压力。

此外，在本次可转债存续期间，如果发生可转债赎回、回售等情况，公司将面临较大的资金压力。

（三）可转债发行摊薄即期回报的风险

本次可转债发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息。本次可转债发行有助于公司增强盈利能力、提高抗风险能力。如可转债持有人在转股期开始后的较短期间内将大部分或全部可转债转换为公司股票，公司净资产将大幅增加，总股本亦相应增加，公司将面临当期每股收益和净资产收益率被摊薄的风险。

（四）可转债交易价格波动的风险

可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的混合型证券，其市场价格受市场利率、债券剩余期限、转股价格、本公司股票价格、赎回条款、向下修正条款、投资者的预期等诸多因素的影响，这需要可转债的投资者具备一定的专业知识。

可转债在上市交易、转股等过程中，可转债的价格可能会出现波动，从而影响投资者的投资收益。为此，本公司提醒投资者必须充分认识到债券市场和股票市场中可能遇

到的风险，以便作出正确的投资决策。

（五）可转债存续期内转股价格向下修正导致公司原有股东股本摊薄程度扩大的风险

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价。

可转债存续期内，若公司股票触发上述条件则本次可转债的转股价格将向下做调整，在同等转股规模条件下，公司转股股份数量也将相应增加。这将导致原有股东股本摊薄程度扩大。因此，存续期内公司原有股东可能面临转股价格向下修正条款实施导致的股本摊薄程度扩大的风险。

（六）可转债存续期内转股价格向下修正条款不实施及修正幅度存在不确定性的风险

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款，在本次可转债存续期间，由于修正后的转股价格应不低于前项规定的股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，因此本次可转债的转股价格向下修正条款可能无法实施。此外，在满足可转债转股价格向下修正条件的情况下，发行人董事会仍可能基于公司的实际情况、股价走势、市场因素等多重考虑，不提出转股价格向下调整方案。并且，公司董事会审议通过的本次可转债转股价格向下修正方案可能未能通过公司股东会审议。因此，存续期内可转债持有人可能面临转股价格向下修正条款不能实施的风险。此外，即使公司决议向下修正转股价格，修正幅度亦存在不确定性。

（七）可转债提前赎回的风险

本次可转债设有有条件赎回条款，在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或当本次可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时，公司董事会会有权决定以面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的本次可转债。如果公司行使上述有条件赎回的条款，

可能促使可转债投资者提前转股，从而导致投资者面临可转债存续期缩短、未来利息收入减少的风险。

（八）可转债转换价值降低的风险

公司股票的交易价格可能因为多方面因素发生变化而出现波动。转股期内，如果因各方面因素导致公司股票价格不能达到或超过本次可转债的当期转股价格，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。

公司股价走势取决于公司业绩、宏观经济形势、股票市场总体状况等多种因素影响。本次可转债发行后，公司股价可能持续低于本次可转债的转股价格，因此可转债的转换价值可能降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

本次发行设置了公司转股价格向下修正条款。如果公司未能及时向下修正转股价格或者即使公司向下修正转股价格但公司股票价格仍低于转股价格，仍可能导致本次发行的可转债转换价值降低，可转债持有人的利益可能受到不利影响。

（九）不可抗力的风险

在公司日常经营过程中，尽管公司制定了较为完善的危机公关预案，但不排除包括政治、政策、经济、自然灾害等在内的不可控因素可能会对本公司的正常生产经营产生不利影响，提示投资者关注相关风险。

第四节 发行人基本情况

一、发行人股本结构及前十名股东持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人总股本为 122,574,975 股，股本结构如下：

股份类别	股数（股）	占总股本比例（%）
有限售条件流通股	478,386	0.39
无限售条件流通股	122,096,589	99.61
股份总数	122,574,975	100.00

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：

序号	股东姓名/名称	持股数量（股）	占公司总股本比例（%）	持有有限售条件股份数量（股）	质押股份数量（股）	股东性质
1	王鹏飞	14,823,125	12.09	27,927	-	境内自然人
2	苏州工业园区原点创业投资有限公司	13,963,950	11.39	-	-	国有法人
3	龚轶	12,240,578	9.99	27,927	-	境内自然人
4	中新苏州工业园区创业投资有限公司	6,552,597	5.35	-	-	国有法人
5	卢万松	4,371,284	3.57	27,927	-	境内自然人
6	苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）	4,071,267	3.32	-	-	其他
7	苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）	2,591,389	2.11	-	-	其他
8	王爱军	1,934,688	1.58	-	-	境内自然人
9	上海理成资产管理有限公司—理成风景1号投资基金	1,280,000	1.04	-	-	其他
10	王绍泽	1,208,138	0.99	-	-	境内自然人
合计		63,037,016	51.43	83,781	-	-

二、科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施

（一）公司科技创新水平

公司专注于高性能功率半导体的研发和销售，产品涵盖高性能功率器件与 IC 产品。

在功率器件领域，公司主要产品包括 GreenMOS 系列超级结 MOSFET、SFGMOS 系列及 FSMOS 系列中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT 系列 IGBT 产品、SiC 器件（含 Si²C MOSFET）以及高密度功率模块。在 IC 产品领域，公司主要产品包括数模混合的快速充电控制芯片和开关电源控制芯片。公司致力于提供从信号处理、逻辑控制到功率输出的完整“控制—驱动—执行”全链路解决方案，逐步从高性能功率器件供应商，升级成为新一代数字能源管理系统解决方案的供应商。

公司坚持以产业化为导向开展技术创新。在功率器件领域，公司遵循技术路线图推进各项技术迭代和产品升级。目前，公司主力产品高压超结 MOSFET 性能已获得市场广泛认可，第六代超级结 MOSFET 产品验证结果符合预期，研发工作取得阶段性进展，器件性能进一步提高，继续保持国内领先水平，将为后续多场景应用拓展提供有力支撑。近年来，在下游产业需求的引领下，公司通过对 25V-200V 全规格段中低压屏蔽栅产品性能的深度优化，成功量产了多颗高难度规格产品，其中 150V-200V 平台凭借新开发的独特技术，匹配通信与服务器电源等高频应用的需求，为客户的国产化替代提供了坚实支撑。此外，公司在第三代半导体功率器件领域也已取得关键进展。

在 IC 产品领域，公司与控股子公司深圳慧能泰开展技术整合，构建了涵盖数模混合电源管理芯片、栅极驱动、高压辅助电源管理芯片等 IC 产品矩阵。公司布局了多款数模混合的开关电源控制芯片产品，以自有专利的数字化开关电源控制技术为核心，辅以提高精度、低时延的模拟外设电路，针对服务器电源常见的多个先进拓扑推出专用控制器，产品的关键技术指标达到了与国际领先厂商可比的水平。公司将持续研发和布局高性能数字电源系统，结合公司在功率器件领域的固有优势，逐步成为新一代数字能源管理系统解决方案的供应商。终端产品创新需求将持续推动公司研发创新实现产品和技术迭代。

公司一直以来高度重视研发团队及知识产权体系的建设，完整的研发团队及体系与持续的研发投入使得公司成为功率器件领域产品性能领先的本土企业之一。公司的核心技术人员均具有丰富的研发经验，并对行业未来的技术发展趋势具有前瞻性的创新能力，核心技术人员的研发能力保证了公司的技术敏锐度和研发水平，确保了公司的产品迭代能够紧跟行业发展趋势，亦满足客户终端产品的创新需求。在公司核心技术人员的带领下，公司研发团队也构建了丰富完备的知识产权体系，截至 2026 年 6 月 30 日，公司已获得授权且尚在有效期内的专利共 202 项，其中发明专利 195 项、实用新型专利 7 项，

通过持续研发和产业整合，公司逐步构建覆盖控制、驱动和功率执行环节的知识产权体系，夯实了公司的核心技术壁垒，为业务的持续创新发展提供了坚实的保障。

综上所述，公司凭借深厚的技术积累、完善的知识产权体系以及高效的成果转化机制，已建立起显著的科技创新优势，为本次可转债募投项目的顺利实施及公司的长期可持续发展奠定了坚实的技术基础。

（二）保持科技创新能力的机制或措施

1、持续高效的研发投入

公司坚持技术创新与研发投入，夯实现有产品的技术升级，加快实现新产品的技术迭代。2023 年、2024 年、2025 年及 2026 年 1-6 月，公司的研发费用分别为 8,505.02 万元、7,571.57 万元、9,231.76 万元及 5,565.28 万元，占同期营业收入的比例分别为 8.74%、7.55%、7.37%及 7.56%，公司将持续保持较高的研发投入强度。

2、加强人才建设和长期激励

公司注重研发技术力量的培养和人才队伍的建设，坚持外部引进与内部培养相结合，吸引国内外优秀设计人才加入公司，激励现有员工和公司形成利益共同体，促进人才队伍建设、研发技术力量建设、提升整体运营效率，形成人才发展与业绩增长相互促进的良性循环。同时，公司提供了有市场竞争力的待遇和中长期激励计划（如已实施的员工股权激励），增强人才留任吸引力。

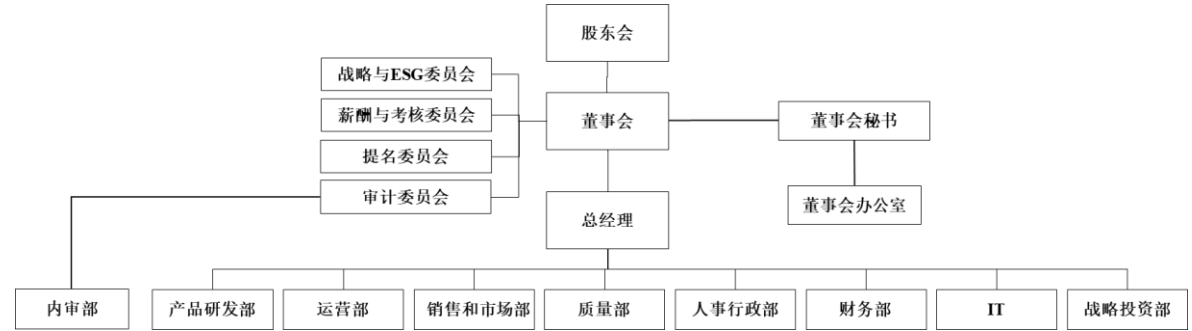
3、强化知识产权管理

公司持续强化知识产权管理，已制定知识产权管理制度并设置专职管理岗位，负责跟踪行业技术发展动态，开展专利信息检索、分析和整理，统筹专利文件的撰写、申请、维护及跟踪管理。公司建立并实施了知识产权激励机制，对形成专利成果的发明人及研发团队给予奖励，鼓励研发人员及时申报创新成果，持续充实自主知识产权储备。同时，公司通过专利申请、商标注册等方式，加强对核心技术和商业秘密的保护。通过上述措施，公司逐步形成覆盖专利布局、申请确权、风险识别、日常维护和成果激励的知识产权管理机制，为核心技术保护和持续创新提供保障。

三、公司组织结构及重要权益投资情况

（一）公司的组织结构

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人组织结构情况如下：



（二）重要子公司的基本情况

1、重要子公司概况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人共有 8 家控股子公司和 6 家参股公司。其中，深圳慧能泰为发行人重要子公司，其基本情况如下：

名称	深圳慧能泰半导体科技有限公司
统一社会信用代码	914403003565056594
住所	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷三栋 2102
法定代表人	谢仁践
注册资本	1,565.510417 万元
实收资本	1,565.510417 万元
主营业务	集成电路研发设计与销售
主要生产经营地	深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路深圳国际创新谷三栋 2102
成立日期	2015 年 10 月 12 日
经营范围	一般经营项目：半导体的研发、设计与销售；机械设备、通讯设备、五金产品、电子产品批发、销售；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；集成电路设计、研发；从事网上贸易、网上咨询；信息咨询；国内贸易，货物及技术进出口。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：无。
经营期限	2015 年 10 月 12 日至无固定期限
持股情况	发行人持股 53.0921%，该公司为发行人的控股子公司

2、重要子公司最近一年主要财务数据

发行人重要子公司 2025 年度主要财务数据如下：

单位：万元

序号	重要子公司	总资产	净资产	营业收入	净利润
1	深圳慧能泰	17,399.14	11,922.59	21,799.46	-1,149.02

注：上述财务数据为单体口径，未经审计。

四、控股股东及实际控制人的基本情况

（一）控股股东及实际控制人

1、控股股东及实际控制人情况

截至本募集说明书签署日，发行人的实际控制人为王鹏飞、龚轶，二者为发行人的共同实际控制人。

截至 2026 年 6 月 30 日，王鹏飞直接持有发行人 12.0931%的股份，并通过作为苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制发行人 3.3215%的股份；龚轶直接持有发行人 9.9862%的股份，并通过作为苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人间接控制发行人 2.1141%的股份；王鹏飞和龚轶的一致行动人卢万松直接持有发行人 3.5662%的股份。因此，王鹏飞和龚轶直接或间接控制及通过一致行动安排合计共同控制了发行人 31.0811%的股份，系发行人的实际控制人。2026 年 7 月，苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）减持公司部分股份，同时公司实施 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票剩余预留授予致使公司总股本增加。上述事项导致王鹏飞、龚轶直接或间接控制及通过一致行动安排合计共同控制公司股份的比例下降至 30.1453%，公司实际控制人未发生变化。上述交易信息具体内容详见公司分别于 2026 年 7 月 8 日、2026 年 7 月 25 日披露的《苏州东微半导体股份有限公司关于股东权益变动触及 1%刻度暨减持股份结果公告》（公告编号 2026-031）《苏州东微半导体股份有限公司关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票剩余预留授予结果公告》（公告编号：2026-036）相关公告。

截至 2026 年 6 月 30 日，实际控制人的基本情况如下：

龚轶先生，1976 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。王鹏飞先生，1976

年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。公司共同实际控制人龚轶先生和王鹏飞先生的简历情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历”之“1、董事”。

2、控股股东、实际控制人变化情况

发行人自上市以来，无控股股东，发行人的实际控制人为王鹏飞和龚轶，未发生变化。

最近三年内，实际控制人的一致行动人变化情况如下：

根据王鹏飞、龚轶、卢万松、王绍泽于2016年12月15日签署的《关于苏州东微半导体有限公司之一致行动协议》，四方就发行人的经营管理和决策事项保持一致行动，该协议有效期6年，届满前若实际控制人未提出到期解除，则有效期自动续展3年。2025年12月15日，王绍泽的一致行动关系已到期自动解除，王绍泽不再为实际控制人的一致行动人。同日，王鹏飞、龚轶、卢万松签署新的《一致行动协议》，约定各方在东微半导的经营管理和决策事项中作出/保持一致的意思表示，该协议自各方签署之日起成立，有效期为自2025年12月15日起24个月，至2027年12月15日止。截至本募集说明书签署日，卢万松为发行人实际控制人的一致行动人。

（二）股份是否存在质押或其他有争议情况

截至本募集说明书签署日，公司无控股股东，公司实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结等权利限制的情形，亦不存在争议情形。

（三）控股股东及实际控制人投资的其他企业

1、控股股东控制的其他企业基本情况

截至2026年6月30日，公司无控股股东，不存在控股股东控制的其他企业。

2、实际控制人控制的其他企业的基本情况

截至2026年6月30日，除发行人及其下属子公司外，发行人实际控制人王鹏飞及龚轶直接或间接控制的企业为苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）及苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）。

截至2026年6月30日，苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）的基本

情况如下：

公司名称	苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	王鹏飞
出资额	223.696 万元
成立日期	2016 年 9 月 27 日
主要经营场所	苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 23 幢 214 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理服务、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2016 年 9 月 27 日至 2031 年 8 月 25 日

截至 2026 年 6 月 30 日，苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）的基本情况如下：

公司名称	苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人	龚轶
出资额	142.384 万元
成立日期	2016 年 9 月 27 日
主要经营场所	苏州工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 23 幢 214 室
企业类型	有限合伙企业
经营范围	企业管理服务、企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
营业期限	2016 年 9 月 27 日至 2031 年 8 月 25 日

五、发行人、实际控制人以及发行人董事、高级管理人员作出的重要承诺及其履行情况以及与本次发行相关的承诺事项

报告期内，发行人、实际控制人、董事、高级管理人员作出的重要承诺内容及履行情况如下：

（一）本次发行前发行人及相关人员作出的重要承诺及履行情况

公司首次公开发行股票相关主体已作出的重要承诺及其履行情况参见发行人于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州东微半导体股份有限公司 2025 年年度报告》之“第五节 重要事项”之“一、承诺事项履行情况”。截至本募集说明书签署日，本次发行前相关主体所作出的重要承诺履行情况正常。

（二）与本次发行相关的承诺事项

1、公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

为保证公司填补回报措施能够得到切实履行，相关主体对本次发行摊薄即期回报填补措施作出了相关承诺，具体情况如下：

（1）公司实际控制人及其一致行动人的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人及其一致行动人作如下承诺：

“1、本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

2、本人将切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及本承诺。若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

3、自本承诺出具之日起至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。”

（2）公司董事、高级管理人员的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下承诺：

“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

3、本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

5、公司未来如实施股权激励计划，本人承诺股权激励行权条件与填补回报措施的

执行情况相挂钩；

6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺。若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

7、本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。”

（三）公司实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员参与本次可转债发行认购情况

根据《证券法》《可转换公司债券管理办法》等相关规定的要求，公司实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事及高级管理人员对本次可转债发行的相关事项说明及承诺如下：

1、公司实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员的承诺

公司实际控制人及其一致行动人、持股 5%以上股东、董事（不含独立董事）、高级管理人员就参与公司本次可转债发行认购事项及减持计划承诺如下：

“本人/本企业作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称‘发行人’）实际控制人/持股 5%以上股东/非独立董事/高级管理人员，现就发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称‘本次可转债发行’）相关事宜承诺如下：

一、本人/本企业将根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规规定及本次可转债发行时的市场情况决定是否参与认购，并将严格履行相应信息披露义务。

二、若本人/本企业参与本次可转债发行的认购，本人/本企业将严格遵守《中华人民共和国证券法》关于买卖可转债的相关规定，不通过任何方式（包括集中竞价交易、大宗交易或协议转让等）进行违反《中华人民共和国证券法》规定的短线交易等违法行为。

三、本人/本企业自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若本人/本企业违反上述承诺交易发行人可转债的，因交易发行人可转债的所得收益全部归发行人所有，本人/本企业将依法承担由此产生的法律责任。

四、本承诺函出具后，若适用法律、法规、规范性文件或证券监管机构的要求发生变化的，本人/本企业承诺将自动适用变更后的相关法律、法规、规范性文件及证券监管机构的要求。”

2、公司独立董事的承诺

公司独立董事就参与公司本次可转债发行认购事项承诺如下：

“本人作为苏州东微半导体股份有限公司（以下简称‘发行人’）独立董事，现就发行人向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜承诺如下：

一、本人承诺本人及本人配偶、父母、子女不参与认购发行人本次向不特定对象发行的可转换公司债券，亦不会委托其他主体参与认购。

二、本人自愿作出上述承诺，并自愿接受本承诺函的约束。若出现违反上述承诺的情形，本人将依法承担由此产生的法律责任。”

（四）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：

“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况

（一）现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人共有 8 名董事、5 名高级管理人员、3 名核心技术人员。

公司现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历如下：

1、董事

发行人本届董事会由 8 名成员组成，其中独立董事 3 名，本届董事会的董事任期三

年。发行人董事列表如下：

序号	姓名	公司职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
1	龚轶	董事长、总经理	男	50	2020年11月20日	2026年12月24日
2	王鹏飞	董事、首席技术官	男	50	2020年11月20日	2026年12月24日
3	卢万松	董事、副总经理	男	51	2020年11月20日	2026年12月24日
4	金光杰	董事	男	40	2020年11月20日	2026年12月24日
5	李麟	董事、董事会秘书	女	44	2020年11月20日	2026年12月24日
6	黄清华	独立董事	男	46	2023年12月25日	2026年12月24日
7	毕嘉露	独立董事	女	43	2020年11月20日	2026年12月24日
8	卢红亮	独立董事	男	48	2020年11月20日	2026年12月24日

注：2021年4月2日，发行人召开第一届董事会第五次会议，聘任王鹏飞为公司首席技术官。因此，王鹏飞的首席技术官任职起始日期为2021年4月2日，任期终止日期为2026年12月24日。

公司董事简历如下：

（1）龚轶，男，1976年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于英国纽卡斯尔大学。1999年7月至2003年4月，担任美国超微半导体公司工程部工程师；2004年9月至2007年12月，担任德国英飞凌科技汽车电子与芯片卡部门技术专家；2008年9月，与王鹏飞共同创办东微有限，历任东微有限董事长、总经理等；2016年9月至今，担任苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2023年9月至今，担任深圳东能半导体有限公司监事；2014年5月至今，担任香港赛普锐思有限公司董事；2025年9月至今，担任苏州智启科技有限公司董事；2025年11月至今，担任上海东脑智合技术有限公司董事；2026年5月至今，担任深圳慧能泰半导体科技有限公司董事长；2020年11月至今，担任东微半导董事长兼总经理。

（2）王鹏飞，男，1976年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。博士毕业于德国慕尼黑工业大学。2004年7月至2006年4月，担任德国英飞凌科技存储器研发中心研发工程师；2006年5月至2007年12月，担任德国奇梦达公司（Qimonda AG）技术创新和集成部门研发工程师；2009年7月至2021年3月，担任复旦大学微电子学院教授；2008年9月，与龚轶共同创办东微有限，历任东微有限董事长、董事等；2016年9月至今，担任苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2014年5月至今，担任香港赛普锐思有限公司董事；2026年5月至今，担

任深圳慧能泰半导体科技有限公司董事；2020年11月至今，担任东微半导董事；2021年4月至今，担任东微半导首席技术官。

（3）卢万松，男，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于上海交通大学安泰管理学院。2003年6月至2005年7月，担任泰瑞达（上海）有限公司采购部采购经理；2005年8月至2010年6月，担任施耐德自动化控制系统（上海）有限公司采购部采购经理；2010年7月至2015年9月，担任霍尼韦尔（中国）有限公司采购部全球采购经理；2016年4月，受聘为东微有限的公司顾问；2017年3月至2020年11月，担任东微有限董事；2018年11月至今，担任深圳东能半导体有限公司总经理、执行董事；2020年11月至今，担任东微半导董事、副总经理。

（4）金光杰，男，1986年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于东南大学信息科学与工程学院。2012年4月至2017年3月，担任旺宏微电子（苏州）有限公司研发一部主任工程师；2017年3月至2022年2月，担任苏州元禾控股股份有限公司高级投资经理；2024年11月至今，任苏州元禾控股股份有限公司集成电路产业投资部总经理；2023年3月至今，担任苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司副总经理；现担任苏州华太电子技术股份有限公司董事、成川科技（苏州）有限公司董事、苏州睿芯集成电路科技有限公司董事、苏州登堡电子科技有限公司董事、苏州磁明科技有限公司董事、苏州腾芯微电子有限公司董事、共模半导体技术（苏州）有限公司董事、苏州禾芯半导体有限公司董事、龙晶石半导体科技（苏州）有限公司董事、苏州慧闻纳米科技有限公司董事、新美光（苏州）半导体科技股份有限公司董事、创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事、Oriza Naxin International Co., Limited（中文名：元禾纳芯国际有限公司）执行董事、致微（苏州）光学技术有限公司董事、苏州园芯微电子技术有限公司董事兼经理；2018年12月至2020年11月，担任东微有限董事；2020年11月至今，担任东微半导董事。

（5）李麟，女，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕业于苏州大学。2002年6月至2006年6月，担任藏持电子（苏州）有限公司（现更名为“雅玛札崎（苏州）精密冲压有限公司”）模具部翻译/检测组长；2006年6月至2008年8月，担任金王（苏州工业园区）卫生用品有限公司供应链部采购专员；2009年6月加入东微有限并担任行政经理；2025年5月至今，担任苏州电征科技有限公司监事；2025年9月至今，担任苏州智启科技有限公司监事；2026年5月至今，担任深

圳慧能泰半导体科技有限公司监事；2020年11月至今，担任东微半导董事、董事会秘书。

（6）黄清华，男，1979年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于南京审计学院审计专业。2000年6月至2005年12月，担任温州欧龙电气有限公司计划员、生产部副经理；2006年1月至2007年2月，担任苏州立泰电子有限公司计划部经理；2007年3月至2015年8月，担任苏州明诚会计师事务所审计员、项目经理、部门经理；2015年9月至2017年9月，担任苏州万隆永鼎会计师事务所部门经理、合伙人；2017年10月至今，担任中兴华会计师事务所苏州分所部门经理、合伙人；2023年12月至今，担任东微半导独立董事。

（7）毕嘉露，女，1982年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，硕士学位，硕士毕业于华东政法大学。2006年1月至2018年2月，担任江苏德富信律师事务所律师助理、律师；2018年2月至今，担任上海市锦天城（苏州）律师事务所合伙人律师；2020年11月至今，担任东微半导独立董事。

（8）卢红亮，男，1978年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，博士毕业于复旦大学。2006年10月至2007年10月，担任意大利微电子材料与器件国家实验室博士后；2007年11月至2009年11月，担任东京大学电子工程系研究员；2010年7月至2014年11月，担任复旦大学微电子学院副教授；2014年11月至今，担任复旦大学微电子学院教授；2020年11月至今，担任东微半导独立董事。

2、高级管理人员

发行人现任5名高级管理人员列表如下：

序号	姓名	公司职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期
1	龚轶	董事长、总经理	男	50	2020年11月20日	2026年12月24日
2	王鹏飞	董事、首席技术官	男	50	2021年4月2日	2026年12月24日
3	卢万松	董事、副总经理	男	51	2020年11月20日	2026年12月24日
4	李麟	董事、董事会秘书	女	44	2020年11月20日	2026年12月24日
5	谢长勇	财务负责人	男	45	2020年11月20日	2026年12月24日

注：2021年4月2日，发行人召开第一届董事会第五次会议，聘任王鹏飞为公司首席技术官。因此，王鹏飞的董事任职起始日期为2020年11月20日，首席技术官任职的起始日期为2021年4月2日。

发行人高级管理人员的简历如下：

（1）龚轶，见本节“（一）现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历”之“1、董事”相关内容。

（2）王鹏飞，见本节“（一）现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历”之“1、董事”相关内容。

（3）卢万松，见本节“（一）现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历”之“1、董事”相关内容。

（4）李麟，见本节“（一）现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历”之“1、董事”相关内容。

（5）谢长勇，男，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，本科毕业于安徽工业大学。2005年5月至2007年5月，担任昆山中扬包装材料有限公司财务部税务/成本专员；2008年6月至2011年2月，担任基伊埃冷冻技术（苏州）有限公司财务部财务主管；2011年3月至2016年7月，担任苏州星创弘辰电子科技有限公司财务部财务经理；2016年7月至2017年5月，担任苏州创易技研股份有限公司财务部财务经理；2017年11月至2019年7月，担任苏州慧工云信息科技有限公司财务部财务总监；2020年8月加入东微有限，担任财务经理；2024年6月至今担任苏州德信芯片科技有限公司监事；2025年5月至今，担任苏州电征科技有限公司董事长；2020年11月至今，担任东微半导财务负责人。

3、核心技术人员

发行人现任3名核心技术人员列表如下：

序号	姓名	公司职务	性别	年龄
1	王鹏飞	董事、首席技术官	男	50
2	王毅	系统应用总监	男	45
3	毛振东	资深研发工程师	男	43

发行人核心技术人员的简历如下：

（1）王鹏飞，见本节“（一）现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历”之“1、董事”相关内容。

（2）王毅，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，荷兰代尔夫特工业大学电力电子专业博士毕业。2011年1月至2017年6月，担任荷兰飞利浦照明（现昕诺飞）高级电源工程师；2017年9月至2025年8月，历任德国英飞凌科技首席应用工程师、资深首席产品定义工程师；2025年9月加入东微半导，担任系统应用总监。

（3）毛振东，男，1983年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，硕士毕业于中国科学院大学集成电路设计学院。2005年7月至2006年5月，担任华晶电子集团有限公司扩散部工程师；2006年5月至2008年1月，担任华润上华科技有限公司技术开发部工程师；2008年1月至2015年3月，担任苏州硅能半导体科技股份有限公司研发部工程师；2015年3月加入东微有限，现任东微半导资深研发工程师。

（二）董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬、兼职情况及激励计划

1、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况

2025年度，公司董事、高级管理人员及核心技术人员在发行人处领取薪酬的情况如下：

序号	姓名	公司职务	是否在公司领薪	薪酬（万元）
1	龚轶	董事长、总经理	是	157.56
2	王鹏飞	董事、首席技术官	是	139.76
3	卢万松	董事、副总经理	是	186.44
4	金光杰	董事	否	-
5	方伟	董事 （已于2025年7月离任）	否	-
6	李麟	董事、董事会秘书	是	61.76
7	黄清华	独立董事	是	8.00
8	毕嘉露	独立董事	是	8.00
9	卢红亮	独立董事	是	8.00
10	谢长勇	财务负责人	是	62.99
11	刘磊	研发部研发总监 （曾为核心技术人员，已于2025年5月离任）	是	23.39
12	刘伟	研发部资深研发工程师 （因工作内容调整，2025年12月不再认定为核心技术人员）	是	46.64

序号	姓名	公司职务	是否在公司领薪	薪酬（万元）
13	王毅	系统应用总监	是	4.98
14	毛振东	资深研发工程师	是	111.04

注：其中，王毅于 2025 年 12 月新增认定为公司核心技术人员。

2、发行人董事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人董事、高级管理人员及核心技术人员在发行人及其控股子公司以外的主要兼职情况如下表：

姓名	职务	兼职单位	兼职职务
龚轶	董事长、总经理	上海东脑智合技术有限公司	董事
		苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
王鹏飞	董事、首席技术官	苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人
金光杰	董事	苏州华太电子技术股份有限公司	董事
		苏州园芯微电子技术有限公司	董事、经理
		成川科技（苏州）有限公司	董事
		苏州睿芯集成电路科技有限公司	董事
		苏州登堡电子科技有限公司	董事
		苏州磁明科技有限公司	董事
		苏州腾芯微电子有限公司	董事
		共模半导体技术（苏州）有限公司	董事
		苏州禾芯半导体有限公司	董事
		龙晶石半导体科技（苏州）有限公司	董事
		苏州慧闻纳米科技有限公司	董事
		Oriza Naxin International Co., Limited（中文名：元禾纳芯国际有限公司）	执行董事
		创耀（苏州）通信科技股份有限公司	董事
		新美光（苏州）半导体科技股份有限公司	董事
		苏州元禾控股股份有限公司	集成电路产业投资部总经理
		苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司	副总经理
黄清华	独立董事	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人
毕嘉露	独立董事	上海市锦天城（苏州）律师事务所	合伙人律师
卢红亮	独立董事	复旦大学	教授
		上海复纯环保科技有限公司	执行董事

姓名	职务	兼职单位	兼职职务
		复奇普半导体科技（嘉兴）有限公司	执行董事、经理
		苏州复纳电子科技有限公司	执行董事
		复奇普集成电路设备（上海）有限公司	监事
谢长勇	财务负责人	苏州德信芯片科技有限公司	监事

3、发行人董事、高级管理人员及其他员工的激励计划

公司制定并执行了 2025 年限制性股票激励计划，具体情况如下：

（1）2025 年限制性股票激励计划的批准情况

2025 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与 2025 年限制性股票激励计划相关议案。

2025 年 8 月 1 日，公司召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等与 2025 年限制性股票激励计划相关议案。

（2）2025 年限制性股票激励计划的首次授予情况

2025 年 8 月 4 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，分别审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项发表了核查意见。同日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 8 月 4 日为授予日，向符合条件的 118 名激励对象授予 1,529,932 股限制性股票，其中授予第一类限制性股票 458,980 股，授予第二类限制性股票 1,070,952 股。因第一类限制性股票认购缴款过程中，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其获授的全部限制性股票共计 8,844 股，其中第一类限制性股票 2,653 股，第二类限制性股票 6,191 股。调整后，公司本激励计划实际授予的激励对象总人数由 118 人调整为 117 人，第一类限制性股票授予数量从 458,980 股调整为 456,327 股，第二类限制性股票授予数量从 1,070,952 股调整为 1,064,761 股。公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予的激励对

象名单，详见公司于 2025 年 8 月 6 日公布的《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。第一类限制性股票首次授予的最终授予结果，详见公司于 2025 年 9 月 20 日公布的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票授予结果公告》。

（3）2025 年限制性股票激励计划的部分预留授予情况

2025 年 9 月 9 日，公司召开了第二届董事会薪酬与考核委员会第五次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对预留授予日的激励对象名单进行核实并对本次授予事项发表了核查意见。同日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予部分预留限制性股票的议案》，同意以 21.77 元/股的授予价格向符合条件的 3 名激励对象授予 73,531 股限制性股票，其中授予第一类限制性股票 22,059 股，授予第二类限制性股票 51,472 股。公司 2025 年限制性股票激励计划部分预留授予的激励对象名单，详见公司于 2025 年 9 月 11 日公布的《2025 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（截至授予日）》。第一类限制性股票预留部分授予的最终授予结果，详见公司于 2025 年 10 月 18 日公布的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留部分授予结果公告》。

（4）2025 年限制性股票激励计划的剩余预留授予情况

2026 年 7 月 9 日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对剩余预留限制性股票授予的激励对象名单进行核实并对本次授予事项发表了核查意见。同日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予剩余预留限制性股票的议案》《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意根据公司 2025 年年度权益分派实施情况，将本次股权激励计划限制性股票授予价格由 21.77 元/股调整为 21.69 元/股；同意以 2026 年 7 月 9 日为授予日，向符合条件的 34 名激励对象授予 234,508 股限制性股票，其中授予第一类限制性股票 70,352 股，授予第二类限制性股票 164,156 股。公司 2025 年限制性股票激励计划剩余预留授予的激励对象名单，详见公司于 2026 年 7 月 11 日公布的《2025 年限制性股票激励计划剩余预留授予激励对象名单（截至授予日）》。第

一类限制性股票剩余预留部分授予的最终授予结果，详见公司于 2026 年 7 月 25 日公布的《关于 2025 年限制性股票激励计划第一类限制性股票剩余预留授予结果公告》。公司 2025 年限制性股票激励计划正在持续实施过程中。

（三）董事、高级管理人员及核心技术人员变动情况

1、报告期内发行人董事变动情况

报告期初，发行人的董事为龚轶、王鹏飞、卢万松、金光杰、吴昆红、李麟、郭龙华、毕嘉露及卢红亮。

因公司第一届董事会任期届满，2023 年 12 月 25 日，发行人召开 2023 年第三次临时股东大会，选举龚轶先生、王鹏飞先生、卢万松先生、金光杰先生、方伟先生及李麟女士为公司第二届董事会非独立董事，选举黄清华先生、毕嘉露女士、卢红亮先生为公司第二届董事会独立董事，上述董事共同组成公司第二届董事会。

因方伟先生于 2025 年 7 月 15 日申请辞去公司第二届董事会非独立董事职务，发行人召开 2025 年第一次临时股东会议，审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意将董事会成员人数由 9 名调整为 8 名，其中独立董事 3 名，非独立董事 5 名。

2、报告期内发行人高级管理人员变动情况

报告期内，发行人高级管理人员不存在变动情况。

3、报告期内发行人核心技术人员变动情况

报告期初，发行人核心技术人员为王鹏飞、刘磊、刘伟、毛振东。

2025 年 5 月，刘磊因个人职业发展原因，向公司申请辞去核心技术人员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。

2025 年 12 月，刘伟因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，公司新增认定王毅为公司核心技术人员。

（四）董事、高级管理人员及核心技术人员持股情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人现任董事、高级管理人员及核心技术人员持有发行

人股份的情况如下：

姓名	职务	直接持股		间接持股		合计持股比例
		直接持股数量 (万股)	直接持股比例	间接持股数量 (万股)	间接持股比例	
龚轶	董事长、总经理	1,224.0578	9.9862%	107.5179	0.8772%	10.8634%
王鹏飞	董事、首席技术官	1,482.3125	12.0931%	203.0667	1.6567%	13.7498%
卢万松	董事、副总经理	437.1284	3.5662%	-	-	3.5662%
金光杰	董事	-	-	-	-	-
李麟	董事、董事会秘书	0.4189	0.0034%	29.2498	0.2386%	0.2420%
黄清华	独立董事	-	-	-	-	-
毕嘉露	独立董事	-	-	-	-	-
卢红亮	独立董事	-	-	-	-	-
谢长勇	财务负责人	0.5585	0.0046%	-	-	0.0046%
王毅	核心技术人员	-	-	-	-	-
毛振东	核心技术人员	0.5236	0.0043%	9.1813	0.0749%	0.0792%

除上述情况外，发行人董事、高级管理人员及核心技术人员不存在其他持有发行人股份的情况。

七、公司的特别表决权股份或类似安排

截至本募集说明书签署日，公司不存在特别表决权股份或类似安排。

八、协议控制架构

截至本募集说明书签署日，公司不存在协议控制架构。

九、公司所处行业基本情况

公司专注于高性能功率半导体的研发和销售，产品涵盖高性能功率器件与 IC 产品，致力于提供从信号处理、逻辑控制到功率输出的完整“控制—驱动—执行”全链路解决方案。公司产品广泛应用于数据中心与算力服务器电源、工业和通讯电源、车载充电桩、直流充电桩、光伏逆变及储能等应用领域。根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，行业代码为“C39”。

（一）行业监管体制及最近三年监管政策的变化

1、行业监管体制和监管部门

公司所处的集成电路设计行业属于国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2024 年本）》所规定的鼓励类产业，政府主管部门为工信部，行业自律性组织为中国半导体行业协会。

工信部主要负责提出新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施工业、通信业、信息化的发展规划；制定并组织实施工业、通信业的行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作等。

半导体协会主要负责提供决策支撑服务，贯彻落实政府有关的政策、法规，承接政府购买服务，经政府有关部门批准或根据政府主管部门授权，承担半导体行业咨询研究课题或开展服务，深入研究半导体行业全局性、战略性、前瞻性重大问题，跟踪行业发展面临的热点、难点问题，向政府有关部门提出促进本行业发展的政策建议；根据授权开展行业数据统计分析工作，采集会员单位经济运行数据并进行统计分析，调查、研究、预测本行业产业与市场发展状况，及时定期向会员单位和政府主管部门提供行业情况调查、市场趋势、经济运行预测等信息，为企业制定发展战略等提供参考，并做好政策导向、信息导向和市场导向工作；广泛开展行业交流活动、开展国际交流与合作；促进行业质量与标准化工作；组织开展半导体行业技术、业务、管理、法规等培训工作等。

2、行业主要法律、法规、政策的变化及其对发行人经营发展的影响

集成电路行业是支撑国民经济和社会发展的战略性、基础性和先导性产业，也是推动新一代信息技术发展、促进信息化与工业化深度融合的重要基础。我国政府高度重视集成电路产业发展，近年来先后出台了一系列法律法规和产业政策，持续规范行业发展秩序，支持产业技术创新和转型升级，为集成电路行业的持续稳定发展创造了良好的政策环境。2023 年以来，集成电路行业主要相关法律法规及产业政策如下表所示：

序号	颁布时间	颁布机构	政策名称	与本行业相关的内容
1	2026 年 4 月	发改委、工信部、财政部、海关总署、税务总局	《国家发展改革委等部门关于做好 2026 年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作的通知》	为我国集成电路产业和软件产业提供税收优惠，促进其持续健康发展
2	2026 年 3 月	全国人民代表大会	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》	全链条推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破 做精做细成熟制程，提高先进制程制造能力，加快宽禁带半导体提质升级并推动氧化镓、金刚石等超宽禁带半导体产业化
3	2026 年 3 月	国务院	《2026 年政府工作报告》	培育壮大新兴产业和未来产业。实施产业创新工程，鼓励央企国企带头开放应用场景，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业
4	2025 年 8 月	工信部、市场监督管理总局	《电子信息制造业 2025—2026 年稳增长行动方案》	持续推进半导体、光伏、锂电池、超高清视频、时空信息、新型显示等领域与有关国家和地区间常态化交流合作机制
5	2025 年 7 月	国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司、工业和信息化部办公厅、交通运输部办公厅	《关于促进大功率充电设施科学规划建设的通知》	推动大功率充电技术创新应用。充电运营企业要加强充电装备技术升级，提高大功率充电设施的运行效率和使用寿命。鼓励对分体式设备采用大功率充电优先的功率分配策略。加快高压碳化硅模块、主控芯片等核心器件国产化替代，推动涵盖零部件、系统集成、运营服务的充电产业链整体升级
6	2024 年 7 月	中共中央	《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路、工业母机、医疗装备、仪器仪表、基础软件、工业软件、先进材料等重点产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用
7	2023 年 12 月	发改委	《产业结构调整指导目录（2024 年本）》	“集成电路设计”属于“鼓励类”
8	2023 年 8 月	工信部、科技部等四部门	《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》	全面推进新兴产业标准体系建设。研制集成电路材料、专用设备与零部件等标准，制修订设计工具、接口规范、封装测试等标准，研制新型存储、处理器等高端芯片标准，开展车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研究。研制智能传感器、功率半导体器件、新型显示器件等基础器件标准，制修订电连接器、纤维光学、微波器件以及印制电路等领域标准

国家相关支持政策明确了集成电路行业在国民经济中的战略地位。上述政策和法规的发布和落实，从定位、导向、税收等多个方面对集成电路行业给予了大力支持，也将持续为发行人主营业务的发展提供积极的政策环境，助力发行人发挥自身优势，不断提高产品的核心竞争力。

（二）近三年在科技创新方面的发展情况和未来发展趋势

1、硅基功率器件持续向低损耗、高频化和平台化方向迭代

硅基 MOSFET 和 IGBT 经过长期产业化发展，制造工艺、封装测试和配套供应链体系已较为成熟，在成本、可靠性和产品覆盖范围方面仍具有综合优势，是消费电子、服务器电源、工业控制、新能源汽车及新能源发电等领域广泛使用的基础功率器件。

近年来，硅基功率器件的技术演进主要围绕持续降低导通与开关损耗、提高工作频率、优化耐压阈值和可靠性以及改善封装散热展开。较低的损耗有助于提升电能转换效率并减少设备散热压力，较高的工作频率有助于缩小电源电路设计及整机体积，封装和散热技术的进步则进一步提升了产品在高功率、长时间运行场景下的稳定性。

由于不同下游应用对工作电压、电流能力、开关速度、封装形式和可靠性等级的要求存在较大差异，行业主要厂商普遍围绕不同电压等级、功率范围和应用场景构建技术平台及系列化产品，并通过多种封装形式满足差异化、定制化需求。在行业科技创新发展趋势下，东微半导持续推进硅基功率器件的技术迭代和产品系列化布局，已形成覆盖不同电压等级及应用场景的多代产品平台，技术和产品性能保持国内领先水平。

2、宽禁带半导体向规模化应用和成本优化演进，超宽禁带半导体研发布局提速

以碳化硅、氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体，相较于传统硅基半导体具备更大禁带宽度、更高击穿场强与电子饱和漂移速度，可显著降低器件导通损耗与开关损耗、提升工作频率与功率密度，同时具备优异的耐高温特性，能够突破硅基功率器件在高压、高频、高效率场景下的物理性能瓶颈。依托核心性能优势，碳化硅、氮化镓器件可精准适配高效算力数据中心高压供电、新能源汽车、光伏储能、智能电网等高功率、高可靠性要求的新兴场景。

当前算力需求的大幅提升带动服务器机柜功率量级大幅增长，传统低压供电存在电流、铜耗、多级损耗等物理瓶颈，800V 高压直流架构成为必然演进方向，在高压整流、高频降压、固态保护、固态变压器等环节均需大量第三代功率器件，带来持续增量需求。

其中碳化硅器件凭借耐高压、低损耗、高可靠性的核心优势，有望成为数据中心高压直流母线等中高压电能转换环节的核心配件；氮化镓器件在高频降压、板级电能转换等高频率、高功率密度场景的应用渗透率持续提升，预计将有效助力电源设备小型化、高效化升级。当前，随着下游算力基础设施等持续扩容，叠加国内产业链衬底、外延、器件设计、封装测试全环节技术突破与产能配套完善，宽禁带半导体正迎来规模化普及窗口期，产业化、商业化进程预计将持续提速，根据 Yole 预测，到 2031 年，碳化硅、氮化镓合计将占据全球功率半导体市场 31% 的份额。在技术创新和市场需求背景下，公司积极推进 SiC 和 GaN 功率器件的研发及产业化，持续完善第三代半导体技术储备和产品布局，为把握相关新兴应用领域的发展机遇奠定基础。

未来，以氧化镓为代表的第四代超宽禁带半导体，有望成为功率半导体领域前瞻性布局的核心赛道。氧化镓禁带宽度约 4.8eV，击穿电场强度可达 8MV/cm，其 Baliga 优值理论极限约为碳化硅的 10 倍，可在超高耐压工况下实现极低导通损耗，适配超高压电网、超大功率数据中心等前沿高端电力电子场景，长期替代与升级空间广阔。根据 Yole 预测，氧化镓将成为功率半导体市场的主流材料之一。

3、功率半导体由单一器件竞争向“控制—驱动—执行”全链路协同演进

功率管理及驱动 IC 是电力电子系统连接控制决策与功率执行的关键环节，其性能直接影响功率器件的开关效率、动态响应和运行可靠性。功率管理及驱动 IC 与功率器件的下游应用领域高度重合，二者在同一电力电子系统中协同配合以实现电能的高效、稳定转换。在传统的电源及电机控制系统中，功率器件、栅极驱动芯片与控制芯片通常由不同厂商分别供应，客户需自行完成器件选型、驱动电路设计及系统集成，兼容性验证、调试周期及多供应商协同等相对复杂。随着产业下游高端应用场景对系统效率、功率密度和可靠性的要求持续提升，行业对一体化系统级解决方案的需求增加，功率半导体行业正逐步由单一器件竞争，向器件与控制芯片、驱动芯片协同设计的系统化方案演进。

全链路协同模式下，功率器件与驱动、控制芯片实现联合定义与协同设计，可精准匹配器件开关特性，优化控制算法，有效降低开关损耗，最大化释放器件性能，提升系统整体转换效率与运行稳定性；同时能够减少客户多供应商采购、多环节兼容性验证的沟通与时间成本，大幅缩短终端产品研发与上市周期。

海外领先厂商均在此方向深度布局。英飞凌通过内生研发和外延并购，形成涵盖 MOSFET、IGBT、HEMT、智能功率开关、驱动芯片及智能功率模块在内的完整产品矩阵，具备从功率器件到系统方案的全覆盖能力；德州仪器则依托其模拟与数字芯片技术积累，在光伏储能、工业电源等场景提供系统级解决方案，构建了极高的市场准入壁垒，搭建全链路功率半导体产品体系，是高端功率半导体实现国产替代的重要课题。搭建“控制—驱动—执行”全链路产品体系是功率半导体行业企业的重要发展方向。目前，公司已通过自主技术储备及收购深圳慧能泰形成高性能模拟和数模混合 IC 业务布局，并形成数字电源管理、DSP 和模拟 IC 等方面的研发及产品基础，为公司“控制—驱动—执行”的全链路协同演进提供了支撑。

（三）行业整体竞争格局及市场集中情况，发行人产品或服务的市场地位、主要竞争对手

1、行业整体竞争格局及市场集中情况

（1）半导体行业发展概况

半导体是指常温下导电性能介于导体与绝缘体之间的材料。半导体产业是现代电子信息产业的基础性、战略性产业，产品广泛应用于消费电子、数据中心、新能源汽车、新能源发电、工业控制、医疗和国防等领域。按照产品类别，半导体可分为集成电路、分立器件、光电子器件以及传感器与执行器。近年来，消费电子、网络通信、汽车、物联网等下游市场的消费需求扩大，AGI、自动驾驶、数字孪生等创新终端应用的商业化落地不断加速，产品应用领域不断拓宽，半导体市场迎来显著增长。根据 WSTS 统计数据，2025 年全球半导体市场规模达到 7,956 亿美元，较 2024 年市场规模同比增长 26.2%，其中集成电路、光电子器件、分立器件以及传感器与执行器的市场规模分别为 7,009 亿美元、430 亿美元、307 亿美元和 210 亿美元。随着本土龙头企业竞争力提升、国产替代进程全面提速以及应用端需求的持续扩张，中国集成电路产业总体规模有望继续扩大，根据 WIND 金融数据，2025 年中国半导体市场规模达 2,113.90 亿美元，相较 2024 年增长 15.56%，在全球市场占比约 26.57%。半导体行业在国民经济中的支柱性与基础性地位将愈发凸显，市场前景广阔。

（2）功率半导体行业发展概况

功率半导体分为功率器件和控制驱动功率器件的 IC 产品，是电子装置中电能转换

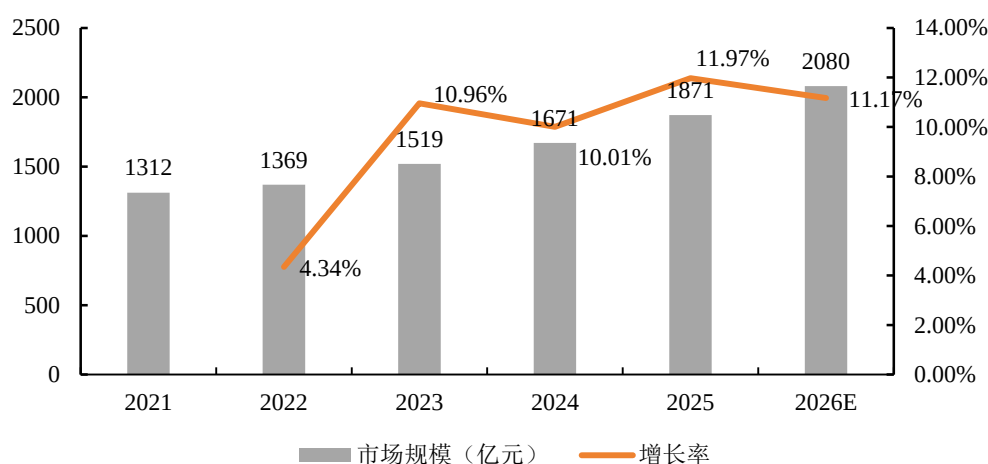
与电路控制的核心，典型的功率处理功能包括变频、变压、变流、功率放大和功率管理等。功率器件主要用于电力设备的电能变换和电路控制，是弱电控制与强电运行间的桥梁，其核心功能涵盖电能的转换、控制与保护，在电路中承担功率变换、功率放大、功率开关、线路保护、逆变（直流转交流）以及整流（交流转直流）等关键作用。



近年来，功率半导体器件已从传统的工业控制和 4C（通信、计算机、消费电子、汽车）领域扩展至数据中心电源、新能源、新能源汽车、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多产业，市场规模呈现稳健增长态势。

中国是全球最大的功率半导体消费国与生产国，根据中商产业研究院数据，2025 年中国功率半导体行业市场规模为 1,871 亿元，近三年复合增长率约 10.97%，显著高于全球平均水平。长期来看，受益于新能源汽车、光伏储能等下游需求拉动，2025-2031 年中国功率半导体行业复合增长率将维持在 14%-17%，2031 年市场规模有望突破 3,800 亿元，成长空间广阔。

2021-2026年中国功率半导体市场规模



功率半导体行业的竞争格局可分为全球与国内两个层面来看。全球市场集中度高，高端功率器件领域长期由美、日、欧等国厂商为主导，其中，高压功率 MOSFET 产品市场以英飞凌、安森美等厂商为主导，IGBT 产品市场则由英飞凌、安森美、三菱、富士电机等厂商长期占据垄断地位。功率半导体行业在我国则面临着更为复杂的局面，呈现出明显的金字塔格局：国际大厂占据高端第一梯队；部分国内 IDM 领先企业构成第二梯队，在 IGBT、中低压 MOSFET 等功率分立器件领域实现规模化量产与国产替代，并向高端市场渗透；IC 产品领域因技术壁垒较高，国内企业多集中于中低端，高端产品仍依赖进口。整体来看，国内功率半导体行业呈现分立器件先行突破、IC 产品逐步追赶的态势，国内厂商在成本、本地化服务与快速响应方面具备差异化优势，孕育出一批优秀的功率半导体器件企业，正逐步从低端市场向高端应用领域渗透。

从发展方向来看，未来行业竞争将不再局限于单一器件的性能突破，也更注重产品矩阵的完整性。在国际竞争中，德州仪器、英飞凌等厂商均已形成“控制+驱动+执行”的系统级产品矩阵，在通信基站、无人机等领域的高端电源管理芯片、栅极驱动芯片供应中形成垄断优势。这种全面的产品布局，有助于企业提升方案完整性、增强客户粘性及提高单客户价值量。

展望未来，随着电气化、数字化、智能化的持续推进，功率半导体的应用场景将进一步拓展，新能源汽车、光伏、储能、轨道交通、数据中心等新兴领域将成为行业增长的核心驱动力，尤其是新能源汽车和数据中心，将推动功率半导体需求持续放量。与此同时，国内厂商产品性能和工艺水平提升，本土市场优势和成本优势显著，使得其全球竞争力不断增强，行业国产替代将从“中低端替代”向“高端突破”转型，国内功率半

导体企业的市场份额有望持续提升。

2、发行人产品或服务的市场地位

东微半导体是一家以功率半导体研发与销售为主的技术驱动型半导体企业，产品包括高性能功率器件和 IC 产品，具备从专利到量产完整经验。在功率器件领域，公司主要产品包括 GreenMOS 系列超级结 MOSFET、SFGMOS 系列及 FSMOS 系列中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT 系列 IGBT 产品、SiC 器件（含 Si²C MOSFET）以及高密度功率模块。在 IC 产品领域，公司主要产品包括数模混合的快速充电控制芯片和开关电源控制芯片。产品终端应用聚焦于工业及汽车相关的中大功率应用领域，同时也广泛应用于消费级市场，公司的市场地位主要体现在以下方面：

（1）细分市场奠定领导地位

公司凭借优秀的半导体器件与工艺创新能力，集中优势资源聚焦新型功率器件的开发，具备从专利到量产完整经验，基于多年的技术积累、产业链深度结合能力以及优秀的客户服务能力，公司已成为国内领先的高性能功率器件设计厂商。凭借在高压高性能功率半导体领域的持续创新与市场领先地位，公司成功入选 Aspen Core 2026 中国 IC 设计 Fabless 100 排行榜之功率器件 TOP 10 榜单。在 IC 产品领域，公司数模混合的开关电源控制芯片产品也实现了对标国际领先厂商水平。

（2）自主研发夯实技术积累

公司始终坚持自主研发，持续深耕功率半导体技术领域，获评国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权优势企业等荣誉，核心产品多次荣获“中国芯”优秀市场表现产品奖。在超级结 MOSFET 领域，公司积累了包括优化电荷平衡技术、优化栅极设计及缓变电容核心原胞结构等领先专利技术，关键技术指标达国际领先厂商可比水平；在中低压屏蔽栅 MOSFET 领域，公司在电荷平衡、自对准加工、尺寸缩减及寄生电容降低等方面拥有自主技术，指标达国内外领先水平；在 IGBT 领域，公司将研发主力投入于高频和高可靠性应用市场，对标国际第八代 IGBT 技术水平布局相关器件的前期预研与技术储备；在第三代半导体领域，SiC MOSFET、Si²C MOSFET、SiC SBD 已量产，性能优势明显，公司同步推进 SiC JFET、GaN HEMT 等器件开发。在 IC 产品领域，公司的快速充电控制芯片围绕各类快充接口生态布局，开发并量产了供电端快充协议系列、受电端快充协议芯片系列和线缆端电子标签芯片等产品，广泛应

用于手机、适配器、车充、储能设备、线缆、IoT 设备等领域；公司数字电源技术经过长时间的技术积累迭代，适配图腾柱 PFC 拓扑、混合开关电容拓扑等先进高效开关电源拓扑，在超小型高压辅助电源、48V 电机和电源驱动 DrGaN 模块等多个领域产品正在逐步开发、送样。

公司高度重视研发团队及体系建设，已建立起了完善的研发团队及体系。截至 2026 年 6 月 30 日，公司共拥有 113 名研发人员，占员工总数的 41.09%。核心技术人员均在功率半导体领域耕耘超过十年，具备深厚的研发经验及前瞻性的技术创新能力。同时，公司的研发管理体系与质量体系持续优化，多个数字化系统功能不断升级。公司自研的新一代产品生命周期管理系统已上线，进一步推动研发效率的提升。

（3）卓越的品牌声誉与客户认可

公司在各类功率半导体应用领域，尤其是车规级和工业级应用领域，产品已获得众多知名企业的认可，并成为该等客户的主要国内供应商之一。同时，公司在全球范围内积累了众多知名终端品牌客户，与之建立了长期、稳定的战略合作关系。进入该等客户的供应链体系后，不仅能持续为公司带来高客户粘性，也将推动公司不断进行技术迭代升级，以满足引领行业发展的头部客户需求，为公司保持高端功率器件领域的领先地位奠定基础。这种深度的客户合作关系，是公司品牌价值、技术实力和量产保障能力的综合体现，为公司的持续经营与市场拓展提供了有力支撑。

（4）经验丰富的管理团队

公司联合创始人拥有多年的半导体行业经验，尤其是在功率半导体领域拥有国际一流的视野与技术创新能力。龚轶先生硕士毕业于英国纽卡斯尔大学，拥有超过 20 年半导体研发管理经验，曾担任全球领先的中央处理器（CPU）厂商超微半导体公司的研发工程师、全球最大的功率器件厂商英飞凌科技的德国研发中心专家，同时也是国家创新人才推进计划科技创新创业人才、江苏省科技企业家、姑苏创新创业领军人才。王鹏飞博士毕业于德国慕尼黑工业大学，从事半导体技术研发工作超过 20 年，曾担任德国英飞凌科技存储器研发中心研发工程师，曾担任复旦大学微电子学院教授，是国家高层次人才特殊支持计划领军人才入选者。

3、发行人的主要竞争对手

（1）国际主要竞争对手

①英飞凌（德国法兰克福交易所上市，代码 IFX）

英飞凌于 1999 年自西门子集团的半导体部门独立出来，是全球领先的半导体公司之一。公司主要业务集中于功率半导体、汽车电子、安全芯片以及工业控制芯片等领域，其产品广泛应用于新能源汽车、风电、太阳能、电网、工业自动化以及数据中心等行业。

②安森美（美国纳斯达克上市，代码 ON）

安森美于 1999 年从摩托罗拉分拆出来，专注于提供行业领先的智能电源和智能传感解决方案，产品系列包括电源和信号管理、逻辑、分立及定制器件，主要应用于汽车、通信、计算机、消费电子、工业、LED 照明、医疗、军事/航空及电源应用等领域。

③意法半导体（纽约证券交易所、泛欧巴黎证券交易所和意大利米兰证券交易所上市，代码 STM.N）

意法半导体成立于 1987 年，是全球领先的半导体设计与制造企业，产品包括集成电路和 MOSFET、IGBT、二极管等功率器件，是半导体产品线最广的厂商之一，在分立器件、手机相机模块和车用集成电路领域居世界前列。

④瑞萨（东京证券交易所上市，代码 6723）

瑞萨成立于 2003 年，在半导体领域方面具有先进技术和丰富经验，产品包括集成电路和功率半导体，其功率半导体产品主要包括 MOSFET、IGBT、功率集成电路、二极管、三极管及晶闸管等。

⑤日本东芝

日本东芝于 1939 年由株式会社芝浦制作所和东京电气株式会社合并成立，公司具有丰富的 MOSFET 研发与生产经验，主要产品包括 500V-800V 的中高压 DTMOS 系列和 12V-250V 的低压 U-MOS 系列等。

（2）国内主要竞争对手

①华润微（上海证券交易所科创板，688396.SH）

华润微电子成立于 2003 年，是中国领先的拥有芯片设计、掩模制造、晶圆制造、

封装测试等全产业链一体化经营能力的半导体企业，同时也是中国本土最大的功率半导体企业之一。公司主营业务聚焦于功率半导体、智能传感器与智能控制等领域，可分为产品与方案、制造与服务两大业务板块。

②宏微科技（上海证券交易所科创板，688711.SH）

宏微科技成立于 2006 年，公司自成立以来，始终专注于以 IGBT、FRD、SiC、GaN 为核心的功率半导体芯片、单管及模块的设计、研发、生产与销售，公司产品全面覆盖新能源汽车（电控系统、充电桩和 OBC 电源）、新能源发电（光伏逆变器、风能变流器和电能质量管理）、储能、工业控制（变频器、伺服电机、UPS 及各种开关电源等）、家电消费等领域。

③新洁能（上海证券交易所主板，605111.SH）

新洁能成立于 2013 年，为国内半导体功率器件设计龙头企业之一。公司主要产品是车规级功率器件、SiC MOSFET、GaN HEMT、功率模块、栅极驱动 IC、电源管理 IC、IPM 智能功率模块、MCU，重点应用领域涵盖新能源汽车及充电桩、光伏储能、服务器和数据中心、无人机、工控自动化等十余个长期被欧美日功率半导体垄断供应的行业。

④士兰微（上海证券交易所主板，600460.SH）

士兰微成立于 1997 年，是国内主要的综合型半导体设计与制造（IDM）企业之一。公司专注于硅半导体以及化合物半导体产品的设计、制造和封装，向客户提供高质量的硅基集成电路、分立器件和化合物半导体器件（LED 芯片和成品，SiC、GaN 功率器件）产品。

⑤南芯科技（上海证券交易所科创板，688484.SH）

南芯科技成立于 2015 年，是国内领先的模拟和嵌入式芯片设计企业之一，主营业务为模拟与嵌入式芯片的研发、设计和销售，专注于电源及电池管理领域，为客户提供高性能、高品质与高经济效益的完整解决方案。

（四）行业的主要进入壁垒

1、技术壁垒

功率半导体器件的性能不仅取决于电路设计，更与晶圆制造工艺深度绑定，功率半导体的研发、设计需要企业研发团队针对不同电压、电流和应用场景开发定制化的特色

工艺平台。“平台化多样性”是特色工艺企业构筑竞争壁垒、打造竞争优势的核心武器，工艺平台越强大的企业，其在技术经验、服务能力和特殊化开发能力方面越具有深厚的优势。技术和平台的能力与优势需要长期的流片验证和产品迭代才能积累，无法在短期内突破，对新进入者构成较高的技术门槛。

2、人才壁垒

当前功率半导体设计企业多采用 Fabless 模式，在这一高度专业化的分工体系中，功率半导体设计环节对研发人员的经验积累要求极高，核心技术人员通常需要在器件结构、工艺制程、可靠性设计等方向深耕十年以上，才能具备独立主导产品开发的能力。这类经验丰富、兼具工艺与设计背景的复合型人才在行业内较为稀缺，是企业保持技术领先地位的核心资源。

3、客户与市场壁垒

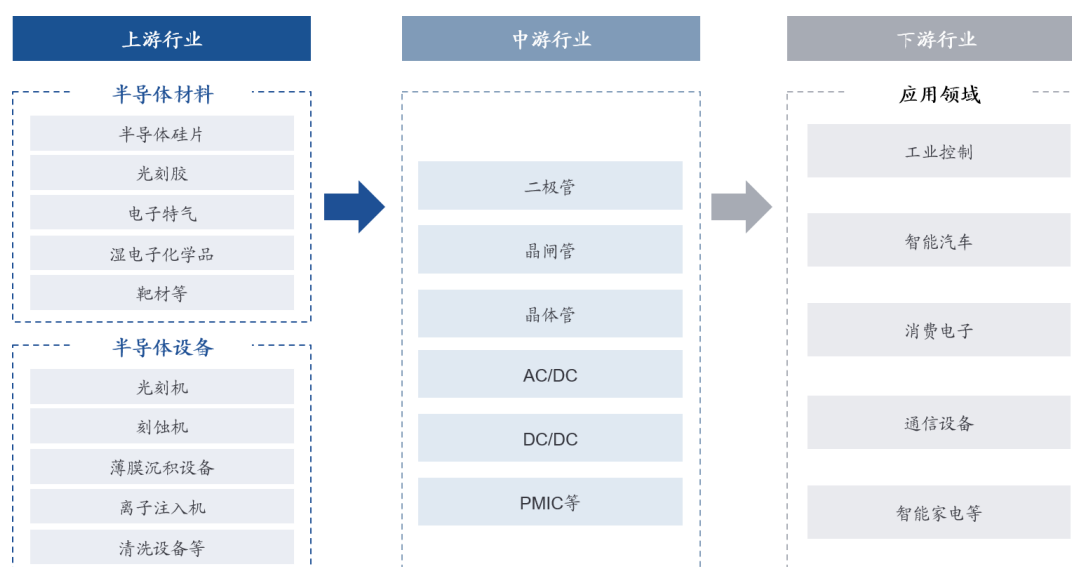
功率器件下游客户尤其是工业、汽车领域客户，对产品的可靠性、一致性和长期稳定性要求极为严苛，产品导入需经过漫长且复杂的认证流程。企业一旦成功进入客户供应链体系，便会形成较强的客户粘性，后进入者较难在短期内打入这些高壁垒的核心供应链。

4、资金和规模壁垒

功率半导体行业具有资本密集特征，产品研发、晶圆产能保障、封测环节协同均需要持续的资金投入。规模较大的企业能够通过丰富的产品组合摊薄固定成本，并在采购端获得更强的议价能力，形成规模效应；新进入者及中小企业在达到临界规模前，难以在成本和供应链稳定性上与之竞争。

（五）发行人所处行业与上下游行业之间的关联性及上下游行业发展状况

功率半导体行业上游为半导体材料及设备供应，中游涵盖设计、制造和封装测试等环节，按集成度可分为功率分立器件和 IC 产品两大类，下游应用市场广泛，涵盖工业控制、汽车、消费电子、网络通信等领域。



1、与上游行业的关联性及上游行业发展状况

公司的上游企业主要为晶圆制造厂商、封装测试厂商。公司与上游供应商均建立了稳定的合作关系，能够满足公司经营需要。在产品开发阶段，公司结合市场需求与技术方向制定产品路线图，同时根据供应商的实际制造能力进行设计与开发，并协同优化适用于晶圆厂和封装厂的工艺流程。基于长期战略合作与高效联动机制，公司能够根据终端需求精准调整产品设计，并可通过与上游供应商合作实现深度定制化开发。

功率半导体工艺较为特殊，研发团队需对晶圆厂基准工艺平台进行深度优化和定制设计。在产品研发阶段，公司与晶圆厂深入沟通，通过反复工艺调试，使晶圆厂工艺更好地实现芯片设计性能。在此过程中，晶圆代工厂的工艺能力亦在双方协作中获得提升，实现技术能力的相互促进。

在能源革命、技术迭代和新兴需求的共同驱动下，下游市场需求的变化倒逼功率器件公司提升设计能力、拓展应用场景，进而推动上游企业在技术研发和工艺创新等方面持续进步。

2、与下游行业的关联性及下游行业发展状况

公司下游客户分布广泛，涵盖工业控制、智能汽车、消费电子、通信设备、智能家电等领域。MOSFET、IGBT 等功率半导体模块作为上述领域的核心零部件，在工业级、车规级和消费级场景中均有广泛应用。

随着上述领域的快速发展，下游客户对公司产品的需求量持续增加。同时，由于该领域客户认证壁垒较高，公司进入头部客户供应链后，不仅能获得高客户粘性，也将持

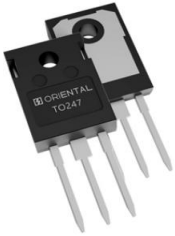
续推动公司进行技术迭代升级，以满足引领行业发展的头部客户需求，为公司保持高端功率器件领域的领先地位奠定基础。

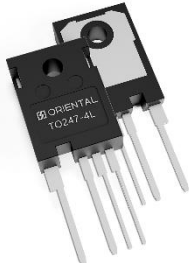
十、公司主营业务的具体情况

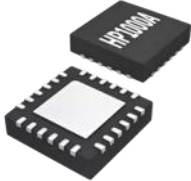
（一）公司的主营业务及主要产品

公司专注于高性能功率半导体的研发和销售，产品涵盖高性能功率器件与 IC 产品。在功率器件领域，公司主要产品包括 GreenMOS 系列超级结 MOSFET、SFGMOS 系列及 FSMOS 系列中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT 系列 IGBT 产品、SiC 器件（含 Si²C MOSFET）以及高密度功率模块。在 IC 产品领域，公司主要产品包括数模混合快速充电控制芯片和数模混合开关电源控制芯片。公司致力于提供从信号处理、逻辑控制到功率输出的完整“控制—驱动—执行”全链路解决方案，逐步从高性能功率器件供应商，升级成为新一代数字能源管理系统解决方案的供应商。

发行人的主要产品具体情况如下：

产品名称	产品介绍	应用领域	产品图片
高性能功率器件/功率模块			
超级结 MOSFET	超级结 MOSFET 产品主要为 GreenMOS 产 品系列，全部采用超级结的技术原理，具有 开关速度快、动态损耗低、可靠性高的特点 及优势 技术特点： 低导通电阻、低栅极电荷、静态与动态损耗 低	<u>车规级和工业级：</u> 5G 基站电源及通信电源、数据中 心和算力服务器电源、新能源汽车 车载充电机、UPS 电源以及工 业照明电源、新能源汽车直流充 电桩、光伏逆变器和储能等 <u>消费级：</u> PC 电源、适配器、TV 电源板、 手机快速充电器等	
中低压屏蔽栅 MOSFET	中低压 MOSFET 产品依托自主创新的屏蔽 栅晶体管技术平台，主要包括 SFGMOS 产 品系列以及 FSMOS 产品系列。其中， 1) SFGMOS 产品系列采用自对准屏蔽栅结 构，兼备了传统平面结构和屏蔽栅结构的优 点，具有更高的工艺稳定性、可靠性及更快 的开关速度、更小的栅电荷和更高的应用效 率等优点 2) FSMOS 产品系列采用基于硅基工艺与电 荷平衡原理的新型屏蔽栅结构，有效降低了 器件的导通电阻和米勒电容，全面提升了产 品的导通电阻温度特性，显著增强器件在高 温下的耐流能力和稳定性。全系列产品采用 Copper Clip 技术封装，有效降低封装电阻， 适用于超低导通电阻的产品，器件优值和散 热性能得以提高，具备更高的应用效率与系 统兼容性 技术特点： 特征导通电阻低，开关速度快，动态损耗低	<u>车规级和工业级：</u> 电动工具、智能机器人、无人机、 新能源汽车电机控制、逆变器、 UPS 电源、动力电池保护板、高 密度电源等 <u>消费级：</u> 移动电源、适配器、数码类锂电 池保护板、多口 USB 充电器、手 机快速充电器、电子雾化器、PC 电源、TV 电源板等	

产品名称	产品介绍	应用领域	产品图片
超级硅 MOSFET	公司自主研发、性能对标氮化镓功率器件产品的高性能硅基 MOSFET 产品。通过调整器件结构、优化制造工艺，突破了传统硅基功率器件的速度瓶颈，在电源应用中达到了接近氮化镓功率器件开关速度的水平 技术特点： 极快的开关速度与极低的动态损耗	<u>工业级：</u> 新能源汽车直流充电桩、通信电源、工业照明电源等 <u>消费级：</u> 各种高密度电源、快速充电器、模块转换器、快充超薄类 PC 适配器、TV 电源板等	
Tri-gate IGBT	公司 IGBT 产品采用具有独立知识产权的 TGBT 器件结构，区别于国际主流 IGBT 技术，通过对器件结构的创新实现了关键技术参数的大幅优化。产品的工作电压范围覆盖 600V-1350V，工作电流覆盖 15A-200A。在不提高制造难度的前提下提升了电流密度，优化了内部载流子分布，调整了电场与电荷的分布，同时优化了导通损耗与开关损耗 技术特点： 大电流密度，开关损耗低，可靠性高，具有自保护特点	<u>车规级和工业级：</u> 新能源汽车直流充电桩、变频器、逆变器、电机驱动、电焊机、压缩机控制、太阳能、UPS 电源等 <u>消费级：</u> 感应加热等	
SiC MOSFET/SBD	公司的 SiC 器件包括 SiC 二极管、SiC MOSFET 等产品。其中，SiC 二极管、SiC MOSFET 全部使用了 SiC 衬底，充分利用 SiC 宽禁带材料的耐高压和耐高温特性 技术特点： 高速开关、超低的反向恢复时间与反向恢复电荷	<u>车规级和工业级：</u> 新能源汽车直流充电桩、新能源汽车车载充电机、储能逆变器、高效率通信电源、高效率服务器电源等	
Si ² C MOSFET	Si ² C MOSFET 克服了传统 SiC MOSFET 成本高和可靠性挑战大的缺点，实现了低成本和高栅氧可靠性，同时还实现了接近 SiC MOSFET 优秀的反向恢复能力，能够在特定应用场景中为客户提供多种选择 技术特点： 高栅氧可靠性，易用性高	<u>工业级：</u> 新能源汽车车载充电机、储能逆变器、高效率通信电源、高效率服务器电源等	
功率模块	功率模块作为电力电子装置的核心组件，通过将功率半导体器件（如 IGBT、MOSFET 或 SiC）的保护电路高度集成，实现了电能的高效转换与智能控制 技术特点： 采用 DBC/AMB 等高导热基板与先进封装工艺，具备优异的热管理性能与低寄生参数，显著降低损耗并提升系统效率；同时，模块内置过流、过热等多重智能保护机制，在实现设备小型化、高功率密度的同时，大幅增强了系统的可靠性与稳定性	<u>车规级和工业级：</u> 新能源汽车车载充电机、主驱电控、空调压缩机、高效率算力服务器电源等	
IC 产品			

产品名称	产品介绍	应用领域	产品图片
数模混合快速充电控制芯片	专为快速充电系统设计的控制芯片，支持各种主流的充电接口，包括 USB Type A，USB Type C 和 GPMI 接口。自动实现各类快充协议的协商与功率输出控制。 技术特点： 支持快充接口主流快充协议，并具备自适应的协议协商与输出控制。同时集成快充系统电源管理功能，智能功率管理。具备完备的电源系统状态检测与快速的故障响应机制	<u>消费类：</u> 旅充，排插，线缆，各类快充接口充电设备等	
数模混合开关电源控制芯片	适配于 AC-DC 转换拓扑和 DC-DC 转换拓扑的数字化开关电源控制器。作为开关电源的控制核心，配合栅极控制器来控制功率级电路将输入电能转换至输出。 技术特点： 全数字化可编程控制环路，可实现多种拓扑的灵活配置，支持图腾柱 PFC、交错 PFC、硬开关全桥、混合开关电容、开环 LLC 等各类开关电源拓扑。通过先进的数字化非线性控制策略以实现优越的电源系统的稳态精度、动态性能和电磁兼容性能，并针对各拓扑控制策略实施多种优化策略，提供精简、易用的控制方案。	<u>工业级：</u> PC 电源、充电器、服务器电源、中间母线变换器	

（二）主要经营模式

1、盈利模式

公司专业从事功率半导体的设计、研发和销售，主要向客户销售高性能功率器件、IC 产品等获得收入和利润。报告期内公司不断推动功率产品迭代，持续扩展下游知名客户，满足数据中心电源、工业通讯电源、光伏储能、新能源汽车、消费电子等多场景需求。

2、研发模式

公司产品的研发流程主要包括产品开发需求信息汇总、立项评估与可行性评估、项目设计开发、产品试制以及测试验证等四个环节。该四项环节主要由研发部、运营部等合作完成，同时，研发部质量团队会全程参与产品研发的所有环节，监督各环节的执行过程，以在全环节实现对产品质量的管控。公司已制定《产品开发管理程序》，产品研发流程严格遵守该制度约定流程，并通过产品生命周期管理系统进行产品开发管控。

3、采购与生产模式

公司作为专业的功率半导体设计及研发企业，自成立以来始终采用 Fabless 的经营模式。Fabless 模式指无晶圆厂模式，采用该模式的企业专注于芯片的研发设计与销售，

将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。

公司采购的内容主要为定制化晶圆制造、封装及测试服务，以及实验室设备的采购。在 Fabless 模式中，公司主要进行功率器件产品的研发、销售与质量管控，产品的生产采用委外加工的模式完成，随后将制造完成的晶圆交由封测厂进行封装和测试。公司已经与行业知名的晶圆代工厂商和封装测试服务供应商建立深度绑定关系，在技术研发、业务落地、市场拓展等维度实现全方位、深层次协同合作。

在质量管控方面，公司建立了以质量部为核心的质量管理体系，有效提高了公司产品和服务的整体质量。公司拥有研发部、运营部、销售部等多个业务部门，且各部门职能相对独立；同时，公司的质量部协助其他部门制定其操作规范、记录和整理日常的工作文档、监督和指导各部门的工作和质量控制流程，其贯穿产品开发、生产、运营和销售的全过程。

4、销售模式

结合行业惯例和客户需求情况，公司目前采用“经销+直销”的销售模式，即公司通过经销商销售产品，同时也向终端系统厂商直接销售产品。在经销模式下，公司与经销商的关系主要为买断式销售关系，公司将产品送至经销商或者经销商指定地点；在直销模式下，公司直接将产品销售给终端客户，公司将产品送至客户指定地点。

公司建立了完善的客户管理制度，对于长期合作客户，公司与其签订框架合作协议，并安排专员提供全方位服务；对于其他客户，公司根据订单向其供货。半导体行业上下游之间粘性较强，公司产品需要通过较为严格的质量认证测试，一旦受到客户的认可和规模化使用，双方较易形成长期稳定的合作关系。

（三）生产、销售情况和主要客户

1、主要产品的产量和销量情况

单位：万颗					
产品类别	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
功率器件	产量	31,361.59	50,250.67	38,067.17	24,885.57
	销量	31,273.82	45,762.74	35,710.88	23,738.17
	产销率	99.72%	91.07%	93.81%	95.39%

产品类别	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
IC 产品	产量	9,839.11	不适用		
	销量	10,139.34			
	产销率	103.05%			
合计	产量	41,200.70	50,250.67	38,067.17	24,885.57
	销量	41,413.16	45,762.74	35,710.88	23,738.17
	产销率	100.52%	91.07%	93.81%	95.39%

2、报告期内主要客户情况

报告期内，公司前五名客户情况如下：

单位：万元

年度	序号	客户	金额	比例
2026 年 1-6 月	1	上海贵秦电子有限公司	13,001.31	17.65%
	2	客户 A	8,132.26	11.04%
	3	东莞市众麦祥电子科技有限公司	7,017.03	9.53%
	4	上海蓝伯科电子科技有限公司	5,677.23	7.71%
	5	南京商络电子股份有限公司	4,727.18	6.42%
	合计		38,555.01	52.35%
2025 年度	1	上海贵秦电子有限公司	18,732.87	14.95%
	2	客户 A	11,219.47	8.96%
	3	上海蓝伯科电子科技有限公司	11,203.84	8.94%
	4	上海云创电气设备有限公司	9,860.96	7.87%
	5	比亚迪股份有限公司	9,556.76	7.63%
	合计		60,573.90	48.35%
2024 年度	1	比亚迪股份有限公司	13,549.79	13.51%
	2	上海贵秦电子有限公司	12,201.40	12.16%
	3	上海云创电气设备有限公司	8,327.40	8.30%
	4	南京商络电子股份有限公司	6,155.91	6.14%
	5	上海蓝伯科电子科技有限公司	5,949.28	5.93%
	合计		46,183.78	46.04%
2023 年度	1	上海蓝伯科电子科技有限公司	16,552.16	17.01%
	2	上海贵秦电子有限公司	13,730.06	14.11%

年度	序号	客户	金额	比例
	3	客户 A	12,158.27	12.50%
	4	深圳市凯新达电子有限公司	8,634.86	8.88%
	5	上海云创电气设备有限公司	3,831.19	3.94%
	合计		54,906.54	56.44%

注：同一控制下公司已合并计算

报告期各期公司对前五大客户的销售比例分别为 56.44%、46.04%、48.35%和 52.35%，整体保持稳定，较为分散，不存在向单一客户销售占比超过 30%的情况。

（四）主要原材料和能源采购情况

1、报告期内主要原材料采购情况

公司作为 Fabless 模式下的集成电路设计企业，对外采购主要包括晶圆和封装测试服务。报告期内，公司主要采购情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
晶圆	58,183.67	80.95%	102,755.68	81.22%	72,769.86	80.74%	80,857.16	87.47%
封装测试服务	13,674.59	19.03%	23,425.12	18.52%	17,361.50	19.26%	11,578.86	12.53%
其他	15.27	0.02%	327.46	0.26%	-	-	-	-
合计	71,873.53	100.00%	126,508.26	100.00%	90,131.36	100.00%	92,436.02	100.00%

2、报告期内境内外主要原材料采购情况

报告期内，发行人境内外主要原材料采购情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	70,150.10	97.60%	125,277.62	99.03%	87,233.50	96.78%	90,870.61	98.31%
境外	1,723.43	2.40%	1,230.64	0.97%	2,897.87	3.22%	1,565.41	1.69%
合计	71,873.53	100.00%	126,508.26	100.00%	90,131.36	100.00%	92,436.02	100.00%

注：境内外采购按照供应商注册地作为划分依据。

3、报告期内能源采购情况

公司主要采用 Fabless 模式，专注于芯片的研发设计与销售，将晶圆制造、封装、测试等生产环节外包给第三方晶圆制造和封装测试企业完成。报告期内，公司经营活动耗用的能源主要为办公用水、用电，均由市政供应，价格稳定，且消耗量较小，占公司成本和费用的比例较低，未对公司的经营业绩造成重大影响。

4、报告期内主要供应商情况

报告期内，公司前五名供应商情况如下：

单位：万元

年度	序号	供应商名称	金额	占比
2026 年 1-6 月	1	华虹宏力半导体有限公司	45,699.13	63.58%
	2	粤芯半导体技术股份有限公司	7,664.81	10.66%
	3	天水华天电子集团股份有限公司	6,400.02	8.90%
	4	成都集佳科技有限公司	2,952.81	4.11%
	5	DB HiTek Co., Ltd	1,723.43	2.40%
	合计		64,440.20	89.66%
2025 年度	1	华虹宏力半导体有限公司	90,489.33	71.53%
	2	天水华天电子集团股份有限公司	10,176.75	8.04%
	3	粤芯半导体技术股份有限公司	8,510.19	6.73%
	4	成都集佳科技有限公司	5,034.21	3.98%
	5	日月新半导体（威海）有限公司	4,234.82	3.35%
	合计		118,445.30	93.63%
2024 年度	1	华虹宏力半导体有限公司	64,172.51	71.20%
	2	天水华天电子集团股份有限公司	7,108.26	7.89%
	3	成都集佳科技有限公司	4,285.65	4.75%
	4	日月新半导体（威海）有限公司	4,260.46	4.73%
	5	粤芯半导体技术股份有限公司	4,032.66	4.47%
	合计		83,859.54	93.04%
2023 年度	1	华虹宏力半导体有限公司	74,054.64	80.11%
	2	天水华天电子集团股份有限公司	5,210.89	5.64%
	3	粤芯半导体技术股份有限公司	4,363.59	4.72%
	4	成都集佳科技有限公司	2,812.92	3.04%

年度	序号	供应商名称	金额	占比
	5	日月新半导体（威海）有限公司	2,750.73	2.98%
		合计	89,192.77	96.49%

注：同一控制下公司已合并计算

报告期各期，公司向前五大供应商合计采购金额占当期采购总额的比例分别为 96.49%、93.04%、93.63%、89.66%，公司向前五大供应商的采购占比超过 50%，其中向华虹宏力半导体有限公司采购金额占当期采购总额比例分别为 80.11%、71.20%、71.53% 及 63.58%，且存在向单个供应商的采购占比超过 30%的情形，主要系公司半导体功率器件设计采用 Fabless 模式，该种模式系芯片设计企业的主流经营模式之一。采用 Fabless 模式的芯片设计公司通常需要选择晶圆代工厂及封装测试厂进行深度合作。报告期内，公司综合考虑产品产量、工艺稳定性和批量采购成本优势等因素，主要选择少数晶圆代工厂及封装测试厂进行合作，因此公司向前五大供应商采购金额较大且采购集中度较高，符合行业特性。

报告期内，公司前五大供应商变动均系与历史供应商合作，公司根据订单情况增加或减少对其采购量，因而部分供应商新进入公司前五大供应商范围。

（五）公司环境保护情况

公司为典型的集成电路设计企业，所处行业不属于国家有关部门界定的存在重污染情况的行业，其生产经营活动基本不涉及环境污染、环境污染物、处理设施及处理能力。

（六）现有业务发展安排及未来发展战略

公司以“成为新一代数字能源管理系统解决方案的供应商”为经营愿景，专注于高性能功率半导体的研发和销售，涵盖高性能功率器件与 IC 产品等的开发和销售。基于多年的技术积累、产业链深度结合能力以及优秀的客户服务能力，公司已成为国内领先的高性能功率半导体设计厂商。

公司现有产品广泛应用于以 5G 基站电源及通信电源、数据中心和算力服务器电源、车载充电机、车身加热和平衡系统、UPS 电源和工业照明电源、新能源汽车直流充电桩、光伏逆变及储能为代表的工业级应用领域，以及以 PC 电源、适配器、TV 电源板、手机快速充电器为代表的消费电子应用领域。

未来，公司在维持高压超结 MOSFET 领域竞争优势的基础上拟通过丰富产品矩阵和优化业务结构，进一步增强盈利能力。在高性能功率器件领域，公司将积极拓展中低压产品在数据中心及服务器电源、汽车电子、电机驱动等领域的应用，通过优化产品结构，推动功率器件业务盈利能力稳步改善。并且公司将持续完善高性能功率器件产品布局，包括拓展 SiC 器件全电压等级产品线、推进 GaN HEMT 器件、推动公司硅基功率器件向低电荷、低损耗方向迭代升级。另一方面，公司将在功率器件业务稳步发展的基础上，依托数模混合快速充电控制芯片和数模混合开关电源控制芯片领域的技术积累，持续推进数字能源控制 IC、电源管理相关 IC 等产品的研发和技术布局，扩大上述领域销售规模，逐步提高相关产品的收入占比，优化公司业务结构并培育新的业务增长点。

随着下游应用向高效率、高功率密度和数字化控制方向发展，客户需求逐步由单一器件采购向器件选型、系统适配、联合验证及整体方案支持延伸。公司着眼于长远发展，在巩固高性能功率器件业务优势的基础上，持续拓展功率驱动、智能控制等 IC 产品的技术布局并推动产业化进程，逐步构建“控制-驱动-执行”相互协同的产品体系，并结合相应的系统应用支持，提升对下游客户多元化需求的综合服务能力。

十一、与公司产品有关的技术情况

（一）研发投入情况

报告期各期，公司研发投入分别为 8,505.02 万元、7,571.57 万元、9,231.76 万元和 5,565.28 万元，占营业收入的比例分别为 8.74%、7.55%、7.37%和 7.56%，具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
研发投入	5,565.28	9,231.76	7,571.57	8,505.02
营业收入	73,643.34	125,268.76	100,322.00	97,285.03
研发投入占营业收入的比重	7.56%	7.37%	7.55%	8.74%

研发投入的具体构成情况，详见本募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”之“（四）利润主要来源及经营成果变化分析”之“3、期间费用分析”相关内容。

（二）报告期内研发形成的重要专利及非专利技术及其应用情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司已获得授权且尚在有效期内的专利共 202 项，其中包括 195 项发明专利、7 项实用新型专利。

报告期内，公司研发形成的授权专利技术详见“附录三：发行人及其子公司拥有的境内专利”及“附录四：发行人及其子公司拥有的境外专利”相关内容。

（三）发行人核心技术人员与研发人员情况

1、核心技术人员及其变化情况

截至本募集说明书签署之日，公司拥有 3 名核心技术人员，分别为王鹏飞、王毅和毛振东。公司的核心技术人员均在功率半导体领域耕耘超过十年，具有丰富的研发经验，并对行业未来的技术发展趋势具有前瞻性的创新能力。报告期内，公司核心技术人员的变化情况主要为：（1）2025 年 5 月，原核心技术人员刘磊因个人职业发展原因辞职，辞职后不再担任东微半导体任何职务；（2）2025 年 12 月，原核心技术人员刘伟因工作内容调整，不再认定为公司核心技术人员，但仍继续在公司任职；新增认定王毅为公司核心技术人员。

2、研发人员及其变化情况

公司报告期内研发人员情况如下：

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
研发人员（人）	113	78	69	65
研发人员数量占公司总人数的比例	41.09%	37.68%	43.67%	50.39%

（四）核心技术来源及其对发行人的影响

公司深耕高性能功率半导体的研发与设计领域，产品广泛应用于多种电力电子系统。目前，公司在硅基器件、第三代半导体及功率模块等关键方向上已构建起多项核心技术壁垒，并成功将这些技术全面应用于公司的主营产品中，实现了技术与产品的深度融合。截至本募集说明书签署之日，公司共有 12 项核心技术，来源均为自主研发，不存在侵权或者可能涉及侵权纠纷的情形，对发行人生产经营和独立性不构成重大不利影响。截至报告期末，公司所掌握的核心技术如下：

核心技术	技术来源	技术简介
超级结 MOSFET 设计及工艺技术	自主研发	深槽超级结 MOSFET 的设计及工艺技术包括优化电荷平衡技术、优化栅极设计及缓变电容核心原胞结构等技术。电荷平衡技术兼具技术先进性与工艺稳定性，技术方面大幅提高衬底掺杂浓度，有效降低导通电阻；稳定性方面使产品内部电场更加均衡，性能更加稳定。栅极结构优化以及缓变电容核心原胞结构技术解决了超级结 MOSFET 由于开关速度快导致的开关震荡的问题。由于导通损耗与导通电阻成正比，超级结 MOSFET 在导通损耗方面具有很大的优势；同时，开关时间越短，开关过程的能量损耗就越低。超级结 MOSFET 拥有极低的 FOM 值，从而拥有极低的开关损耗和驱动能量损耗。
中低压屏蔽栅 MOSFET 设计及工艺技术	自主研发	中低压屏蔽栅 MOSFET 设计及其工艺技术包括自对准的制造技术、电荷平衡原理以及全新的器件结构与生产工艺，实现了电场调制耐压的提高，形成了高功率密度、低开关损耗、高可靠性等特点。
Tri-gate IGBT 设计及工艺技术	自主研发	TGBT 产品设计及其工艺技术具体包括载流子控制技术、原胞功率调制技术以及独创的器件结构等。载流子控制技术优化了 IGBT 器件在导通时的内部载流子分布；原胞功率调制技术使器件在大功率开关过程中的功率分布更加均匀，避免了局部电压电流过大而导致的器件失效，使得器件具有更高的工作稳定性；公司独创的器件结构提升了产品的电场调制能力，提高了耐压性以及载流子浓度，因此提升了产品整体的可靠性。
Hybrid-FET 器件设计及工艺技术	自主研发	Hybrid-FET 器件及其工艺技术包括全新的器件架构以及电流动态调整技术。这种特殊的器件结构结合了导通电流密度高与开关速度快的特点，可实现高速关断和大电流的处理能力；采用电流动态调整技术则使器件在不同的应用工作状态下拥有不同的电学表现，具有更加宽广的安全工作区域，可提高产品的整体稳定性。公司的 Hybrid-FET 器件兼具 IGBT 与 MOSFET 器件的优势，综合提供更加符合应用场景的解决方案，器件及其工艺技术处于国内领先水平。Hybrid-FET 器件基于 TGBT 技术，是 TGBT 的一个子类。1）原创的器件架构，兼具 IGBT 与 MOSFET 器件的优势，综合提供更加符合应用场景的解决方案；2）电流动态调整技术，具有更加宽广的安全工作区；3）结合了导通电流密度高与开关速度快的特点，可实现高速关断和大电流的处理能力，尤其在 DCDC 领域，兼顾了性能与成本的要求。
碳化硅 SiC MOSFET	自主研发	公司长期跟进 SiC 技术的发展，包括 SiC 器件的 FOM 设计、高可靠性的栅氧工艺以及测试筛选技术等。公司通过逐步积累知识产权，并和头部工厂保持联动，积极推进 SiC 器件产品的自主研发和规模化生产交付工作。
新型 Si ² C 器件设计及工艺技术	自主研发	Si ² C MOSFET 器件具有独创的器件架构与优化的制造工艺，拥有极好的栅氧可靠性与高栅源耐压，同时具有极低的反向恢复时间和反向恢复电荷，易于应用，适用于图腾柱无桥 PFC、H 桥逆变等拓扑结构，已用于新能源汽车车载充电桩、光伏逆变及储能等领域。技术特点主要包括：1）原创的器件技术架构，兼具 Si 基器件的高成熟度和 SiC 器件的高性能；2）高栅氧可靠性、易用性高、性价比高；3）极快的反向恢复时间与极低的反向恢复电荷；4）可实现全架构国产供应链

核心技术	技术来源	技术简介
		代工制造。
超级硅 MOSFET 设计及工艺技术	自主研发	公司的超级硅 MOSFET 设计及其工艺技术主要包括独创的器件结构与优化的制造工艺，拥有高速开关以及低动态损耗的特性，在硅基制造工艺上进一步提升了器件的开关速度，在主流快速充电器应用中能获得接近氮化镓（GaN）功率模块的效率和功率密度，产品具有栅电荷与导通电阻的乘积优值低、工艺成熟度高的特点及优势。由于超级硅系列产品采用的硅基制造工艺更加成熟，一方面相较氮化镓器件可靠性更高，另一方面具有优秀的动态特性，可以进入 SiC MOSFET 及 GaN HEMT 的应用领域。技术特点主要包括：1）原创的器件结构与优化的制造工艺；2）极快的开关速度与极低的动态损耗；3）在主流快速充电器应用中能获得接近氮化镓（GaN）功率模块的效率和功率密度；4）二代超级硅器件提供更加优良的性能。
半导体模块设计及制造技术	自主研发	公司掌握先进的半导体模块设计与制造技术，通过优化的封装结构与低寄生电感设计，显著提升了功率密度与散热效率；结合 SJMOS、IGBT、SGT 及 SiC 等先进器件技术，实现了低损耗与高可靠性，全面满足车规级及高端工业应用的严苛要求。技术特点主要包括：1）多芯片封装的模块结构；2）高功率密度；3）高可靠性设计；4）实现低杂感和高效率；5）支持顶部液冷散热。
GaN HEMT 设计和工艺技术	自主研发	公司紧跟 GaN 技术的发展，包括 GaN 器件的 FOM 设计、高可靠性的栅极、欧姆接触、钝化层工艺以及测试筛选技术等。公司通过逐步积累知识产权，并与头部工厂保持紧密合作，推进 GaN 器件产品的自主研发和规模化生产交付工作
基于第三代半导体的高压辅助电源 IC 技术	自主研发	基于公司第三代半导体产品技术，公司在系统层面优化辅助电源 IC 的高压启动电路与高功率密度架构，开发了具备高耐压及高可靠性特点的高压辅助电源 IC 平台。报告期内，平台已完成核心电路架构与版图设计，正推进首次流片验证。
快速充电控制策略与控制器设计技术	自主研发	快速充电系统由供电端、线缆端和受电端构成，每个环节产品均存在多种快速充电协议，包括国外的 USB PD 协议、BC1.2、QC 等协议以及国产的 UFCS、SCP、FCP 等协议。针对实际应用场景中的各类组合，快速充电控制策略能够自动识别各个环节所支持的快充协议，自适应选择最合适的充电协议，以提供最佳的用户体验。同时，针对快速充电系统所需要的各类组件，研发功率与控制融合的集成技术，不断提升单个控制器产品集成度，减少系统的整体设计复杂度。
数字化开关电源控制策略与控制器设计技术	自主研发	数字化开关电源控制以数字化控制为核心，将开关电源的反馈至占空比调节部分通过数字代码的方式实现，大幅减少外围模拟器件，以解决模拟控制技术中的器件参数漂移、控制策略单一、缺乏灵活调度能力等缺点。通过内部高精度、低时延的模拟外设功能模块，将开关电源的各个模拟输入信号转化为数字信号，以进行全数字域的策略处理。通过数字域的代码实现，开关电源可实现稳定可靠的控制输出、多模式非线性的先进控制策略、全状态的实时监控与动态调节，有效提升开关电源的灵活度和电源系统的整体性能。1）全数字实现的 PID 补偿器，具备多变量自适应调节功能，自动依据应用条件调节至最优状态；2）高精度、低时延的模数转换单元，将模拟信号准确、及时的转化为数字信号，提升电源动

核心技术	技术来源	技术简介
		态性能；3）多通道实时并行监控与调节系统，监控开关电源各个关键节点，并具备独立智能调节功能，保障输出参数的稳定性与可靠性。

十二、公司主要固定资产、无形资产情况

（一）主要固定资产

1、固定资产总体情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人主要固定资产情况如下表所示：

单位：万元

序号	资产名称	账面余额	累计折旧	账面价值
1	房屋及建筑物	11,435.73	937.43	10,498.30
2	通用设备	897.70	630.62	267.08
3	专用设备	8,842.64	3,277.46	5,565.18
4	运输工具	320.98	229.78	91.20
合计		21,497.04	5,075.29	16,421.76

2、房屋建筑物情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人及其重要子公司拥有的主要房屋及建筑物情况如下表所示：

序号	权属	证号	建筑面积 (平方米)	房屋坐落	类型	规划用途	是否抵押
1	东微 半导	苏（2025）苏州工业园区 不动产权第 0036402 号	13,014.82	苏州工业园区金鸡湖 大道 99 号 1 幢 101 室	房屋（构筑物）所有权	非居住	否

3、房屋租赁情况

（1）境内租赁

截至本募集说明书签署日，发行人及其重要子公司向第三方租赁的主要境内房产情况如下表所示：

序号	出租方	承租方	房产地址	面积（㎡）	租赁期限	用途
1	深圳市特区建设发展集团有限公司	东微半导	深圳市南山区创智云城大厦(工业区)1标段1栋C座19层05号	534.62	2023年12月22日至2026年12月21日	办公
2	深圳市创科园区投资有限公司	深圳慧能泰	深圳市南山区万科云城(一期)7栋E座21层2102、2103号(深圳国际创新谷3栋21层2102、2103号房)	989.58	2025年10月20日至2028年10月19日	研发
3	杭州尚坤卓越科技有限公司	深圳慧能泰	杭州市拱墅区萍水街299号萍水太合商业中心7幢503室	58.00	2026年9月1日至2028年8月31日	办公
4	上海中京电子标签集成技术有限公司	上海慧能泰	上海市浦东新区盛夏路500弄2号10楼整层	1,028.63	2023年12月1日至2028年3月31日	办公

（2）境外租赁

截至2026年6月30日，发行人及其重要子公司不存在向第三方租赁主要境外房产情况。

（二）主要无形资产

截至2026年6月30日，发行人及其控股子公司主要无形资产情况如下表所示：

单位：万元

序号	资产名称	账面余额	累计摊销	账面价值
1	土地使用权	1,021.76	8.51	1,013.25
2	软件	1,047.82	612.87	434.95
3	专利技术	3,412.33	267.33	3,145.00
4	商标	900.00	67.50	832.50
合计		6,381.91	956.22	5,425.69

1、土地使用权

截至2026年6月30日，发行人及其子公司拥有的土地使用权具体情况如下：

序号	权属	证号/地号	面积（㎡）	终止日期	坐落	类型	用途	是否抵押
1	东微半导	苏（2025）苏州工业	1,754.94	2071.10.13	苏州工业园区金鸡	国有建设用地使用	工业用地	否

序号	权属	证号/地号	面积（m²）	终止日期	坐落	类型	用途	是否抵押
		园区不动产权第0036402号			湖大道99号1幢101室	权		
2	东微半导	苏（2026）苏州工业园区不动产权第0000077号	26,792.31	2056.04.23	苏州工业园区星汉东街，苏虹西路北	国有建设用地使用权	一类工业用地	否

2、商标

截至2026年6月30日，发行人及其重要子公司已取得的境内注册商标38项、境外注册商标18项，合计56项，具体情况详见“附录一：发行人及其子公司拥有的境内注册商标”及“附录二：发行人及其子公司拥有的境外注册商标”相关内容。

3、专利技术

截至2026年6月30日，发行人及其重要子公司已取得的境内专利110项、境外专利92项，合计202项，具体情况详见“附录三：发行人及其子公司拥有的境内专利”及“附录四：发行人及其子公司拥有的境外专利”相关内容。

4、软件著作权

截至2026年6月30日，发行人及其重要子公司已取得的计算机软件著作权合计1项，具体情况详见“附录五：发行人及其子公司拥有的软件著作权”相关内容。

5、集成电路布图设计专有权

截至2026年6月30日，发行人及其重要子公司已取得的集成电路布图设计专有权合计105项，具体情况详见“附录六：发行人及其子公司拥有的集成电路布图设计专有权”相关内容。

十三、公司拥有的特许经营权情况

截至2026年6月30日，发行人及其下属企业无特许经营权。

十四、发行人报告期内重大资产重组情况

报告期内，公司不存在重大资产重组情况。

十五、公司的境外经营情况

公司的境外子公司包括香港赛普锐思有限公司、香港慧能泰、美国慧能泰，具体参见本募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况”之“（三）合并财务报表范围及其变化情况”相关内容。

公司来源于不同销售区域的收入情况参见本募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“七、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”。

公司境外租赁情况参见本节“十二、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（一）主要固定资产”之“3、房屋租赁情况”之“（2）境外租赁”。

十六、报告期内的分红情况

（一）公司现行利润分配政策

根据现行《公司章程》，公司利润分配的政策如下：

“第一百五十八条 公司的利润分配政策及其决策程序

（一）公司的利润分配政策

1.利润分配原则：公司应当执行稳定、持续的利润分配政策，利润分配应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可分配利润范围。

2.利润分配形式：公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。

3.中期利润分配：在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。

4.现金利润分配：在公司当年经审计的净利润为正数且符合《公司法》规定的利润分配条件的情况下，如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司每年度采取的利润分配方式中应当含有现金分配方式，且公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的 10%。

5.股票利润分配：公司在实施以现金方式分配利润的同时，可以以股票方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后

的总股本是否与公司目前的经营规模相适应，并考虑对未来债权融资成本的影响，以确保分配方案符合全体股东的整体利益。

6.如公司董事会作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式决定的，应就其作出不实施利润分配或实施利润分配的方案中不含现金分配方式的理由，在定期报告中予以披露。

7.公司的利润分配政策不得随意变更。如现行政策与公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确实发生冲突的，可以调整利润分配政策。调整利润分配政策应广泛征求独立董事、公众投资者的意见，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元；（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

（二）公司的差异化现金分红政策

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1.公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2.公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照第 3 项规定处理。

（三）公司的利润分配政策决策程序

1.公司的利润分配政策由董事会本章程规定、公司盈利情况、资金供给和需求等提出、拟定，经董事会审议通过后，提请股东会审议。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。

2.独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。在股东会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。

3.公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。董事会认为需要调整利润分配政策时，可以提交利润分配政策调整方案供股东会审议。

4.存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

（二）最近三年公司利润分配情况

1、最近三年利润分配方案

公司最近三年的利润分配方案如下：

年度	利润分配方案	利润分配结果
2023 年	每 10 股派发现金红利 1.7875 元（含税），同时以资本公积金每 10 股转增 3 股	派发现金红利 1,680.52 万元（含税），转增 28,204,532 股
2024 年	每 10 股派发现金红利 0.3955 元（含税）	派发现金红利 482.89 万元（含税）
2025 年	每 10 股派发现金红利 0.7540 元（含税）	派发现金红利 924.22 万元（含税）

2、最近三年现金股利分配情况

公司 2023 年-2025 年的现金分红情况如下：

单位：万元

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
合并报表归属于母公司所有者的净利润	4,621.04	4,023.51	14,002.50
现金分红（含税）	924.22	482.89	1,680.52
当年现金分红占合并报表归属于母公司所有者的净利润的比例	20.00%	12.00%	12.00%
最近三年累计现金分配合计	3,087.63		
最近三年年均可分配利润	7,549.02		

项目	2025 年度	2024 年度	2023 年度
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例	40.90%		

公司最近三年以现金方式累计分配的利润共计 3,087.63 万元，占最近三年实现的年均可分配利润的 40.90%。

（三）现金分红的能力及影响因素

最近三年，公司实现营业收入分别为 972,850,306.19 元、1,003,220,024.79 元、1,252,687,576.17 元，归属于母公司所有者的净利润分别为 140,024,955.26 元、40,235,142.44 元、46,210,361.99 元。盈利能力增强将提升公司的现金分红能力，反之盈利能力减弱将削弱公司的现金分红能力。

公司基于实际经营情况及未来发展需要，依据《公司法》及《公司章程》，制定利润分配方案，影响公司现金分红的因素主要包括公司的收入规模、盈利情况、现金流状况、发展所处阶段、资本性支出需求、未来资金需求等。

（四）实际分红情况与公司章程及资本支出需求的匹配性

1、现金分红符合《公司章程》的规定

公司报告期内每一会计年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金充裕，实施现金分红不会影响公司的后续持续经营；公司现金分红金额达到《公司章程》要求的标准；由董事会在综合考虑、分析公司章程的规定、经营情况、现金流情况、公司发展战略、社会资金成本、外部融资环境、股东要求和意愿等因素的基础上，制定利润分配预案后，经公司董事会、股东会审议通过后实施，公司现金分红决策程序合规。

公司在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，符合《公司章程》的规定。

2、现金分红与资本支出需求的匹配性

公司本着重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾资金需求及可持续发展的利润分配原则，综合考量业务市场环境、内部能力提升、经营情况及盈利水平等，实施相关现金分红计划。现金分红与公司的资本支出需求相匹配。

综上，公司实际分红情况符合《公司章程》规定，与公司的资本支出需求较匹配。

（五）公司未来三年的分红规划

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司于2026年7月1日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《苏州东微半导体股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，并于2026年7月20日召开2026年第二次临时股东会审议通过了《苏州东微半导体股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

十七、最近三年公开发行的债券或者其他债务是否存在违约或延迟支付本息的情形

最近三年，公司未公开发行公司债券，不存在其他债务有违约或者延迟支付本息的情形。

十八、最近三年平均可分配利润是否足以支付各类债券一年的利息的情况

2023年度、2024年度及2025年度，公司归属于母公司所有者的净利润分别为14,002.50万元、4,023.51万元和4,621.04万元，最近三年实现的平均可分配利润为7,549.02万元。本次向不特定对象发行可转债募集资金按143,588.00万元计算，并参考近期可转换公司债券市场的发行利率水平，经合理估计：公司最近三年平均可分配利润足以支付可转换公司债券一年的利息。

十九、本次发行符合理性融资，合理确定融资规模

截至报告期末，公司不存在公开发行公司债及企业债的情形，亦不存在计入权益类科目的债券产品、非公开发行及在银行间市场发行的债券，以及具有资本补充属性的次级债、二级资本债，公司累计债券余额为0元。截至2026年6月末，公司所有者权益合计308,398.99万元，公司本次发行可转债拟募集资金总额不超过人民币143,588.00万元（含本数），占截至报告期末所有者权益的46.56%。本次发行完成后，公司累计债券余额不超过最近一期末净资产的百分之五十。

本次发行可转债募集资金到位后，在不考虑转股等其他因素影响的情况下，以截至报告期末的资产、负债计算，公司合并资产负债率将由8.53%上升至35.85%，仍处于

合理范围；随着可转债持有人在转股期内陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，可转债全部转股后资产负债率将下降至 5.98%。本次发行后公司仍具备合理的资产负债结构，本次发行不会对公司的资产负债率产生重大不利影响。

公司本次发行拟募集资金总额不超过人民币 143,588.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于与公司主业有关的“新型功率器件技术和产品研发及产业化项目”、“新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”等项目，符合公司的业务发展规划，融资规模具有合理性。

第五节 财务会计信息与管理层分析

本节的财务会计数据反映了公司最近三年及一期的财务状况，引用的财务会计数据，非经特别说明，均引自公司 2023 年度、2024 年度、2025 年度经审计的财务报告和 2026 年 1-6 月未经审计的财务报告，财务指标以上述财务报表为基础编制。

公司提醒投资者关注公司财务报告和审计报告全文，以获取更详尽的财务资料。

一、最近三年及一期财务报表审计情况

（一）审计情况

公司 2023 年度-2025 年度财务报告已经审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙) 审计，出具了致同审字（2026）第 332A034478 号标准无保留意见审计报告。

公司 2026 年 1-6 月财务数据未经审计。

（二）与财务会计信息相关的重要性水平的判断标准

公司根据自身业务特点和所处行业，从项目性质及金额两方面判断与财务会计信息相关的重大事项或重要性水平。在判断项目性质重要性时，公司主要考虑该项目的性质是否显著影响公司财务状况、经营成果和现金流量，是否会引起特别的风险。在判断项目金额大小的重要性时，综合考虑该项目金额占总资产、净资产、营业收入、净利润等项目金额比重情况。

以下财务数据若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

二、最近三年及一期财务报表

（一）合并资产负债表

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：				
货币资金	56,135.58	159,990.65	208,418.52	225,067.05
交易性金融资产	86,013.80	25,000.00	6,000.31	-
应收票据	571.47	4,842.25	9,992.67	342.72

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款	25,405.32	15,514.40	16,294.43	11,549.41
应收款项融资	3,244.76	2,002.26	1,591.12	1,770.80
预付款项	5,741.50	3,598.61	959.85	969.04
其他应收款	101.55	24.47	473.25	348.38
存货	68,442.21	54,789.84	36,060.22	34,035.05
一年内到期的非流动资产	-	-	-	1,439.16
其他流动资产	893.85	1,147.61	352.28	748.52
流动资产合计	246,550.03	266,910.09	280,142.66	276,270.14
非流动资产：				
长期股权投资	13,023.74	17,833.92	15,529.21	12,873.82
其他权益工具投资	4,250.00	-	-	-
其他非流动金融资产	9,325.48	2,677.02	1,500.00	1,500.00
固定资产	16,421.76	20,710.77	6,580.68	1,918.77
在建工程	6.19	118.41	1,891.46	-
使用权资产	728.63	500.39	1,308.49	346.58
无形资产	5,425.69	342.68	446.21	162.51
商誉	33,247.05	1,003.24	-	-
长期待摊费用	308.74	317.19	1,522.56	155.50
递延所得税资产	2,331.66	1,428.26	917.95	400.43
其他非流动资产	5,536.42	82.92	149.12	7,548.62
非流动资产合计	90,605.37	45,014.80	29,845.68	24,906.22
资产总计	337,155.40	311,924.89	309,988.33	301,176.35
流动负债：				
短期借款	3,502.43	4,002.72	476.03	3,002.18
应付账款	8,003.82	8,775.57	15,099.45	9,215.53
合同负债	156.37	52.26	302.06	136.81
应付职工薪酬	1,575.67	1,821.27	1,258.12	1,028.92
应交税费	182.29	51.16	25.44	17.02
其他应付款	9,948.87	1,083.00	45.60	88.58
一年内到期的非流动负债	350.99	190.73	654.22	228.15
其他流动负债	432.84	752.70	440.92	329.78
流动负债合计	24,153.28	16,729.40	18,301.84	14,046.96

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
非流动负债：				
租赁负债	349.53	302.46	786.51	102.54
长期应付款	2,393.42	-	-	-
递延收益	354.44	457.45	784.59	784.35
递延所得税负债	1,505.74	351.46	141.03	28.40
非流动负债合计	4,603.13	1,111.37	1,712.13	915.29
负债合计	28,756.41	17,840.77	20,013.96	14,962.26
股东权益：				
股本	12,257.50	12,257.50	12,253.14	9,432.69
资本公积	228,497.72	231,480.08	231,496.04	231,591.02
减：库存股	1,041.45	1,041.45	2,601.81	1,293.06
其他综合收益	5.96	7.22	8.07	7.51
盈余公积	5,729.26	5,729.26	5,118.78	4,716.35
未分配利润	56,933.78	47,227.82	43,700.16	41,759.59
归属于母公司所有者 权益合计	302,382.76	295,660.43	289,974.37	286,214.10
少数股东权益	6,016.23	-1,576.31	-	-
所有者权益合计	308,398.99	294,084.12	289,974.37	286,214.10
负债和股东权益总计	337,155.40	311,924.89	309,988.33	301,176.35

（二）合并利润表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	73,643.34	125,268.76	100,322.00	97,285.03
减：营业成本	60,829.61	104,935.34	85,982.32	75,170.26
税金及附加	135.60	107.53	60.83	125.78
销售费用	2,009.80	2,878.80	1,696.88	979.31
管理费用	3,230.43	5,415.30	3,539.79	2,359.76
研发费用	5,565.28	9,231.76	7,571.57	8,505.02
财务费用	25.43	-400.94	-1,322.81	-3,991.82
其中：利息费用	104.97	127.70	108.13	49.11
利息收入	99.56	545.21	1,460.17	4,045.63
加：其他收益	414.22	1,159.14	834.60	1,338.62

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
投资收益（损失以“-”号填列）	4,583.70	2,307.97	2,573.06	67.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,770.40	177.02	0.31	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-223.47	356.10	-682.90	344.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,159.91	-3,980.88	-2,209.57	-862.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.83	200.09	8.42	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,238.97	3,320.41	3,317.33	15,024.25
加：营业外收入	2.85	14.61	15.42	-
减：营业外支出	1.01	9.76	19.35	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,240.80	3,325.26	3,313.40	15,024.25
减：所得税费用	736.61	-55.50	-710.11	1,021.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,504.20	3,380.77	4,023.51	14,002.50
（一）按经营持续性分类：				
其中：持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,504.20	3,380.77	4,023.51	14,002.50
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-
（二）按所有权归属分类：				
其中：归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,630.18	4,621.04	4,023.51	14,002.50
少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-125.98	-1,240.27	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-1.35	-0.85	0.56	0.63
（一）归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-1.27	-0.85	0.56	0.63
1、不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
2、将重分类进损益的其他综合收益	-1.27	-0.85	0.56	0.63
（1）外币财务报表折算差额	-1.27	-0.85	0.56	0.63
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-0.08	-	-	-
六、综合收益总额	10,502.85	3,379.92	4,024.08	14,003.12
归属于母公司股东的综合收益总额	10,628.91	4,620.19	4,024.08	14,003.12

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
归属于少数股东的综合收益总额	-126.06	-1,240.27	-	-

（三）合并现金流量表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	65,414.17	124,557.83	82,786.04	106,740.92
收到的税费返还	-	1,440.48	990.19	847.22
收到其他与经营活动有关的现金	287.80	1,589.42	2,343.43	5,185.52
经营活动现金流入小计	65,701.97	127,587.73	86,119.66	112,773.67
购买商品、接受劳务支付的现金	71,132.19	134,924.44	86,333.22	92,533.73
支付给职工以及为职工支付的现金	5,712.46	9,036.04	5,490.93	4,514.49
支付的各项税费	155.53	431.44	367.01	4,342.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,632.19	2,368.73	2,759.82	4,328.48
经营活动现金流出小计	78,632.37	146,760.65	94,950.98	105,718.95
经营活动产生的现金流量净额	-12,930.39	-19,172.92	-8,831.32	7,054.72
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	429,578.21	1,036,010.57	632,428.95	178,093.30
取得投资收益收到的现金	908.62	2,523.11	2,643.41	1,138.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,327.30	99.90	21.07	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	4,767.16	-
投资活动现金流入小计	434,814.13	1,038,633.58	639,860.59	179,231.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,118.35	12,293.37	3,231.18	7,521.02
投资支付的现金	483,988.00	1,058,510.57	638,428.95	175,493.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,226.29	267.40	-	-
投资活动现金流出小计	522,332.64	1,071,071.33	641,660.13	183,014.32
投资活动产生的现金流量净额	-87,518.51	-32,437.75	-1,799.54	-3,782.75
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	94.76	-	-
取得借款收到的现金	1,000.00	4,997.18	476.03	3,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	946.68	-	-

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
筹资活动现金流入小计	1,000.00	6,038.62	476.03	3,000.00
偿还债务支付的现金	4,200.00	1,699.00	3,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74.28	551.17	1,738.04	9,975.20
支付其他与筹资活动有关的现金	131.51	604.80	1,728.37	1,643.39
筹资活动现金流出小计	4,405.78	2,854.97	6,466.41	11,618.59
筹资活动产生的现金流量净额	-3,405.78	3,183.65	-5,990.39	-8,618.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0.38	-0.85	-27.28	2.73
五、现金及现金等价物净增加额	-103,855.08	-48,427.87	-16,648.53	-5,343.89
加：期初现金及现金等价物余额	159,990.65	208,418.52	225,067.05	230,410.95
六、期末现金及现金等价物余额	56,135.58	159,990.65	208,418.52	225,067.05

三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况

（一）财务报表的编制基础

公司财务报表按照财政部发布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称：“企业会计准则”）编制。此外，公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》披露有关财务信息。公司财务报表以持续经营为基础列报。公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，公司财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（二）合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制，是指公司拥有对被投资单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。当相关事实和情况的变化导致对控制定义所涉及的相关要素发生变化时，公司将进行重新评估。

（三）合并财务报表范围及其变化情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

序号	子公司名称	取得方式
1	苏州电征科技有限公司	收购

序号	子公司名称	取得方式
2	香港赛普锐思有限公司	设立
3	深圳东能半导体有限公司	设立
4	苏州智启科技有限公司	设立
5	深圳慧能泰	收购
6	上海慧能泰	收购
7	香港慧能泰	收购
8	美国慧能泰	收购

最近三年及一期，公司合并财务报表范围主要变化情况如下：

1、2026 年 1-6 月公司合并范围的变化情况

公司以现金方式受让交易对方所持有的深圳慧能泰 53.0921%股权。交易完成后，公司直接持有深圳慧能泰 53.0921%的股权，深圳慧能泰成为公司的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

2、2025 年公司合并范围的变化情况

公司收购苏州电征科技有限公司 54.55%股权，并将其纳入合并范围。

公司新设全资子公司苏州智启科技有限公司，自成立之日起纳入合并范围。

3、2024 年公司合并范围的变化情况

公司注销子公司东能微科技创新投资（苏州）有限公司，该公司注销前尚未实际经营。

4、2023 年公司合并范围的变化情况

公司新设子公司东能微科技创新投资（苏州）有限公司，自成立之日起纳入合并范围。

四、最近三年及一期主要财务指标及非经常性损益明细表

（一）主要财务指标表

项目	2026 年 6 月 30 日 /2026 年 1-6 月	2025 年 12 月 31 日 /2025 年度	2024 年 12 月 31 日 /2024 年度	2023 年 12 月 31 日 /2023 年度
流动比率（倍）	10.21	15.95	15.31	19.67

项目	2026年6月30日 /2026年1-6月	2025年12月31日 /2025年度	2024年12月31日 /2024年度	2023年12月31日 /2023年度
速动比率（倍）	7.37	12.68	13.34	17.24
资产负债率（合并）	8.53%	5.72%	6.46%	4.97%
资产负债率（母公司）	6.30%	4.15%	6.46%	4.97%
应收账款周转率（次）	7.20	7.88	7.21	6.56
存货周转率（次）	1.97	2.31	2.45	2.92
归属于母公司所有者的每股净资产（元）	24.67	24.12	23.67	30.34
每股经营活动现金净流量（元）	-1.05	-1.56	-0.72	0.75
每股净现金流量（元）	-8.47	-3.95	-1.36	-0.57
归属于母公司所有者的净利润（万元）	10,630.18	4,621.04	4,023.51	14,002.50
研发费用占营业总收入的比重	7.56%	7.37%	7.55%	8.74%

注 1：上述指标除资产负债率（母公司）外均依据合并报表口径计算。

各指标的具体计算公式如下：

- 1、流动比率=流动资产/流动负债
- 2、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
- 3、资产负债率=总负债/总资产
- 4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均账面价值，2026 年 1-6 月应收账款周转率已经年化
- 5、存货周转率=营业成本/存货平均账面价值，2026 年 1-6 月存货周转率已经年化
- 6、归属于母公司所有者的每股净资产=期末归属于母公司所有者权益/期末股本总额
- 7、每股经营活动现金净流量=经营活动产生的现金流量净额/期末普通股股份总数
- 8、每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末普通股股份总数
- 9、研发费用占营业总收入的比重=各项研发费用合计/营业总收入

（二）公司最近三年及一期净资产收益率及每股收益

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2023]65 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
扣除非经常性损益前				
基本每股收益（元/股）	0.87	0.38	0.33	1.14
稀释每股收益（元/股）	0.86	0.38	0.33	1.14

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率	3.54%	1.58%	1.40%	4.92%
扣除非经常性损益后	基本每股收益（元/股）	0.01	0.06	0.02
	稀释每股收益（元/股）	0.01	0.06	0.02
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	0.02%	0.27%	0.08%	4.20%

（三）公司最近三年及一期非经常性损益明细表

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6.83	200.09	8.05	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	256.21	1,149.81	817.42	1,300.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,670.03	3,225.78	3,638.78	1,124.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.84	4.85	-3.56	-
非经常性损益总额	11,934.90	4,580.53	4,460.69	2,424.69
减：非经常性损益的所得税影响数	1,364.48	656.48	669.10	363.70
非经常性损益净额	10,570.42	3,924.06	3,791.58	2,060.98
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	9.16	92.73	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	10,561.26	3,831.33	3,791.58	2,060.98

五、会计政策变更、会计估计变更及重大会计差错更正

（一）会计政策变更

1、2023 年度

（1）企业会计准则解释第 16 号

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易按该规定进行调整。对在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。具体调整情况如下：

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备 注
2022 年 12 月 31 日资产负债表项目		
递延所得税负债	13,196.89	以抵销后净额列示
未分配利润	13,196.89	截至 2022 年末，盈余公积提取数已达注册资本的 50%
2022 年度利润表项目		
所得税费用	800.10	

（2）企业会计准则解释第 17 号

公司自 2023 年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于售后租回交易的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

2、2024 年度

（1）企业会计准则解释第 17 号

公司自 2024 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”的规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

（2）企业会计准则解释第 18 号

公司自 2024 年 12 月 6 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。

3、2025 年度

2025 年度，公司不存在重要会计政策变更。

4、2026 年 1-6 月

2026 年 1-6 月，公司不存在重要会计政策变更。

（二）会计估计变更

报告期内，公司无会计估计变更事项。

（三）会计差错更正

报告期内，公司无重大的会计差错更正事项。

六、财务状况分析

（一）资产情况

1、资产的构成及分析

截至报告期各期末，公司资产构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	246,550.03	73.13%	266,910.09	85.57%	280,142.66	90.37%	276,270.14	91.73%
非流动资产	90,605.37	26.87%	45,014.80	14.43%	29,845.68	9.63%	24,906.22	8.27%
资产总计	337,155.40	100.00%	311,924.89	100.00%	309,988.33	100.00%	301,176.35	100.00%

报告期各期末，公司资产总额分别为 301,176.35 万元、309,988.33 万元、311,924.89 万元和 337,155.40 万元，呈持续增长趋势。

报告期各期末，流动资产占资产总计的比例分别为 91.73%、90.37%、85.57%和 73.13%。报告期各期末公司流动资产占比整体保持在 70%以上水平，资产流动性较好。

2、流动资产的构成及分析

截至报告期各期末，公司流动资产构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	56,135.58	22.77%	159,990.65	59.94%	208,418.52	74.40%	225,067.05	81.47%
交易性金融资产	86,013.80	34.89%	25,000.00	9.37%	6,000.31	2.14%	-	-
应收票据	571.47	0.23%	4,842.25	1.81%	9,992.67	3.57%	342.72	0.12%
应收款项融资	3,244.76	1.32%	2,002.26	0.75%	1,591.12	0.57%	1,770.80	0.64%
应收账款	25,405.32	10.30%	15,514.40	5.81%	16,294.43	5.82%	11,549.41	4.18%
预付款项	5,741.50	2.33%	3,598.61	1.35%	959.85	0.34%	969.04	0.35%
其他应收款	101.55	0.04%	24.47	0.01%	473.25	0.17%	348.38	0.13%
存货	68,442.21	27.76%	54,789.84	20.53%	36,060.22	12.87%	34,035.05	12.32%
一年内到期的非流动资产	-	-	-	-	-	-	1,439.16	0.52%
其他流动资产	893.85	0.36%	1,147.61	0.43%	352.28	0.13%	748.52	0.27%
流动资产合计	246,550.03	100.00%	266,910.09	100.00%	280,142.66	100.00%	276,270.14	100.00%

报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收账款和存货构成。报告期各期末，公司流动资产分别为 276,270.14 万元、280,142.66 万元、266,910.09 万元和 246,550.03 万元。

报告期各期末，公司主要流动资产科目的变动情况及原因如下：

（1）货币资金

截至报告期各期末，公司货币资金的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
银行存款	50,897.34	137,507.79	149,579.82	215,956.53
其他货币资金	5,238.23	22,439.82	58,838.70	9,110.52
数字货币	-	43.04	-	-
合计	56,135.58	159,990.65	208,418.52	225,067.05

公司货币资金主要为银行存款。截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司货币资金余额分别为 225,067.05 万元、208,418.52 万元、159,990.65 万元及 56,135.58 万元，占流动资产的比例分别为 81.47%、74.40%、59.94%及 22.77%。公司其他货币资金主要为购买的理财产品赎回后，各期末留存在证券账户中的活期资金。报告期内，公司货币资金呈下降趋势，主要系公司以现金方式受让交易对方所持有的深圳慧能泰股权、利用暂时闲置资金进行现金管理购买理财产品增加所致。

（2）交易性金融资产

截至报告期各期末，公司交易性金融资产的具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	86,013.80	100.00%	25,000.00	100.00%	6,000.31	100.00%	-	-
其中：理财产品	86,013.80	100.00%	25,000.00	100.00%	6,000.31	100.00%	-	-
合计	86,013.80	100.00%	25,000.00	100.00%	6,000.31	100.00%	-	-

公司交易性金融资产为理财产品。截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司交易性金融资产余额分别为 0.00 万元、6,000.31 万元、25,000.00 万元及 86,013.80 万元，占流动资产的比例分别为 0.00%、2.14%、9.37%及 34.89%。公司交易性金融资产主要为公司利用暂时闲置资金进行现金管理购买的流动性较好、风险较低的理财产品。

（3）应收账款

1) 应收账款构成及变动情况

截至报告期各期末，公司应收账款具体情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面余额	26,837.21	16,330.95	17,152.04	12,157.27
坏账准备	1,431.89	816.55	857.60	607.86

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
应收账款账面价值	25,405.32	15,514.40	16,294.43	11,549.41
营业收入	73,643.34	125,268.76	100,322.00	97,285.03
应收账款账面价值/ 营业收入（年化）	17.25%	12.38%	16.24%	11.87%

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司应收账款账面价值分别为 11,549.41 万元、16,294.43 万元、15,514.40 万元和 25,405.32 万元，占流动资产的比例分别为 4.18%、5.82%、5.81%及 10.30%。

报告期内，公司应收账款账龄较短，回款较为及时，应收账款账面价值主要随公司四季度收入变化而变动。2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司应收账款账面价值占当年第四季度营业收入的比重分别为 56.93%、50.49%和 53.67%，整体保持稳定。2026 年 6 月末，公司应收账款较 2025 年末增长 9,890.91 万元，增幅为 63.75%，主要系公司收购深圳慧能泰业务规模扩大，应收账款增加。

2) 应收账款账龄分析

截至报告期各期末，公司应收账款余额账龄分布情况如下：

单位：万元

账龄	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1 年以内	26,734.02	99.62%	16,330.95	100.00%	17,152.04	100.00%	12,157.27	100.00%
1 至 2 年	26.16	0.10%	-	-	-	-	-	-
2 至 3 年	77.03	0.29%	-	-	-	-	-	-
应收账款账面余额	26,837.21	100.00%	16,330.95	100.00%	17,152.04	100.00%	12,157.27	100.00%
减：坏账准备	1,431.89	5.34%	816.55	5.00%	857.60	5.00%	607.86	5.00%
应收账款账面价值	25,405.32	94.66%	15,514.40	95.00%	16,294.43	95.00%	11,549.41	95.00%

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司 1 年以内的应收账款余额占比分别为 100.00%、100.00%、100.00%和 99.62%。从账龄上看，报告期各期末，公司 1 年以内应收账款为主要组成部分。报告期内应收账款回款情况良好，未发生重大坏账情况。

3) 应收账款按坏账计提方法分类情况

截至报告期各期末，公司应收账款余额分类情况如下表所示：

单位：万元

类别	2026 年 6 月 30 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按单项计提坏账准备	93.19	0.35	93.19	100.00	-
按组合计提坏账准备	26,744.02	99.65	1,338.70	5.01	25,405.32
合计	26,837.21	100.00	1,431.89	5.34	25,405.32
类别	2025 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	16,330.95	100.00	816.55	5.00	15,514.40
合计	16,330.95	100.00	816.55	5.00	15,514.40
类别	2024 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	17,152.04	100.00	857.60	5.00	16,294.43
合计	17,152.04	100.00	857.60	5.00	16,294.43
类别	2023 年 12 月 31 日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	预期信用损失率(%)	
按组合计提坏账准备	12,157.27	100.00	607.86	5.00	11,549.41
合计	12,157.27	100.00	607.86	5.00	11,549.41

截至 2023 年末、2024 年末及 2025 年末，公司应收账款全部为按组合计提坏账准备。2026 年 6 月末，公司按组合计提坏账准备的应收账款占比为 99.65%，按单项计提坏账准备的应收账款情况如下：

单位：万元

名称	2026 年 6 月 30 日			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率（%）	计提依据
深圳市鼎速科技有限公司	77.03	77.03	100.00	预计无法收回
深圳市博巨兴微电子科技有限公司	10.88	10.88	100.00	预计无法收回
深圳市鼎芯未来科技有限公司	5.28	5.28	100.00	预计无法收回
合计	93.19	93.19	100.00	-

4) 公司应收账款前五大情况

截至报告期各期末，公司应收账款余额前五名的情况如下：

单位：万元、%

2026 年 6 月 30 日			
单位名称	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海贵秦电子有限公司	4,917.08	18.32	245.85
客户 A	3,770.43	14.05	188.52
上海蓝伯科电子科技有限公司	2,686.38	10.01	134.32
深圳麦米电气供应链管理有限公司	2,574.13	9.59	128.71
东莞市众麦祥电子科技有限公司	1,797.49	6.70	89.87
合计	15,745.51	58.67	787.28
2025 年 12 月 31 日			
单位名称	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
上海贵秦电子有限公司	2,900.57	17.76	145.03
客户 A	1,896.39	11.61	94.82
深圳麦米电气供应链管理有限公司	1,852.79	11.35	92.64
上海蓝伯科电子科技有限公司	1,614.46	9.89	80.72
深圳市任创天其科技有限公司	1,068.12	6.54	53.41
合计	9,332.33	57.15	466.62
2024 年 12 月 31 日			
单位名称	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
长沙市比亚迪汽车有限公司	1,806.13	10.53	90.31
上海贵秦电子有限公司	1,793.42	10.46	89.67

株洲麦格米特电气有限责任公司	1,420.97	8.28	71.05
上海蓝伯科电子科技有限公司	1,399.78	8.16	69.99
上海云创电气设备有限公司	1,339.09	7.81	66.95
合计	7,759.39	45.24	387.97
2023 年 12 月 31 日			
单位名称	应收账款余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 A	3,025.46	24.89	151.27
上海贵秦电子有限公司	1,238.95	10.19	61.95
株洲麦格米特电气有限责任公司	1,186.14	9.76	59.31
深圳市凯新达电子有限公司	1,021.98	8.41	51.10
上海云创电气设备有限公司	763.52	6.28	38.18
合计	7,236.05	59.53	361.80

5）与同行业公司相比应收账款坏账计提方法及比例

截至报告期各期末，公司应收账款坏账计提比例（预期信用损失率）与可比上市公司的对比情况如下：

公司名称	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
华润微	0.06%	0.06%	0.24%	0.40%
宏微科技	5.16%	5.16%	5.16%	5.05%
新洁能	5.58%	5.48%	5.38%	5.53%
士兰微	6.20%	6.42%	6.10%	5.66%
南芯科技	1.13%	1.09%	1.00%	1.00%
平均值	3.63%	3.64%	3.58%	3.53%
公司	5.34%	5.00%	5.00%	5.00%

注 1：应收账款坏账计提比例=坏账准备/应收账款账面余额；

注 2：数据源自各公司定期报告、同花顺 iFind；

如上表所示，公司应收账款坏账计提比例高于同行业可比公司平均值，应收账款坏账计提比例处于合理水平。

（4）存货

截至报告期各期末，公司存货的明细情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	34,625.70	45.72%	30,841.13	51.07%	17,322.14	44.76%	21,047.65	59.97%
库存商品	22,387.77	29.56%	22,136.26	36.65%	12,919.85	33.38%	8,708.03	24.81%
发出商品	641.36	0.85%	35.43	0.06%	11.28	0.03%	16.71	0.05%
委托加工物资	18,081.00	23.87%	7,379.39	12.22%	8,448.67	21.83%	5,325.86	15.17%
余额合计	75,735.83	100.00%	60,392.21	100.00%	38,701.95	100.00%	35,098.26	100.00%
减：跌价准备	7,293.62	9.63%	5,602.37	9.28%	2,641.72	6.83%	1,063.21	3.03%
账面价值	68,442.21	90.37%	54,789.84	90.72%	36,060.22	93.17%	34,035.05	96.97%

公司的存货主要为原材料、库存商品、发出商品和委托加工物资等。截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司存货账面价值分别为 34,035.05 万元、36,060.22 万元、54,789.84 万元和 68,442.21 万元，占流动资产的比重分别为 12.32%、12.87%、20.53%及 27.76%。2024 年末，公司存货账面价值较 2023 年末增加 2,025.18 万元，同比增加 5.95%，整体保持稳定。2025 年末，公司存货账面价值较 2024 年末增加 18,729.62 万元，同比增幅为 51.94%，主要系公司经营规模持续扩大，为保障客户持续需求增加备货，期末结存的原材料和发出商品增加所致。2026 年 6 月末，公司存货账面价值较 2025 年末增加 13,652.37 万元，增幅为 24.92%，除经营规模扩大外，公司收购深圳慧能泰，带来逾 4,000 万元的存货增加。

报告期各期末，公司存货余额及其跌价准备计提情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	34,625.70	3,555.90	31,069.81
库存商品	22,387.77	3,737.73	18,650.04
发出商品	641.36	-	641.36
委托加工物资	18,081.00	-	18,081.00
合计	75,735.83	7,293.62	68,442.21
项目	2025 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,841.13	2,933.95	27,907.18

库存商品	22,136.26	2,668.42	19,467.84
发出商品	35.43	-	35.43
委托加工物资	7,379.39	-	7,379.39
合计	60,392.21	5,602.37	54,789.84
项目	2024 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,322.14	1,711.74	15,610.41
库存商品	12,919.85	929.99	11,989.86
发出商品	11.28	-	11.28
委托加工物资	8,448.67	-	8,448.67
合计	38,701.95	2,641.72	36,060.22
项目	2023 年 12 月 31 日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	21,047.65	414.75	20,632.90
库存商品	8,708.03	648.46	8,059.57
发出商品	16.71	-	16.71
委托加工物资	5,325.86	-	5,325.86
合计	35,098.26	1,063.21	34,035.05

3、非流动资产的构成及分析

截至报告期各期末，公司非流动资产构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期股权投资	13,023.74	14.37%	17,833.92	39.62%	15,529.21	52.03%	12,873.82	51.69%
其他权益工具投资	4,250.00	4.69%	-	-	-	-	-	-
其他非流动金融资产	9,325.48	10.29%	2,677.02	5.95%	1,500.00	5.03%	1,500.00	6.02%
固定资产	16,421.76	18.12%	20,710.77	46.01%	6,580.68	22.05%	1,918.77	7.70%
在建工程	6.19	0.01%	118.41	0.26%	1,891.46	6.34%	-	-
使用权资产	728.63	0.80%	500.39	1.11%	1,308.49	4.38%	346.58	1.39%
无形资产	5,425.69	5.99%	342.68	0.76%	446.21	1.50%	162.51	0.65%
商誉	33,247.05	36.69%	1,003.24	2.23%	-	-	-	-

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期待摊费用	308.74	0.34%	317.19	0.70%	1,522.56	5.10%	155.50	0.62%
递延所得税资产	2,331.66	2.57%	1,428.26	3.17%	917.95	3.08%	400.43	1.61%
其他非流动资产	5,536.42	6.11%	82.92	0.18%	149.12	0.50%	7,548.62	30.31%
非流动资产合计	90,605.37	100.00%	45,014.80	100.00%	29,845.68	100.00%	24,906.22	100.00%

报告期各期末，公司非流动资产主要由长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、固定资产、无形资产、商誉、其他非流动资产等构成。报告期各期末，公司非流动资产分别为 24,906.22 万元、29,845.68 万元、45,014.80 万元和 90,605.37 万元，呈持续上升趋势。

报告期各期末，公司主要非流动资产科目的变动情况及原因如下：

（1）长期股权投资

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司长期股权投资分别为 12,873.82 万元、15,529.21 万元、17,833.92 万元和 13,023.74 万元，占非流动资产的比例分别为 51.69%、52.03%、39.62%和 14.37%。报告期各期末，公司长期股权投资具体情况如下：

单位：万元

被投资单位	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
苏州工业园区苏纳微创新创业投资合伙企业（有限合伙）	8,107.08	62.25%	7,289.42	40.87%	6,822.14	43.93%	5,891.58	45.76%
苏州工业园区智源微创新创业投资合伙企业（有限合伙）	4,916.66	37.75%	2,464.87	13.82%	-	-	-	-
苏州德信芯片科技有限公司	-	-	8,079.62	45.30%	8,707.07	56.07%	6,982.24	54.24%
合计	13,023.74	100.00%	17,833.92	100.00%	15,529.21	100.00%	12,873.82	100.00%

（2）其他权益工具投资

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司其他权益工具投资账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 4,250.00 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、0.00%及 4.69%。

报告期各期末，公司其他权益工具投资情况如下：

单位：万元

被投资单位	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
苏州德信芯片科技有限公司	4,000.00	94.12%	-	-	-	-	-	-
厦门钧胜广源半导体有限公司	250.00	5.88%	-	-	-	-	-	-
合计	4,250.00	100.00%	-	-	-	-	-	-

上述投资为公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于其他权益工具投资科目列报。

（3）其他非流动金融资产

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司其他非流动金融资产账面价值分别为 1,500.00 万元、1,500.00 万元、2,677.02 万元和 9,325.48 万元，占非流动资产的比例分别为 6.02%、5.03%、5.95%及 10.29%。

报告期各期末，公司其他非流动金融资产情况如下：

单位：万元

被投资单位	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
苏州永鑫融耀创业投资合伙企业（有限合伙）	8,325.48	89.28%	1,677.02	62.65%	1,500.00	100.00%	1,500.00	100.00%
苏州登临科技股份有限公司	1,000.00	10.72%	1,000.00	37.35%	-	-	-	-

被投资单位	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	9,325.48	100.00%	2,677.02	100.00%	1,500.00	100.00%	1,500.00	100.00%

公司其他非流动金融资产均为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，为对苏州永鑫融耀创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州登临科技股份有限公司的投资。

（4）固定资产

截至报告期各期末，公司固定资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	21,497.04	24,116.75	8,333.86	2,914.76
其中：房屋及建筑物	11,435.73	11,380.23	-	
通用设备	897.70	599.45	375.16	287.22
专用设备	8,842.64	11,816.09	7,646.90	2,335.82
运输工具	320.98	320.98	311.81	291.72
二、累计折旧合计：	5,075.29	3,405.97	1,753.19	996.00
其中：房屋及建筑物	937.43	390.39	-	
通用设备	630.62	350.85	260.01	202.58
专用设备	3,277.46	2,455.45	1,324.19	639.28
运输工具	229.78	209.28	168.99	154.14
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
通用设备	-	-	-	-
专用设备	-	-	-	-
运输工具	-	-	-	-
四、账面价值合计	16,421.76	20,710.77	6,580.68	1,918.77
其中：房屋及建筑物	10,498.30	10,989.84	-	
通用设备	267.08	248.60	115.15	84.65
专用设备	5,565.18	9,360.64	6,322.71	1,696.53
运输工具	91.20	111.70	142.82	137.59

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司固定资产的账面价值分别为 1,918.77 万元、6,580.68 万元、20,710.77 万元和 16,421.76 万元，占非流动资产的比例分别为 7.70%、22.05%、46.01%和 18.12%。公司固定资产由房屋及建筑物、通用设备、专用设备和运输工具等组成，其中，房屋及建筑物和专用设备占比较高。

2024 年末，公司固定资产账面价值较 2023 年末增加 4,661.91 万元，同比增加 242.96%，主要为新增购置专用设备所致。2025 年末，公司固定资产账面价值较 2024 年末增加 14,130.09 万元，同比增加 214.72%，主要为 IPO 募投项目中研发工程中心建设项目新增购置房屋所致。2026 年 6 月末，公司固定资产账面价值较 2025 年末减少 4,289.01 万元，降幅 20.71%，主要为处置专用设备所致。

报告期各期末，公司固定资产状况良好，不存在减值迹象，未计提减值准备；截至 2026 年 6 月末，公司无重大闲置或待处置的固定资产。

发行人固定资产折旧年限与同行业可比公司的比较情况如下：

公司名称	房屋建筑物	通用设备/电子设备	专用设备/机器设备	运输设备
华润微	25 年	3-5 年	8 年	5 年
宏微科技	10-30 年	3-5 年	10 年	5 年
新洁能	20 年	3 年	10 年	4 年
士兰微	30-35 年	5-10 年	5-10 年	5-8 年
南芯科技	35 年	3-5 年	10 年	3-5 年
公司	5-20 年	3 年	3-10 年	5 年

由上表可见，公司的固定资产折旧年限与可比上市公司的折旧年限较为类似，处于合理水平。

（5）无形资产

截至报告期各期末，公司无形资产具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
一、账面原值合计：	6,381.91	743.36	726.29	368.04
其中：土地使用权	1,021.76	-	-	-
软件	1,047.82	743.36	726.29	368.04

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
专利技术	3,412.33	-	-	-
商标	900.00	-	-	-
二、累计摊销合计：	956.22	400.68	280.08	205.53
其中：土地使用权	8.51	-	-	-
软件	612.87	400.68	280.08	205.53
专利技术	267.33	-	-	-
商标	67.50	-	-	-
三、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地使用权	-	-	-	-
软件	-	-	-	-
专利技术	-	-	-	-
商标	-	-	-	-
四、账面价值合计	5,425.69	342.68	446.21	162.51
其中：土地使用权	1,013.25	-	-	-
软件	434.95	342.68	446.21	162.51
专利技术	3,145.00	-	-	-
商标	832.50	-	-	-

公司无形资产由土地使用权、软件、专利技术和商标组成。截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司无形资产账面价值分别为 162.51 万元、446.21 万元、342.68 万元和 5,425.69 万元，占非流动资产的比例分别为 0.65%、1.50%、0.76% 和 5.99%。2023 年末、2024 年末和 2025 年末，公司无形资产规模较小。2026 年 6 月末，公司无形资产账面价值较 2025 年末增长 5,083.01 万元，增幅为 1,483.31%，主要系公司购置土地，同时收购深圳慧能泰，合并报表层面确认专利、商标等无形资产所致。

截至 2026 年 6 月末，公司无形资产的情况参见“第四节 发行人基本情况”之“十二、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（二）主要无形资产”。

（6）商誉

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司商誉账面价值分别为 0.00 万元、0.00 万元、1,003.24 万元和 33,247.05 万元，占非流动资产的比例分别为 0.00%、0.00%、2.23%和 36.69%。

2025 年度商誉系公司收购电征科技公司股权时形成；2026 年 6 月末，公司商誉较 2025 年末增加 32,243.81 万元，增幅为 3,213.97%，主要系公司收购深圳慧能泰股权形成新增商誉所致，具体情况如下：

单位：万元

被投资单位名称或形成商誉的事项	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
电征科技公司	1,003.24	3.02%	1,003.24	100.00%	-	-	-	-
深圳慧能泰	32,243.81	96.98%	-	-	-	-	-	-
合计	33,247.05	100.00%	1,003.24	100.00%	-	-	-	-

（7）其他非流动资产

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司其他非流动资产分别为 7,548.62 万元、149.12 万元、82.92 万元和 5,536.42 万元，占非流动资产的比例分别为 30.31%、0.50%、0.18%和 6.11%。报告期各期末，公司其他非流动资产主要为预付长期资产款。

（二）负债情况

1、负债的构成及分析

截至报告期各期末，公司负债的构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债	24,153.28	83.99%	16,729.40	93.77%	18,301.84	91.45%	14,046.96	93.88%
非流动负债	4,603.13	16.01%	1,111.37	6.23%	1,712.13	8.55%	915.29	6.12%
负债总计	28,756.41	100.00%	17,840.77	100.00%	20,013.96	100.00%	14,962.26	100.00%

报告期各期末，公司负债总额分别为 14,962.26 万元、20,013.96 万元、17,840.77 万元和 28,756.41 万元。报告期内，公司负债总额整体较小。

2、流动负债的构成及分析

报告期各期末，公司流动负债构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	3,502.43	14.50%	4,002.72	23.93%	476.03	2.60%	3,002.18	21.37%
应付账款	8,003.82	33.14%	8,775.57	52.46%	15,099.45	82.50%	9,215.53	65.61%
合同负债	156.37	0.65%	52.26	0.31%	302.06	1.65%	136.81	0.97%
应付职工薪酬	1,575.67	6.52%	1,821.27	10.89%	1,258.12	6.87%	1,028.92	7.32%
应交税费	182.29	0.75%	51.16	0.31%	25.44	0.14%	17.02	0.12%
其他应付款	9,948.87	41.19%	1,083.00	6.47%	45.60	0.25%	88.58	0.63%
一年内到期的非流动负债	350.99	1.45%	190.73	1.14%	654.22	3.57%	228.15	1.62%
其他流动负债	432.84	1.79%	752.70	4.50%	440.92	2.41%	329.78	2.35%
流动负债合计	24,153.28	100.00%	16,729.40	100.00%	18,301.84	100.00%	14,046.96	100.00%

报告期各期末，公司流动负债分别为 14,046.96 万元、18,301.84 万元、16,729.40 万元和 24,153.28 万元，主要由短期借款、应付账款、应付职工薪酬、其他应付款等构成。报告期内，公司流动负债总体呈波动态势，主要系随着公司业务规模和经营情况变化，公司短期借款和经营性流动负债金额变化所致。

报告期各期末，公司主要流动负债科目的变动情况及原因如下：

（1）短期借款

截至报告期各期末，公司短期借款具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
信用借款	2,001.11	4,002.72	-	3,002.18
保证借款	800.56	-	-	-
质押借款	700.76	-	-	-
信用证议付借款	-	-	476.03	-
合计	3,502.43	4,002.72	476.03	3,002.18

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司短期借款分别为 3,002.18 万元、476.03 万元、4,002.72 万元和 3,502.43 万元，占流动负债的比例分别为

21.37%、2.60%、23.93%和 14.50%。2024 年末，公司短期借款较 2023 年末同比减少 2,526.15 万元，降幅 84.14%，主要系公司归还为了配套政府科技项目新增的银行短期贷款所致。2025 年末，公司短期借款较 2024 年末同比增加 3,526.70 万元，增幅 740.86%，主要系基于经营发展需要，取得银行短期经营性贷款有所增加所致。2026 年 6 月末，公司短期借款较 2025 年末减少 500.30 万元，降幅为 12.50%，主要系偿还信用借款所致。

（2）应付账款

截至报告期各期末，公司应付账款具体情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
货款	7,706.30	7,397.73	13,235.12	9,123.14
资产款	172.09	977.32	1,634.15	1.91
费用款	125.43	400.51	230.17	90.48
合计	8,003.82	8,775.57	15,099.45	9,215.53

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司应付账款分别为 9,215.53 万元、15,099.45 万元、8,775.57 万元和 8,003.82 万元，应付账款占流动负债的比例分别为 65.61%、82.50%、52.46%和 33.14%。报告期内，公司应付账款余额随着公司业务发展和生产经营实际情况而波动。公司 2024 年末应付账款同比增加 5,883.92 万元，增幅为 63.85%，主要系随着公司采购规模扩大，报告期末公司应付货款增加所致。公司 2025 年末应付账款同比减少 6,323.88 万元，降幅为 41.88%，主要系公司期末应付的供应商货款有所减少所致。2026 年 6 月末，公司应付账款较 2025 年末减少 771.75 万元，降幅为 8.79%，主要系应付资产款和费用款减少所致。

（3）应付职工薪酬

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司应付职工薪酬余额分别为 1,028.92 万元、1,258.12 万元、1,821.27 万元和 1,575.67 万元，占流动负债的比例分别为 7.32%、6.87%、10.89%和 6.52%。

报告期各期末，公司应付职工薪酬情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期薪酬	1,481.18	94.00%	1,628.44	89.41%	1,250.29	99.38%	1,024.50	99.57%
离职后福利-设定提存计划	94.50	6.00%	7.82	0.43%	7.83	0.62%	4.42	0.43%
辞退福利	-	-	185.00	10.16%	-	-	-	-
合计	1,575.67	100.00%	1,821.27	100.00%	1,258.12	100.00%	1,028.92	100.00%

公司 2024 年应付职工薪酬同比增加 229.20 万元，增幅为 22.28%，公司 2025 年末应付职工薪酬较 2024 年末增加 563.15 万元，增幅为 44.76%，主要系公司员工人数扩充及人均薪酬增加所致。

（4）其他应付款

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司其他应付款分别为 88.58 万元、45.60 万元、1,083.00 万元和 9,948.87 万元，占流动负债的比例分别为 0.63%、0.25%、6.47%和 41.19%。公司其他应付款情况如下：

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
应付股权收购款	7,940.83	79.82%	-	-	-	-	-	-
限制性股票回购义务	1,041.45	10.47%	1,041.45	96.16%	-	-	-	-
应付股利	921.16	9.26%	-	-	-	-	-	-
应付暂收款	45.43	0.46%	41.55	3.84%	45.60	100.00%	88.58	100.00%
合计	9,948.87	100.00%	1,083.00	100.00%	45.60	100.00%	88.58	100.00%

2025 年末，公司其他应付款同比增加 1,037.40 万元，增幅为 2,275.04%，主要系新增限制性股票回购义务所致。2026 年 6 月末，公司其他应付款较 2025 年末增加 8,865.87 万元，增幅为 818.64%，主要系新增应付的深圳慧能泰股权收购款所致。

3、非流动负债的构成及分析

截至报告期各期末，公司非流动负债构成及变化情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
租赁负债	349.53	7.59%	302.46	27.22%	786.51	45.94%	102.54	11.20%
长期应付款	2,393.42	52.00%	-	-	-	-	-	-
递延收益	354.44	7.70%	457.45	41.16%	784.59	45.83%	784.35	85.69%
递延所得税 负债	1,505.74	32.71%	351.46	31.62%	141.03	8.24%	28.40	3.10%
非流动负债 合计	4,603.13	100.00%	1,111.37	100.00%	1,712.13	100.00%	915.29	100.00%

报告期各期末，公司非流动负债分别为 915.29 万元、1,712.13 万元、1,111.37 万元和 4,603.13 万元，主要由租赁负债、长期应付款、递延收益和递延所得税负债构成。

报告期各期末，公司主要非流动负债科目的变动情况及原因如下：

（1）租赁负债

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司租赁负债分别为 102.54 万元、786.51 万元、302.46 万元、349.53 万元，占非流动负债的比例分别为 11.20%、45.94%、27.22%和 7.59%。公司租赁负债主要由租赁房屋产生，房屋租赁情况参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十二、公司主要固定资产、无形资产情况”之“（一）主要固定资产”之“3、房屋租赁情况”。

（2）长期应付款

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司长期应付款分别为 0.00 万元、0.00 万元、0.00 万元和 2,393.42 万元。2026 年 6 月末，公司长期应付款主要为子公司股权回购款。

（3）递延收益

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司递延收益分别为 784.35 万元、784.59 万元、457.45 万元和 354.44 万元，占非流动负债的比例分别为 85.69%、45.83%、41.16%和 7.70%。报告期各期末，公司递延收益主要为政府补助。

（4）递延所得税负债

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司递延所得税负债分别为 28.40 万元、141.03 万元、351.46 万元和 1,505.74 万元，占非流动负债的比例分别为 3.10%、8.24%、31.62%和 32.71%。公司递延所得税负债主要由投资合伙企业损益调整、内部交易未实现利润、使用权资产、折旧差异、公允价值变动等原因产生。

（三）偿债能力分析

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率（倍）	10.21	15.95	15.31	19.67
速动比率（倍）	7.37	12.68	13.34	17.24
资产负债率（合并）	8.53%	5.72%	6.46%	4.97%
资产负债率（母公司）	6.30%	4.15%	6.46%	4.97%

注：各指标计算口径如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产－存货）/流动负债
资产负债率=总负债/总资产

1、偿债能力分析

截至 2023 年末、2024 年末、2025 年末及 2026 年 6 月末，公司流动比率分别为 19.67 倍、15.31 倍、15.95 倍和 10.21 倍，速动比率分别为 17.24 倍、13.34 倍、12.68 倍和 7.37 倍，合并报表层面资产负债率分别为 4.97%、6.46%、5.72%和 8.53%。报告期内，公司流动比率、速动比率较高，资产负债率较低，整体流动性较好。

2、偿债能力对比分析

报告期各期末，公司与可比上市公司的偿债能力指标比较情况如下：

项目		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动比率 （倍）	华润微	3.18	2.95	3.23	3.77
	宏微科技	1.45	1.42	1.40	1.60
	新洁能	8.10	10.49	9.20	6.53
	士兰微	1.83	1.92	1.86	2.39
	南芯科技	6.06	4.49	5.96	5.44
	可比公司平均值	4.12	4.25	4.33	3.95
	公司	10.21	15.95	15.31	19.67
速动比率 （倍）	华润微	2.73	2.50	2.72	3.31
	宏微科技	1.14	1.04	0.96	1.05

	新洁能	7.37	9.69	8.41	5.71
	士兰微	1.33	1.40	1.32	1.73
	南芯科技	4.72	3.42	5.07	4.74
	可比公司平均值	3.46	3.61	3.70	3.31
	公司	7.37	12.68	13.34	17.24
资产负债率 (合并)	华润微	18.14%	18.71%	16.53%	19.12%
	宏微科技	60.63%	59.01%	58.58%	54.09%
	新洁能	11.58%	9.56%	10.34%	14.03%
	士兰微	53.28%	52.10%	44.25%	43.87%
	南芯科技	38.86%	20.31%	15.32%	17.10%
	可比公司平均值	36.50%	31.94%	29.00%	29.64%
	公司	8.53%	5.72%	6.46%	4.97%

注：数据源自各公司定期报告、同花顺 iFind。

报告期各期末，公司的流动比率和速动比率高于同行业可比上市公司平均水平，公司的资产负债率低于同行业可比上市公司平均水平，公司偿债能力较强。

（四）资产周转能力分析

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款周转率（次）	7.20	7.88	7.21	6.56
存货周转率（次）	1.97	2.31	2.45	2.92

注：各指标计算口径如下：

应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均账面价值，2026 年 1-6 月应收账款周转率已经年化

存货周转率 = 营业成本 / 存货平均账面价值，2026 年 1-6 月存货周转率已经年化

1、资产周转能力分析

2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月，公司应收账款周转率分别为 6.56 次/年、7.21 次/年、7.88 次/年和 7.20 次/年。报告期内，公司应收账款整体回款良好。

2023 年度、2024 年度、2025 年度和 2026 年 1-6 月，公司存货周转率分别为 2.92 次/年、2.45 次/年、2.31 次/年和 1.97 次/年。报告期内，公司存货周转率整体呈下降趋势，主要系公司经营规模持续扩大，为保障客户持续需求增加备货，期末结存的存货产品增加所致。

2、资产周转能力对比分析

报告期各期内，公司与可比上市公司的资产周转能力指标比较情况如下：

项目		2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
应收账款 周转率 (次/年)	华润微	6.72	6.70	7.34	8.51
	宏微科技	2.85	2.74	2.87	4.00
	新洁能	8.88	6.95	8.05	9.15
	士兰微	4.19	4.33	4.34	4.28
	南芯科技	6.41	10.20	12.61	11.55
	可比公司平均值	5.81	6.18	7.04	7.50
	公司	7.20	7.88	7.21	6.56
存货周 转率(次/年)	华润微	3.93	3.72	3.63	3.49
	宏微科技	3.43	2.78	2.60	3.39
	新洁能	4.84	4.10	3.04	2.28
	士兰微	3.08	2.72	2.38	2.14
	南芯科技	1.94	2.57	2.70	2.39
	可比公司平均值	3.44	3.18	2.87	2.74
	公司	1.97	2.31	2.45	2.92

注：数据源自各公司定期报告、同花顺 iFind。

应收账款周转率方面，公司应收账款周转率整体呈增长趋势，2024 年以来高于同行业可比上市公司平均值，公司应收账款周转情况较好。

存货周转率方面，报告期内，公司的存货周转率呈下降趋势，主要系随着公司业务的开拓和下游市场需求的提升，为保障客户持续需求增加备货，期末结存的存货产品增加所致。

（五）财务性投资

1、最近一期末公司持有财务性投资明细、持有原因及未来处置计划

根据《上市公司证券发行注册管理办法》，上市公司向不特定对象发行可转债的：“除金融类企业外，最近一期末不存在金额较大的财务性投资”，“除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。”

根据中国证监会《证券期货法律适用意见第 18 号》，对财务性投资说明如下：

“（一）财务性投资包括但不限于：投资类金融业务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未增加的对集团财务公司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投资产业基金、并购基金；拆借资金；委托贷款；购买收益波动大且风险较高的金融产品等。

（二）围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并购投资，以拓展客户、渠道为目的的拆借资金、委托贷款，如符合公司主营业务及战略发展方向，不界定为财务性投资。

（三）上市公司及其子公司参股类金融公司的，适用本条要求；经营类金融业务的不适用本条，经营类金融业务是指将类金融业务收入纳入合并报表。

（四）基于历史原因，通过发起设立、政策性重组等形成且短期难以清退的财务性投资，不纳入财务性投资计算口径。

（五）金额较大是指，公司已持有和拟持有的财务性投资金额超过公司合并报表归属于母公司净资产的百分之三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。

（六）本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资金额应当从本次募集资金总额中扣除。投入是指支付投资资金、披露投资意向或者签订投资协议等。”

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人与财务性投资相关的各类报表项目情况如下：

单位：万元

项目	2026年6月末账面价值	其中：财务性投资金额	财务性投资占期末归母净资产的比例
交易性金融资产	86,013.80	-	-
其他应收款	101.55	-	-
其他流动资产	893.85	-	-
长期股权投资	13,023.74	-	-
其他权益工具投资	4,250.00	-	-
其他非流动金融资产	9,325.48	-	-
其他非流动资产	5,536.42	-	-
合计	119,144.84	-	-

（1）交易性金融资产

公司交易性金融资产为理财产品。截至 2026 年 6 月末，公司交易性金融资产余额为 86,013.80 万元，主要为公司利用暂时闲置资金进行现金管理购买的流动性较好、风险较低的理财产品，不属于财务性投资。

（2）其他应收款

截至 2026 年 6 月末，公司其他应收款账面价值 101.55 万元，主要为押金保证金，不存在拆借资金、委托贷款等财务性投资性质的款项。

（3）其他流动资产

截至 2026 年 6 月末，公司其他流动资产账面价值 893.85 万元，主要为待抵扣进项税额、预缴所得税等，不属于财务性投资。

（4）长期股权投资

截至 2026 年 6 月末，公司长期股权投资为 13,023.74 万元，具体情况如下：

被投资单位	2026 年 6 月 30 日	
	金额	占比
苏州工业园区苏纳微创新创业投资合伙企业（有限合伙）	8,107.08	62.25%
苏州工业园区智源微创新创业投资合伙企业（有限合伙）	4,916.66	37.75%
合计	13,023.74	100.00%

上述被投资公司与公司的业务具有协同性，对上述公司的投资为符合发行人主营业务及战略发展方向的产业投资，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

（5）其他权益工具投资

截至 2026 年 6 月末，公司其他权益工具投资账面价值为 4,250.00 万元，为对苏州德信芯片科技有限公司、厦门钧胜广源半导体有限公司等产业链上下游相关公司的投资，与公司业务具有协同性。上述投资为公司出于战略目的而计划长期持有的投资，因此公司将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，于其他权益工具投资科目列报。对上述公司的投资符合公司主营业务及战略发展方向，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

（6）其他非流动金融资产

截至 2026 年 6 月末，公司其他非流动金融资产账面价值为 9,325.48 万元，为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，为对苏州永鑫融耀创业投资合伙企业（有限合伙）和苏州登临科技股份有限公司半导体产业基金或公司的投资，与发行人的业务具有协同性，对上述公司的投资为符合发行人主营业务及战略发展方向的产业投资，系围绕产业链上下游以获取技术、原料或者渠道为目的的产业投资，不属于财务性投资。

（7）其他非流动资产

截至 2026 年 6 月末，公司其他非流动资产账面价值为 5,536.42 万元。公司其他非流动资产主要为预付长期资产款，不属于财务性投资。

综上所述，公司最近一期末财务性投资金额为 0.00 万元，占归属于母公司股东净资产的比例为 0.00%，不超过 30%。公司最近一期末不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。截至本募集说明书签署日，公司对于财务性投资暂无未来处置计划。

2、自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司实施或拟实施的财务性投资（包括类金融投资）情况

公司于 2026 年 7 月 1 日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过本次向不特定对象发行可转债的相关事项。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今（即自 2026 年 1 月 1 日至今），经过逐项对照核查，公司不存在已实施或拟实施的财务性投资与类金融业务，具体分析如下：

（1）类金融业务

公司专注于高性能功率半导体的研发和销售，产品涵盖高性能功率器件与 IC 产品，致力于提供从信号处理、逻辑控制到功率输出的完整“控制—驱动—执行”全链路解决方案，不属于类金融机构，未进行类金融业务。

（2）投资产业基金、并购基金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，除按原合同约定履行出资义务外，公司不存在投资产业基金、并购基金的情形。

（3）拆借资金

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在资金拆借情况。

（4）委托贷款

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在将资金以委托贷款的形式借予他人的情况。

（5）以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资

公司不存在以超过集团持股比例向集团财务公司出资或增资情形。

（6）购买收益波动大且风险较高的金融产品

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在购买收益波动大且风险较高的金融产品的情形。

（7）非金融企业投资金融业务

自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今，公司不存在投资金融业务的情况。

综上所述，截至报告期末，公司不存在持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今公司不存在实施或拟实施的财务性投资及类金融业务的情况。

七、经营成果分析

（一）营业收入分析

1、营业收入的整体变化情况

报告期内，公司营业收入构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	73,137.85	99.31%	125,242.67	99.98%	100,258.96	99.94%	97,285.03	100.00%
其他业务收入	505.49	0.69%	26.08	0.02%	63.04	0.06%	-	-
合计	73,643.34	100.00%	125,268.76	100.00%	100,322.00	100.00%	97,285.03	100.00%

报告期各期，公司主营业务收入分别为 97,285.03 万元、100,258.96 万元、125,242.67

万元和 73,137.85 万元，报告期内占营业收入的比例均超过 99%。

2、主营业务收入按产品类型分析

报告期内，公司按照产品类型划分的主营业务收入构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
功率器件	64,648.29	88.39%	119,326.59	95.28%	93,890.46	93.65%	90,013.36	92.53%
晶圆	4,163.51	5.69%	5,916.09	4.72%	6,368.50	6.35%	7,271.67	7.47%
数模混合控制芯片	4,326.06	5.91%	-	-	-	-	-	-
合计	73,137.85	100.00%	125,242.67	100.00%	100,258.96	100.00%	97,285.03	100.00%

报告期内，公司主营业务收入由功率器件、晶圆和数模混合控制芯片的销售收入构成。

2024 年度，公司主营业务收入同比增长 2,973.93 万元，增幅为 3.06%，收入规模整体保持稳定。

2025 年度，公司主营业务收入同比增长 24,983.71 万元，增幅为 24.92%，主要系公司积极优化产品组合策略，进行工艺平台迭代升级，持续开拓新兴市场，通过不断深化与上下游优秀合作伙伴的合作，持续扩大产能。公司主营产品广泛应用于以 5G 基站电源及通信电源、数据中心和算力服务器电源、工业照明电源、车载充电机、新能源汽车直流充电桩、光伏逆变及储能、车身加热和平衡系统等为代表的工业级与汽车级领域。2025 年度，受前述应用领域需求回暖、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化等因素影响，公司营业收入有所上升。

3、营业收入按销售区域分析

报告期内，公司营业收入按销售区域分布如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
境内	72,588.17	98.57%	124,089.18	99.06%	98,592.36	98.28%	96,002.54	98.68%
境外	1,055.17	1.43%	1,179.57	0.94%	1,729.64	1.72%	1,282.49	1.32%

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	73,643.34	100.00%	125,268.76	100.00%	100,322.00	100.00%	97,285.03	100.00%

报告期内，公司销售区域以境内为主，各期占比均超过 98%。

4、主营业务收入按销售模式分析

报告期内，公司主营业务收入按销售模式分布如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
经销模式	53,285.36	72.86%	87,964.37	70.24%	65,590.55	65.42%	68,717.17	70.63%
直销模式	19,852.49	27.14%	37,278.30	29.76%	34,668.42	34.58%	28,567.86	29.37%
合计	73,137.85	100.00%	125,242.67	100.00%	100,258.96	100.00%	97,285.03	100.00%

报告期内，结合行业惯例和客户需求情况，公司采用“经销加直销”的销售模式，既通过经销商销售产品，同时也向终端系统厂商直接销售产品，其中经销模式各期占比超过 65%。

5、营业收入季节性变动情况

报告期内，公司营业收入季节性变动情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
一季度	27,977.53	37.99%	28,288.53	22.58%	17,310.85	17.26%	30,217.08	31.06%
二季度	45,665.81	62.01%	33,294.64	26.58%	24,642.59	24.56%	23,090.63	23.74%
三季度	-	-	34,779.15	27.76%	26,098.36	26.01%	23,689.32	24.35%
四季度	-	-	28,906.44	23.08%	32,270.20	32.17%	20,288.00	20.85%
合计	73,643.34	100.00%	125,268.76	100.00%	100,322.00	100.00%	97,285.03	100.00%

报告期内，发行人各季度实现的收入具有一定波动，主要与下游终端产品市场需求有关。

（二）营业成本分析

1、营业成本的整体变化情况

报告期内，公司营业成本构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务成本	60,788.25	99.93%	104,922.06	99.99%	85,974.80	99.99%	75,170.26	100.00%
其他业务成本	41.36	0.07%	13.27	0.01%	7.52	0.01%	-	-
合计	60,829.61	100.00%	104,935.34	100.00%	85,982.32	100.00%	75,170.26	100.00%

报告期各期，发行人主营业务成本分别为 75,170.26 万元、85,974.80 万元、104,922.06 万元及 60,788.25 万元，与主营业务收入变动趋势保持一致。

2、主营业务成本按产品类型分析

报告期内，公司按照产品类型划分的主营业务成本构成情况如下所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
功率器件	54,440.27	89.56%	99,892.74	95.21%	80,577.44	93.72%	68,928.09	91.70%
晶圆	3,511.20	5.78%	5,029.32	4.79%	5,397.37	6.28%	6,242.17	8.30%
数模混合控制芯片	2,836.79	4.67%	-	-	-	-	-	-
合计	60,788.25	100.00%	104,922.06	100.00%	85,974.80	100.00%	75,170.26	100.00%

报告期内，公司主营业务成本构成与其主营业务收入构成基本一致，变动趋势基本匹配。

（三）毛利率分析

1、毛利结构分析

报告期内，公司营业毛利情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
----	--------------	---------	---------	---------

	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务毛利	12,349.61	96.38%	20,320.61	99.94%	14,284.16	99.61%	22,114.77	100.00%
其他业务毛利	464.12	3.62%	12.81	0.06%	55.52	0.39%	-	-
合计	12,813.73	100.00%	20,333.42	100.00%	14,339.68	100.00%	22,114.77	100.00%

报告期内，公司毛利基本来自主营业务。报告期各期，公司主营业务毛利分别为 22,114.77 万元、14,284.16 万元、20,320.61 万元及 12,349.61 万元。2024 年度，公司保持了主要产品销量的同比上升，整体销售规模较上年同期小幅增加，但由于产品销售价格的下降，公司毛利率有所下降，毛利有所降低。2025 年度，受益于数据中心、算力服务器电源等领域的业务稳步增长、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化，公司营业收入和毛利率有所上升，毛利同比有所增加。

报告期内，公司主营业务毛利构成情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比	毛利	占比
功率器件	10,208.02	82.66%	19,433.84	95.64%	13,313.03	93.20%	21,085.27	95.34%
晶圆	652.32	5.28%	886.77	4.36%	971.14	6.80%	1,029.50	4.66%
数模混合控制芯片	1,489.27	12.06%	-	-	-	-	-	-
总计	12,349.61	100.00%	20,320.61	100.00%	14,284.16	100.00%	22,114.77	100.00%

2、毛利率分析

报告期内，公司毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
主营业务	12,349.61	16.89%	20,320.61	16.22%	14,284.16	14.25%	22,114.77	22.73%
其他业务	464.12	91.82%	12.81	49.11%	55.52	88.07%	-	-
总计	12,813.73	17.40%	20,333.42	16.23%	14,339.68	14.29%	22,114.77	22.73%

报告期各期，公司综合毛利率分别为 22.73%、14.29%、16.23%和 17.40%。

2024 年度，由于产品销售价格的下降，公司毛利率有所下降；2025 年以来，公司受益于数据中心、算力服务器电源等领域的业务保持增长并稳步提升、产能持续扩大、新产品不断推出及产品组合结构进一步优化等因素影响，公司营业收入和毛利率有所上升。

报告期内，公司各类业务毛利率情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率	毛利	毛利率
功率器件	10,208.02	15.79%	19,433.84	16.29%	13,313.03	14.18%	21,085.27	23.42%
晶圆	652.32	15.67%	886.77	14.99%	971.14	15.25%	1,029.50	14.16%
数模混合控制芯片	1,489.27	34.43%	-	-	-	-	-	-
总计	12,349.61	16.89%	20,320.61	16.22%	14,284.16	14.25%	22,114.77	22.73%

3、发行人毛利率与同行业上市公司毛利率比较

同行业上市公司同类型业务毛利率水平如下表所示：

上市公司	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
华润微	26.62%	26.38%	27.19%	32.22%
宏微科技	12.52%	17.34%	15.39%	22.18%
新洁能	30.04%	32.86%	36.42%	30.75%
士兰微	18.56%	18.83%	19.09%	22.21%
南芯科技	35.28%	37.74%	40.12%	42.30%
可比公司平均值	24.60%	26.63%	27.64%	29.93%
公司	17.40%	16.23%	14.29%	22.73%

资料来源：同花顺 iFind。

公司以高压超级结 MOSFET 等功率器件为主要产品，并采用 Fabless 经营模式。

华润微、士兰微以中低压 MOSFET 等功率器件业务，采用 IDM 模式，与公司产品的下游市场和经营模式不具有完全可比性。新洁能采用 Fabless+部分自主封测模式，产品结构以中低压功率器件为主，与公司产品的下游市场存在一定差异。南芯科技主营产品为电源管理及电池管理 IC，与报告期内公司的主要收入来源存在一定差异。宏微科

技采用 Fabless+ 部分自主封装模式，产品以 IGBT 及模块为主，产品存在一定差异但下游均以工业领域应用为主，均出现 2024 年较大幅度的毛利率下降，报告期内的毛利率波动情况与公司情况较为可比。

综上所述，公司报告期内毛利率水平与可比公司存在差异，主要系具体产品结构、业务规模及经营模式存在差异所致，具有合理性。

（四）利润主要来源及经营成果变化分析

最近三年及一期，公司利润表主要项目构成如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
一、营业收入	73,643.34	125,268.76	100,322.00	97,285.03
减：营业成本	60,829.61	104,935.34	85,982.32	75,170.26
税金及附加	135.60	107.53	60.83	125.78
销售费用	2,009.80	2,878.80	1,696.88	979.31
管理费用	3,230.43	5,415.30	3,539.79	2,359.76
研发费用	5,565.28	9,231.76	7,571.57	8,505.02
财务费用	25.43	-400.94	-1,322.81	-3,991.82
其中：利息费用	104.97	127.70	108.13	49.11
利息收入	99.56	545.21	1,460.17	4,045.63
加：其他收益	414.22	1,159.14	834.60	1,338.62
投资收益（损失以“-”号填列）	4,583.70	2,307.97	2,573.06	67.36
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,770.40	177.02	0.31	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-223.47	356.10	-682.90	344.47
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,159.91	-3,980.88	-2,209.57	-862.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6.83	200.09	8.42	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,238.97	3,320.41	3,317.33	15,024.25
加：营业外收入	2.85	14.61	15.42	-
减：营业外支出	1.01	9.76	19.35	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,240.80	3,325.26	3,313.40	15,024.25
减：所得税费用	736.61	-55.50	-710.11	1,021.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,504.20	3,380.77	4,023.51	14,002.50

1、营业收入分析

报告期内，公司营业收入的变动情况及分析参见本节之“七、经营成果分析”之“（一）营业收入分析”的相关内容。

2、营业成本分析

报告期内，公司营业成本的变动情况及分析参见本节之“七、经营成果分析”之“（二）营业成本分析”的相关内容。

3、期间费用分析

（1）期间费用整体占比及变动情况

报告期内，公司各项期间费用金额及其占营业收入的比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
销售费用	2,009.80	2.73%	2,878.80	2.30%	1,696.88	1.69%	979.31	1.01%
管理费用	3,230.43	4.39%	5,415.30	4.32%	3,539.79	3.53%	2,359.76	2.43%
研发费用	5,565.28	7.56%	9,231.76	7.37%	7,571.57	7.55%	8,505.02	8.74%
财务费用	25.43	0.03%	-400.94	-0.32%	-1,322.81	-1.32%	-3,991.82	-4.10%
合计	10,830.93	14.71%	17,124.92	13.67%	11,485.44	11.45%	7,852.28	8.07%

公司期间费用包括销售费用、管理费用、研发费用及财务费用，报告期各期，公司期间费用分别为 7,852.28 万元、11,485.44 万元、17,124.92 万元和 10,830.93 万元，占营业收入的比例分别为 8.07%、11.45%、13.67%和 14.71%。

（2）销售费用

报告期内，公司各期销售费用主要项目及所占比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,215.38	60.47%	1,783.42	61.95%	1,097.54	64.68%	674.81	68.91%
股份支付	299.22	14.89%	311.12	10.81%	-	-	-	-

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
折旧摊销费	175.22	8.72%	306.67	10.65%	261.38	15.40%	41.08	4.19%
差旅费、招待费	136.80	6.81%	181.12	6.29%	77.33	4.56%	59.76	6.10%
样品费	103.09	5.13%	187.06	6.50%	175.99	10.37%	149.72	15.29%
物业费	21.67	1.08%	42.25	1.47%	43.37	2.56%	3.02	0.31%
广告宣传费	9.49	0.47%	24.16	0.84%	7.18	0.42%	21.53	2.20%
中介服务费	2.56	0.13%	16.17	0.56%	14.26	0.84%	20.94	2.14%
其他	46.35	2.31%	26.83	0.93%	19.84	1.17%	8.47	0.86%
合计	2,009.80	100.00%	2,878.80	100.00%	1,696.88	100.00%	979.31	100.00%

公司销售费用主要由职工薪酬、股份支付、折旧摊销费、差旅费、招待费、样品费等构成。报告期各期，公司销售费用分别为 979.31 万元、1,696.88 万元、2,878.80 万元和 2,009.80 万元，占营业收入的比例分别是 1.01%、1.69%、2.30%及 2.73%。近三年公司销售费用呈增长趋势，主要系：1）销售人员增加及相应薪资调增，导致人员费用增加；2）实施了限制性股票激励计划，新增股份支付；3）公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租赁办公场所，相应的房租物业费均有所增加。

（3）管理费用

报告期内，公司各期管理费用主要项目及所占比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	1,636.08	50.65%	3,111.55	57.46%	1,722.98	48.67%	1,350.02	57.21%
股份支付	541.90	16.77%	530.73	9.80%	-	-	-	-
折旧摊销费	485.24	15.02%	668.96	12.35%	659.46	18.63%	295.97	12.54%
中介服务费	213.45	6.61%	458.16	8.46%	665.64	18.80%	401.29	17.01%
办公水电费	140.73	4.36%	386.15	7.13%	239.58	6.77%	124.73	5.29%
差旅费、招待费	128.62	3.98%	168.87	3.12%	128.99	3.64%	140.90	5.97%
物业费	26.90	0.83%	67.67	1.25%	64.25	1.82%	30.32	1.29%
其他	57.51	1.78%	23.19	0.43%	58.89	1.66%	16.53	0.70%
合计	3,230.43	100.00%	5,415.30	100.00%	3,539.79	100.00%	2,359.76	100.00%

公司管理费用以职工薪酬为主，另包含股份支付、折旧摊销费、中介服务费、办公水电费等。报告期各期，公司管理费用分别为 2,359.76 万元、3,539.79 万元、5,415.30 万元和 3,230.43 万元，占营业收入的比例分别为 2.43%、3.53%、4.32%和 4.39%。公司管理费用整体呈上升趋势，主要系：1）公司经营规模扩大，为提升治理水平和管理能力，适度增加了管理人员，致人员薪资费用等增加；2）公司实施了限制性股票激励计划，相应的股份支付有所增加；3）公司经营管理需要，搬迁至新的办公地点，新增租赁办公场所，相应的搬迁费用及房租物业费均有所增加。

（4）研发费用

报告期内，公司各期研发费用主要项目及所占比例情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
职工薪酬	2,212.45	39.75%	3,875.00	41.97%	2,902.51	38.33%	2,263.87	26.62%
物料消耗	1,623.77	29.18%	2,620.54	28.39%	2,565.76	33.89%	2,424.21	28.50%
折旧与摊销	578.94	10.40%	761.61	8.25%	562.32	7.43%	359.29	4.22%
股份支付	504.35	9.06%	551.31	5.97%	-	0.00%	-	0.00%
检测测试费	456.68	8.21%	893.98	9.68%	854.04	11.28%	665.64	7.83%
委外研发	45.67	0.82%	290.18	3.14%	433.96	5.73%	2,618.40	30.79%
专利费	12.52	0.23%	37.66	0.41%	68.58	0.91%	55.46	0.65%
其他	130.91	2.35%	201.49	2.18%	184.40	2.44%	118.15	1.39%
合计	5,565.28	100.00%	9,231.76	100.00%	7,571.57	100.00%	8,505.02	100.00%

公司研发费用主要由职工薪酬、物料消耗和折旧与摊销等组成。报告期各期，公司研发费用分别为 8,505.02 万元、7,571.57 万元、9,231.76 万元及 5,565.28 万元，研发费用占营业收入的比重分别为 8.74%、7.55%、7.37%和 7.56%。2024 年度，公司研发费用同比有所降低，主要系委外研发减少所致。2025 年度，公司研发费用同比有所上升，主要系公司加大研发投入，职工薪酬增加，同时新增股份支付所致。

（5）财务费用

报告期内，公司各期财务费用主要项目情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
利息支出	94.32	73.82	55.34	32.63
租赁负债融资费用	10.65	53.88	52.79	16.48
减：利息收入	99.56	545.21	1,460.17	4,045.63
汇兑损益	17.74	13.86	27.85	-2.10
手续费及其他	2.28	2.71	1.39	6.80
合计	25.43	-400.94	-1,322.81	-3,991.82

报告期各期，公司财务费用分别为-3,991.82 万元、-1,322.81 万元、-400.94 万元和 25.43 万元，占营业收入的比重分别为-4.10%、-1.32%、-0.32%和 0.03%。报告期内，公司财务费用随存款类产品的利息收入变化而变化。

4、其他收益

报告期各期，公司取得的其他收益金额分别为 1,338.62 万元、834.60 万元、1,159.14 万元及 414.22 万元，主要是政府补助等。报告期内，公司其他收益项目情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
与资产相关的政府补助	103.01	206.02	133.85	146.02
与收益相关的政府补助	153.20	943.79	683.57	1,154.10
增值税进项加计抵减	147.88	-	-	32.07
代扣个人所得税手续费返还	10.14	9.33	17.18	6.42
合计	414.22	1,159.14	834.60	1,338.62

5、投资收益

报告期各期，公司取得投资收益金额分别为 67.36 万元、2,573.06 万元、2,307.97 万元及 4,583.70 万元，主要为处置长期股权投资产生的投资收益、处置交易性金融资产取得的投资收益、权益法核算的长期股权投资收益等。

投资收益明细情况如下表。

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
处置长期股权投资产生的投资收益	2,816.03	-	-	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	891.01	2,521.57	2,643.41	1,124.56
权益法核算的长期股权投资收益	782.76	-194.16	-70.35	-1,055.69
丧失重大影响后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	90.28	-	-	-
其他非流动金融资产在持有期间取得的股利收入	14.19	0.11	-	-
应收款项融资贴现损失	-10.58	-19.54	-	-1.51
合计	4,583.70	2,307.97	2,573.06	67.36

6、公允价值变动收益

报告期各期，公司公允价值变动收益金额分别为 0.00 万元、0.31 万元、177.02 万元及 6,770.40 万元，主要为理财收益和分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动等。

7、信用减值损失

公司将应收票据、应收账款、其他应收款等科目的坏账准备计入信用减值损失。报告期内主要信用减值损失是对应收账款计提的减值损失，具体情况及分析参见本节之“六、财务状况分析”之“（一）资产情况”之“2、流动资产的构成及分析”之“（3）应收账款”的相关内容。

8、资产减值损失

报告期内，公司资产减值损失主要是存货跌价损失，具体情况及分析参见本节之“六、财务状况分析”之“（一）资产情况”之“2、流动资产的构成及分析”之“（4）存货”的相关内容。

9、资产处置收益

报告期各期，公司取得的资产处置收益金额分别为 0.00 万元、8.42 万元、200.09 万元及 6.83 万元，整体金额较小。

10、营业外收入和营业外支出

（1）营业外收入

报告期各期，公司营业外收入金额分别为 0.00 万元、15.42 万元、14.61 万元和 2.85 万元，整体金额较低。

（2）营业外支出

报告期各期，公司营业外支出金额分别为 0.00 万元、19.35 万元、9.76 万元及 1.01 万元，整体金额较低。

（五）非经常性损益情况

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	6.83	200.09	8.05	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	256.21	1,149.81	817.42	1,300.12
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	11,670.03	3,225.78	3,638.78	1,124.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1.84	4.85	-3.56	-
非经常性损益总额	11,934.90	4,580.53	4,460.69	2,424.69
减：非经常性损益的所得税影响数	1,364.48	656.48	669.10	363.70
非经常性损益净额	10,570.42	3,924.06	3,791.58	2,060.98
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	9.16	92.73	-	-
归属于公司普通股股东的非经常性损益	10,561.26	3,831.33	3,791.58	2,060.98

报告期内，公司非经常性损益净额分别为 2,060.98 万元、3,791.58 万元、3,924.06 万元及 10,570.42 万元。公司非经常性损益主要构成项目为持有金融资产和金融负债产

生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益、政府补助等。

（六）纳税情况

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额（应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算）	6%、13%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴	1.2%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税额	7%、5%
教育费附加	实际缴纳的流转税额	3%
地方教育费附加	实际缴纳的流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、21%

截至 2026 年 6 月 30 日，不同企业所得税税率纳税主体情况如下：

纳税主体名称	所得税税率
东微半导、深圳慧能泰、上海慧能泰	15%
赛普锐思公司、香港慧能泰公司	16.5%
深圳东能半导体有限公司	20%
苏州电征科技有限公司	20%
苏州智启科技有限公司	20%
美国慧能泰公司	21%

2、税收优惠

（1）公司于 2021 年取得编号为 GR202132004350 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，故 2023 年度按照应纳税所得额的 15%计提企业所得税。

公司于 2024 年取得编号为 GR202432001930 的高新技术企业证书，有效期为 3 年，2024 年度-2026 年 6 月按照应纳税所得额的 15%计提企业所得税。

子公司深圳慧能泰于 2023 年取得编号为 GR202344205582 的高新技术企业证书，有效期 3 年，2026 年 1-6 月按照应纳税所得额的 15%计提企业所得税。

子公司上海慧能泰于 2023 年取得编号为 GR202331004675 的高新技术企业证书，

有效期 3 年，2026 年 1-6 月按照应纳税所得额的 15%计提企业所得税。

（2）根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部税务总局公告〔2023〕43 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，公司作为先进制造业企业，相关业务按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳增值税税额。

根据《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》（财政部税务总局公告 2023 年第 17 号），允许集成电路企业按照当期可抵扣进项税额加计 15%抵减应纳增值税税额。子公司深圳慧能泰、上海慧能泰享受上述优惠政策。

（3）根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 6 号）和《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部、税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。子公司电征科技公司、东能半导体公司、智启科技公司作为小型微利企业享受上述税收优惠政策。

八、现金流量分析

（一）经营活动现金流

报告期内，公司经营活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
销售商品、提供劳务收到的现金	65,414.17	124,557.83	82,786.04	106,740.92
收到的税费返还	-	1,440.48	990.19	847.22
收到其他与经营活动有关的现金	287.80	1,589.42	2,343.43	5,185.52
经营活动现金流入小计	65,701.97	127,587.73	86,119.66	112,773.67
购买商品、接受劳务支付的现金	71,132.19	134,924.44	86,333.22	92,533.73
支付给职工以及为职工支付的现金	5,712.46	9,036.04	5,490.93	4,514.49
支付的各项税费	155.53	431.44	367.01	4,342.25
支付其他与经营活动有关的现金	1,632.19	2,368.73	2,759.82	4,328.48
经营活动现金流出小计	78,632.37	146,760.65	94,950.98	105,718.95
经营活动产生的现金流量净额	-12,930.39	-19,172.92	-8,831.32	7,054.72

报告期各期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 7,054.72 万元、-8,831.32 万元、-19,172.92 万元和-12,930.39 万元，其中销售商品、提供劳务收到的现金分别为 106,740.92 万元、82,786.04 万元、124,557.83 万元和 65,414.17 万元。2024 年以来公司经营活动现金流量净额为负，主要系公司经营规模有所扩大，购买商品、接受劳务支付的现金以及支付给职工及为职工支付的现金有所增加所致。

（二）投资活动现金流

报告期内，公司投资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	429,578.21	1,036,010.57	632,428.95	178,093.30
取得投资收益收到的现金	908.62	2,523.11	2,643.41	1,138.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,327.30	99.90	21.07	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	4,767.16	-
投资活动现金流入小计	434,814.13	1,038,633.58	639,860.59	179,231.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,118.35	12,293.37	3,231.18	7,521.02
投资支付的现金	483,988.00	1,058,510.57	638,428.95	175,493.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	31,226.29	267.40	-	-
投资活动现金流出小计	522,332.64	1,071,071.33	641,660.13	183,014.32
投资活动产生的现金流量净额	-87,518.51	-32,437.75	-1,799.54	-3,782.75

报告期各期，公司投资活动产生的现金流量净额分别为-3,782.75 万元、-1,799.54 万元、-32,437.75 万元和-87,518.51 万元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额变化，主要系购买及到期赎回的理财产品规模的净额变化及支付购建的固定资产金额变化所致。

（三）筹资活动现金流

报告期内，公司筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
吸收投资收到的现金	-	94.76	-	-

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
取得借款收到的现金	1,000.00	4,997.18	476.03	3,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	946.68	-	-
筹资活动现金流入小计	1,000.00	6,038.62	476.03	3,000.00
偿还债务支付的现金	4,200.00	1,699.00	3,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74.28	551.17	1,738.04	9,975.20
支付其他与筹资活动有关的现金	131.51	604.80	1,728.37	1,643.39
筹资活动现金流出小计	4,405.78	2,854.97	6,466.41	11,618.59
筹资活动产生的现金流量净额	-3,405.78	3,183.65	-5,990.39	-8,618.59

报告期各期，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为-8,618.59 万元、-5,990.39 万元、3,183.65 万元和-3,405.78 万元。2024 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额有所提高，主要系公司派发的现金红利少于上年度所致。2025 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额由负转正，主要系由于控股子公司经营发展需要，取得银行短期贷款有所增加所致。

九、资本性支出分析

（一）报告期内重大资本性支出情况

报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 7,521.02 万元、3,231.18 万元、12,293.37 万元和 7,118.35 万元。报告期内公司不涉及重大资本性支出，主要为日常生产经营中购建固定资产。

（二）未来可预见的重大资本性支出计划及资金需求情况

截至本募集说明书出具日，未来可预见的重大资本性支出主要为：1、根据公司战略发展规划，公司拟投资不高于人民币 32,000 万元（含土地出让金，最终投资总额以实际投资为准）建设研发生产总部基地。2、本次募集资金投资项目，具体情况详见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”的有关内容。

（三）重大资本性支出与科技创新之间的关系

关于重大资本性支出与科技创新之间的关系，具体参见本募集说明书“第七节 本次募集资金运用”之“四、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式”。

十、技术创新分析

（一）技术先进性及具体表现

参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”及“十一、与公司产品有关的技术情况”。

（二）正在从事的研发项目及进展情况

截至报告期末，公司正在从事的研发项目共 23 个，具体情况如下：

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
1	1200V SiC 功率器件平台拓广研发	完成新一代 1200V SiC MOSFET 的流片，器件静态参数达标	第三代、第四代 650V/750V/1200V SiC MOSFET 工艺平台搭建以及代表产品稳定量产	应用于新能源汽车电驱系统、直流大功率新能源汽车充电桩、车载充电机、光伏逆变器、储能逆变、UPS 电源等应用领域
2	第六代超级结器件研发	产品设计已达预期，并顺利通过内部测试	第六代超级结器件在东微自主知识产权 GreenMOS 技术平台上，缩小了元胞尺寸，优化了元胞设计 P 柱和 N 柱之比，大幅降低器件 RSP，同时优化保证制造工艺的稳定性	算力电源，光伏逆变
3	中低压 SGT 在人形机器人关节应用中的器件优化研发	完成开发目标并实现批量出货	具备高鲁棒性，安全工作区大，功率密度大，开关速度及响应速度快等优点	应用于人形机器人关节电机控制
4	新一代算力中心专用 650V SiC 功率器件平台拓广研发	已完成开发，客户测试导入中	高速开关 650V SiC MOSFET 3.8um pitch 器件工艺平台搭建，目标电压 650V, R _{ONSP} 3.0ohm-cm ² , 满足算力中心应用的需求。缩小芯片面积，提高产品良率，显著提高产品的竞争力和性价比	算力电源
5	激光雷达及高密度电机驱动用低压 GaN 器件研发	实验进展顺利	TCAD 仿真优化器件 pitch、场板结构；栅极增加阻挡层结构降低器件栅极漏电、调整场板结构及 layout 布局调控器件 Q _{gs} /Q _{gd} 比值、优化欧姆接触工艺	应用于 LIDAR 和高密度电机以及 DC-DC 转换器领域
6	车载半桥 Si 器件与 SiC 器件模块研发	部分料号开发完成，客户导入中	开发车规半桥模块并兼容液冷散热技术	车载电源

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
7	算力系统高速超级结芯片研发	实验进展顺利	开发面向算力系统（AI服务器、数据中心）电源应用的高速 600V/650V 超级结 MOSFET 芯片。围绕器件结构优化、体二极管反向恢复特性改善以及封装优化等维度，全面提升超级结 MOSFET 在导通电阻、开关特性、反向恢复以及大功率应用等方面的综合性能	AI 服务器、数据中心电源
8	200V-300V 超级结芯片型号扩展研发	实验进展顺利	项目基于 8 英寸深沟槽超级结工艺平台，开发 200V/250V/300V 多电压等级、多 Rds(on) 档位（如数毫欧至数十毫欧）的芯片型号系，并通过可靠性考核	DC-DC 转换，微型逆变器
9	车规级第四代超级结器件研发	实验进展顺利	依托 GreenMOS 第四代技术平台，通过器件结构与工艺优化实现更低比导通电阻、更优开关特性及 dv/dt 耐受能力，同步开发顶部散热封装并完成 AEC-Q101 车规级可靠性认证，打造适配新一代车载 OBC 液冷方案的高功率密度、高可靠性车规级超级结器件	车载电源
10	固态变压器用高压 SiC 产品研发	已完成部分规格的开发	700V-10KV SiC MOSFET 器件工艺平台搭建；满足 SST 应用需求。提高耐压，改善电流能力，缩小芯片面积，提高产品良率，显著提高产品的竞争力和性价比	固态变压器
11	12 寸超级硅器件研发	600/650V 平台已经完成工程开发验证	开发电压规格 600V、650V 产品平台，栅电荷 (Qg) 较传统 SJ 降低 $\geq 10\%$	高密度电源、快速充电器、模块转换器、快充超薄类 PC 适配器、TV 电源板等
12	第三代 650V 高速 IGBT（Tri-gate IGBT）产品系列化研发	部分料号开发完成，客户导入中	显著提升开关速度，相较于第二代产品，具有更大功率极限的安全冗余	车载电源，光伏储能领域

序号	项目名称	进展或阶段性成果	拟达到目标	具体应用前景
13	第三代 1200V 高速 IGBT（Tri-gate IGBT）产品系列化研发	实验进展顺利	显著提升开关速度，相较于第二代产品，具有更大功率极限的安全冗余	光伏储能领域
14	12 寸 IGBT 型号拓展研发	已完成部分规格的开发并实现批量出货	提升产品一致性，降低产品成本，保证供应链安全	IGBT 全应用领域
15	第三代半导体电源相关 IC 产品研发	完成版图设计	实现工业、车载以及 AI 算力中心等高端应用场景的适配	车载电源和 AI 算力中心电源
16	使用 AMB 材料的新能源汽车电机控制器用 Xpak 系列功率模块的研制	A 样制作完成，客户测试中	大功率塑封模块的汽车应用	新能源汽车电控
17	非内置驱动 IC 的全桥 DIPxx 系列功率模块的研制	设计完成	以面积的功率半导体芯片替代智能功率模块驱动 IC 的空间，实现更大电流更大功率的输出	新能源汽车电动空调、主动悬架控制器
18	小功率供电端接口控制技术及芯片产品研发	小功率单口产品已完成验证，进入量产阶段。小功率多口产品已完成流片	形成覆盖 60W 以下供电端接口主流应用的多个产品系列	适用于小功率旅行充电器，车载充电器，插排等应用场景
19	大功率供电端接口控制技术及芯片产品研发	大功率单口产品已完成验证并开始推广	形成覆盖 60W 以上供电端接口主流应用的多个产品系列	适用于大功率笔电适配器，大功率多口旅行充电器等应用场景
20	受电端接口控制技术及芯片产品研发	大功率受电端芯片已完成流片	超低功耗的受电端接口控制方案，覆盖完整的快充充电功率段	适用于移动储能系统、大功率移动电源、显示器的充电接口控制
21	大功率 ACDC 转换控制技术及芯片产品研发	图腾柱 PFC 产品已进入量产阶段	高转换效率的交直流解决方案	适用于服务器电源、PC 电源、各类工业电源的主功率控制
22	大功率 DCDC 转换控制技术及芯片产品研发	芯片已完成流片	高可靠性的可编程直流转直流控制解决方案	适用于服务器电源、砖模块电源的主功率控制
23	小功率模拟电源管理技术及芯片产品研发	芯片已完成流片	高转换效率的电源转换方案	适用于小功率旅行充电器，车载充电器，插排等应用场景

（三）保持持续技术创新的机制和安排

参见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、科技创新水平及保持科技创新能力的机制或措施”。

十一、重大担保、仲裁、诉讼、其他或有事项及重要期后事项

（一）重大担保事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在尚未了结或可预见的对外担保。

（二）重大仲裁、诉讼及其他或有事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在重大未决诉讼或仲裁事项，公司不存在其他或有事项。

（三）重大期后事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在需要披露的重大期后事项。

（四）其他重大事项

截至本募集说明书签署日，公司不存在其他对公司财务状况、盈利能力及持续经营产生影响的重大事项。

十二、本次发行的影响

（一）本次发行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合计划

本次向不特定对象发行可转债募集资金到位后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，可为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人未来陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

本次发行募集资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度摊薄，但本次可转债募集资金投资项目符合国家产业政策要求和行业市场发展趋势，随着本次募投项目效益的实现，公司长期盈利能力将会得到显著增强，经营业绩预计会有一定程度的提升。

截至 2026 年 6 月末，公司无存续债券，公司合并口径净资产为 308,398.99 万元，本次发行募集资金总额不超过 143,588.00 万元（含本数）。本次发行完成后，累计债券余额为不超过 143,588.00 万元，不超过最近一期末净资产的 50%。

本次发行不涉及资产整合情况。

（二）本次发行完成后，上市公司科技创新情况的变化

本次发行的募集资金投资项目建成后，有利于公司进一步提升生产能力，满足市场需求，深化公司发展战略，项目实施后，将显著增强公司在高端功率半导体领域的技术壁垒和产品供应能力，助力国产替代进程，有利于公司保持并进一步提升自身的研发实力和科技创新能力。

（三）本次发行完成后，上市公司控制权结构的变化

本次发行完成后，公司股权结构未发生重大变更，亦不会对实际控制人地位造成影响，不会导致上市公司控制权发生变化。

第六节 合规经营与独立性

一、公司报告期内受到的行政处罚情况

公司已按照上市公司的要求建立了完善健全的法人治理结构和内部控制制度，公司及其董事和高级管理人员严格按照公司章程及相关法律法规的规定开展经营活动。报告期内，公司及其子公司不存在受到行政处罚的情况。

二、公司及其董事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人被中国证监会行政处罚或采取监管措施及整改情况，被证券交易所公开谴责的情况，以及因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情况

报告期内，发行人无控股股东，发行人及其董事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在被证监会行政处罚或采取监管措施的情况，不存在被证券交易所公开谴责的情况，亦不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正在被证监会立案调查的情况。

三、资金占用和对控股股东、实际控制人的担保情况

报告期内，发行人无控股股东，发行人不存在资金被实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情况，不存在为实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

四、同业竞争

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的企业间不存在同业竞争情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人无控股股东，公司实际控制人王鹏飞、龚轶除持有公司股份外，其控制的其他企业不存在与公司及其下属企业从事相同或相似业务的情况，公司与实际控制人及其控制的企业间不存在同业竞争。

（二）关于避免同业竞争的承诺

1、实际控制人及其一致行动人关于避免同业竞争的承诺

（1）截至本承诺函签署之日，本人及本人控制的企业不存在、未来也不会直接或

间接从事任何与公司及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动，亦不会以任何形式支持第三方直接或间接从事任何与公司及其下属子公司所从事的业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；

（2）自本承诺函签署之日起，若本人或本人控制的企业进一步拓展产品和业务范围，本人及本人控制的企业将不开展与公司及其下属子公司相竞争的业务，若本人或本人控制的企业有任何商业机会可从事、参与或投资任何可能会与公司及其下属子公司所从事的业务构成竞争的业务，本人及本人控制的企业将给予公司及其下属子公司优先发展权；

（3）如违反上述承诺，本人及本人控制的企业愿意承担由此产生的全部责任，赔偿或补偿由此给公司及其下属子公司造成的损失；

（4）本承诺自签署之日起生效，有效期至本人及本人控制的企业不再拥有公司及其下属子公司的控制权，且本人不再担任公司董事、高级管理人员为止。

（三）避免同业竞争承诺的履行和实施情况

报告期内，发行人实际控制人及其一致行动人严格遵守避免同业竞争的承诺，未实施与承诺相背的行为。

（四）本次发行不涉及新增同业竞争情况

公司本次募集资金将用于新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目和研发中心建设项目，本次发行不涉及新增同业竞争情况。

五、关联交易

（一）关联方和关联关系

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市规则》《企业会计准则第36号——关联方披露》、相关主体填写的调查表、《审计报告》、发行人的公告文件、相关主体的营业执照、工商登记资料、身份证明文件及公开渠道信息，报告期内发行人的主要关联方如下：

1、关联自然人

（1）实际控制人及其一致行动人

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人实际控制人为王鹏飞、龚轶，卢万松系公司实际控制人的一致行动人。

发行人实际控制人及其一致行动人的具体情况详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“四、控股股东及实际控制人的基本情况”之“（一）控股股东及实际控制人”之“1、控股股东及实际控制人情况”及“第四节 发行人基本情况”之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历”之“1、董事”相关内容。

（2）直接或间接持有发行人 5%以上股份的自然人股东

截至 2026 年 6 月 30 日，除实际控制人王鹏飞、龚轶外，发行人无其他直接或间接持有发行人 5%以上的自然人股东。

（3）发行人现任董事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人现任董事、高级管理人员的情况详见“第四节 发行人基本情况”之“六、公司董事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“（一）现任董事、高级管理人员及核心技术人员的任职情况及经历”相关内容。

前述关联自然人关系密切的家庭成员亦为发行人的关联方，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母，以及过去十二个月内或者根据相关协议安排在未来十二个月内存在上述情形的自然人。

（4）直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其他主要负责人

截至 2026 年 6 月 30 日，无直接或间接控制发行人的法人或其他组织，不涉及直接或间接控制发行人的法人或其他组织的董事、高级管理人员或其他主要负责人。

2、关联法人

（1）控股股东

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人无控股股东。

（2）子公司

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人子公司的基本情况详见本募集说明书“第五节 财务会计信息与管理层分析”之“三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及其变化情况”之“（三）合并财务报表范围及其变化情况”相关内容。

（3）联营企业

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人共有 3 家联营企业，联营企业的基本情况如下：

序号	企业名称	持股比例/出资比例	成立日期	注册资本/出资额（万元）	认缴出资/持有股数（万元/万股）	注册地址/主要经营场所	经营范围/主营业务
1	苏州工业园区智源微新创业投资合伙企业（有限合伙）	83.1947%	2024.12.17	6,010	5,000	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 8 幢 203 室	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2	苏州工业园区苏纳微新创业投资合伙企业（有限合伙）	78.9474%	2022.08.04	7,600	6,000	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路 183 号东沙湖基金小镇 8 幢 203 室	一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
3	苏州德信芯片科技有限公司	7.5758%	2022.02.22	52,800	4,000	中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区东长路 88 号 D1 幢 1 层 B35-6 室	一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；电力电子元器件

序号	企业名称	持股比例/出资比例	成立日期	注册资本/出资额（万元）	认缴出资/持有股数（万元/万股）	注册地址/主要经营场所	经营范围/主营业务
							制造；电力电子元器件销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子专用材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（4）直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至 2026 年 6 月 30 日，直接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	苏州工业园区原点创业投资有限公司	直接持有发行人5%以上股份的法人，持有发行人11.39%的股份
2	中新苏州工业园区创业投资有限公司	直接持有发行人5%以上股份的法人，持有发行人5.35%的股份，通过持有苏州工业园区原点创业投资有限公司100%的股权，间接持有发行人11.39%的股份

苏州工业园区原点创业投资有限公司系中新苏州工业园区创业投资有限公司的全资子公司，二者合计持有发行人 16.74%的股份。

（5）上述关联法人或关联自然人直接或者间接控制的发行人及其控股子公司之外的法人或其他组织，或者由关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的发行人及其控股子公司之外的法人或其他组织

截至 2026 年 6 月 30 日，上述关联法人或关联自然人直接或者间接控制的发行人及其控股子公司之外的法人或其他组织，或者由关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的发行人及其控股子公司之外的主要法人或其他组织，具体如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	苏州工业园区高维企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人王鹏飞担任执行事务合伙人的企业
2	苏州工业园区得数聚才企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人龚轶担任执行事务合伙人的企业
3	上海东脑智合技术有限公司	实际控制人龚轶持有19.29%股权并担任董事的企业
4	温州市顺泰人力资源顾问有限公司	实际控制人王鹏飞的父亲王绍杰持股100.00%，担任执行董事兼经理的企业

序号	关联方名称	关联关系
5	温州市鑫泰人力资源顾问有限公司	实际控制人王鹏飞的父亲王绍杰担任执行董事兼经理的企业
6	温州东众创空间管理有限公司	实际控制人王鹏飞的兄弟王鹏善持股90.00%，王鹏飞的父亲王绍杰担任执行董事兼总经理的企业
7	上海成长之路教育科技有限公司	实际控制人王鹏飞的配偶持股96.3%，担任执行董事的企业
8	苏州华坤企业管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人龚轶的配偶陆晓蕾持有40%财产份额，担任执行事务合伙人的企业
9	苏州华太电子技术股份有限公司	董事金光杰担任董事的企业
10	苏州园芯微电子技术有限公司	董事金光杰担任董事、经理的企业
11	成川科技（苏州）有限公司	董事金光杰担任董事的企业
12	苏州睿芯集成电路科技有限公司	董事金光杰担任董事的企业
13	苏州登堡电子科技有限公司	董事金光杰担任董事的企业
14	苏州磁明科技有限公司	董事金光杰担任董事的企业
15	苏州腾芯微电子有限公司	董事金光杰担任董事的企业
16	共模半导体技术（苏州）有限公司	董事金光杰担任董事的企业
17	苏州禾芯半导体有限公司	董事金光杰担任董事的企业
18	龙晶石半导体科技（苏州）有限公司	董事金光杰担任董事的企业
19	苏州慧闻纳米科技有限公司	董事金光杰担任董事的企业
20	创耀（苏州）通信科技股份有限公司	董事金光杰担任董事的企业
21	Oriza Naxin International Co., Limited （中文名：元禾纳芯国际有限公司）	董事金光杰担任执行董事的企业
22	新美光（苏州）半导体科技股份有限公司	董事金光杰担任董事的企业
23	苏州工业园区集成电路产业投资发展有限公司	董事金光杰担任副总经理的企业
24	苏州工业园区原汐紫信息咨询工作室	董事金光杰配偶周尔双持股 100.00%并担任经营者的企业
25	上海复纯环保科技有限公司	独立董事卢红亮持有90.00%股权的企业
26	复奇普半导体科技（嘉兴）有限公司	独立董事卢红亮持有85.00%股权的企业
27	苏州复纳电子科技有限公司	独立董事卢红亮持有85.00%股权的企业
28	复奇普集成电路设备（上海）有限公司	独立董事卢红亮持有80.00%股权的企业

除上表所列示的主体外，上述关联法人或关联自然人直接或者间接控制的发行人及其控股子公司之外的法人或其他组织，或者由关联自然人（独立董事除外）担任董事、高级管理人员的发行人及其控股子公司之外的法人或其他组织，也为发行人的关联方。

(6) 间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织

截至 2026 年 6 月 30 日，间接持有发行人 5%以上股份的法人或其他组织如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	苏州元禾控股股份有限公司	间接持有发行人5%以上股份的法人，通过持有中新苏州工业园区创业投资有限公司100%的股权，间接持有发行人16.74%的股份
2	苏州工业园区经济发展有限公司	间接持有发行人5%以上股份的法人，通过持有苏州元禾控股股份有限公司59.98%的股权，间接持有发行人10.04%的股份
3	苏州工业园区管理委员会	间接持有发行人5%以上股份的其他组织，通过持有苏州工业园区经济发展有限公司90.00%的股权，间接持有发行人9.04%的股份

3、其他主要关联方

报告期内，发行人曾经的关联方、发行人基于实质重于形式原则认定的主要关联方，具体情况如下：

序号	关联方名称	关联关系
1	王绍泽	报告期内曾为实际控制人的一致行动人，已于 2025 年 12 月解除一致行动关系
2	吴昆红	报告期内曾任董事，已于 2023 年 12 月离任
3	方伟	报告期内曾任董事，已于 2025 年 7 月离任
4	郭龙华	报告期内曾任独立董事，已于 2023 年 12 月离任
5	刘伟	报告期内曾任监事，2025 年 8 月发行人取消监事会及监事
6	赵振强	报告期内曾任监事，2025 年 8 月发行人取消监事会及监事
7	顾海军	报告期内曾任监事，2025 年 8 月发行人取消监事会及监事
8	李程晟	报告期内曾任监事，已于 2023 年 12 月离任
9	东能微科技创新投资（苏州）有限公司	发行人曾经的控股子公司，已于 2024 年 5 月注销
10	客户 A	报告期内，曾经的董事吴昆红、方伟为原 5%股东（2022 年 2 月起持股低于 5%）委派且在客户 A 任职；吴昆红已于 2023 年 12 月辞任，方伟已于 2025 年 7 月辞任，依据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，按照实质重于形式的原则，2025 年 8 月至 2026 年 7 月客户 A 仍然认定为关联方
11	杰华特微电子股份有限公司	报告期内曾经的董事吴昆红、方伟担任董事的企业。吴昆红已于 2023 年 12 月自发行人处离任，已于 2024 年 5 月自该企业离任，方伟已于 2025 年 7 月自发行人处离任，已于 2026 年 5 月自该企业离任

除上述关联方外，发行人董事、高级管理人员的关系密切家庭成员报告期内曾经直接或间接控制的，或该等人员（独立董事除外）报告期内曾担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，以及上述关联自然人及其关系密切的家庭成员作为发行人关联自然人期间曾直接或间接控制的，或该等人员（独立董事除外）为发行人关联自然人期间曾担任董事、高级管理人员的法人或其他组织，亦为发行人的其他关联方。

（二）报告期内的关联交易

1、重大关联交易

（1）重大关联交易的判断标准及依据

发行人上市以来，未发生影响发行人独立性的关联交易，不存在违反关联交易相关承诺的情况。公司参照《上海证券交易所科创板股票上市规则》（2024 年 4 月修订）相关规定，将报告期内公司与关联人发生的交易金额（关联担保除外）在 3,000 万元人民币以上且占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上的关联交易认定为重大关联交易。

（2）重大经常性关联交易

报告期内，公司重大经常性关联交易如下：

单位：万元

关联方	关联交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
客户 A	出售商品和服务	8,132.26	11,219.47	5,782.16	12,158.27
占当期营业收入的比重		11.04%	8.96%	5.76%	12.50%

注：方伟先生已于 2025 年 7 月 15 日辞任公司董事，依据《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，公司对与原董事方伟相关联的公司 2025 年 8 月至 2026 年 7 月的交易额仍作为关联交易披露。

公司与客户 A 的交易价格依据市场价格公平、合理确定，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。

报告期内，公司与重大经常性关联交易相关的应收应付款项如下：

单位：万元

项目名称	关联方	2026 年 6 月 30 日		2025 年 12 月 31 日		2024 年 12 月 31 日		2023 年 12 月 31 日	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账	客户 A	3,770.43	188.52	1,896.39	94.82	1,026.04	51.30	3,025.46	151.27

款									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

（3）重大偶发性关联交易

报告期内，公司无重大偶发性关联交易。

2、一般关联交易汇总表

单位：万元

经常性关联交易：出售商品、提供劳务情况					
关联方名称	关联交易内容	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
杰华特微电子股份有限公司	出售商品	-	11.42	1.88	2.09
合计		-	11.42	1.88	2.09
关键管理人员薪酬					
关联交易内容		2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
关键管理人员报酬		460.89	700.27	824.95	680.92
合计		460.89	700.27	824.95	680.92
关联方共同投资					
1) 2025 年度，公司以 0 对价收购 Ridge-Semiconductor Limited 和苏州迎合企业管理合伙企业（有限合伙）合计所持有的电征科技公司 54.55%股权（对应 600 万元人民币认缴出资额，其中已实缴到位 0 元），并承担实缴出资义务。公司联营企业苏纳微新合伙企业持有电征科技公司 45.45%股权，此次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。					
2) 2025 年度，公司收购苏州登临科技股份有限公司（以下简称苏州登临公司）的 117,319 股股份，涉及交易金额为人民币 1,000 万元。同时，公司实际控制人之一的龚轶先生和 5%以上股东中新创投公司（本次交易前已为苏州登临公司股东）以同样股价分别收购苏州登临的股份，涉及交易金额分别为人民币 300 万元和 5,000 万元。本次交易完成后，公司持有苏州登临 0.2175%股份，龚轶先生和中新创投公司分别持有苏州登临 0.0652%和 4.3998%股份，此次交易属于与关联方共同投资，构成关联交易。					
关联方股权转让					
2026 年 1-6 月，公司以 288 万元对价收购了苏纳微新合伙企业持有的电征科技 45.45%股权。因交易对方为公司关联方，本次收购构成关联交易。					

（三）关联方应收应付款项

报告期各期末，除前述与重大经常性关联交易相关的应收应付款项外，公司无其他关联方应收应付款项。

（四）公司最近三年关联交易的履行情况和独立董事对关联交易的意见

为规范关联交易行为，保证关联交易的公平、公正、公开，保护发行人股东的合法权益，特别是中小股东的合法权益，发行人在《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》中对关联交易事项决策程序、信息披露等事项进行了明确规定，对关联交易的公允性提供了决策程序上的保证。报告期内，发行人已根据《上市规则》及上述内部制度对报告期内的关联交易事项履行了相应的董事会、股东会程序。

报告期内，发行人独立董事根据《上市规则》《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等规定对发行人报告期内关联交易发表独立意见，认为关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易价格依据市场价格公平、合理确定，符合商业惯例，遵循了公允、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的利益。

（五）关联交易的公允性、必要性及对公司财务状况和经营成果的影响

报告期内，除与客户 A 发生重大经常性关联交易外，公司各期发生关联销售交易金额占当期营业收入的比例较低，对公司财务状况和经营成果影响较小。相关交易基于发行人日常生产经营需要而发生，系正常的市场行为，符合发行人的实际经营和发展需要，具有必要性。相关交易定价按照市场价格协商确定，遵循平等互利原则，具有公允性。公司偶发性关联交易的发生具有客观情况和偶发性因素，符合公司业务需求和战略发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

（六）规范和减少关联交易的措施

对于在发行人经营过程中，根据业务需要与关联方进行的关联交易，发行人将按照《公司章程》和有关法律法规对关联交易的有关规定，严格执行关联交易基本原则、决策程序、回避制度、信息披露等措施，将关联交易的数量和对经营成果的影响降至最小程度。对于不可避免的关联交易，发行人将严格执行《公司章程》《关联交易管理制度》规定的关联交易管理程序、关联交易决策制度、关联股东回避表决制度和信息披露制度，进一步完善独立董事制度，加强独立董事对关联交易的监督，并进一步健全发行人治理结构，保证关联交易的公平、公正、公允，避免关联交易损害发行人及股东利益。

第七节 本次募集资金运用

一、本次募集资金投资项目计划

（一）项目基本情况

本次发行可转债募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 143,588.00 万元（含 143,588.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金额	备案项目代码	备案时间
1	新型功率器件技术和产品研发及产业化项目	54,772.31	54,772.30	2608-320571-89-01-284525	2026 年 8 月 3 日
2	新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目	45,897.87	45,897.70	2608-320571-89-01-110212	2026 年 8 月 3 日
3	研发中心建设项目	32,918.00	32,918.00	2608-320571-89-01-196885	2026 年 8 月 3 日
4	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-	-
合计		143,588.18	143,588.00	-	-

如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会（或董事会授权人士）可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

（二）本次募集资金投资项目与现有业务或发展战略的关系

公司专注于高性能功率半导体的研发和销售，产品涵盖高性能功率器件与 IC 产品。在功率器件领域，公司主要产品包括 GreenMOS 系列超级结 MOSFET、SFGMOS 系列及 FSMOS 系列中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT 系列 IGBT 产品、SiC 器件（含 Si²C MOSFET）以及高密度功率模块。在 IC 产品领域，公司主要产品包括数模混合的快速充电控制芯片和开关电源控制芯片。公司致力于提供从信号处理、逻辑控制到功率输出的完整“控制—驱动—执行”全链路解决方案，逐步从高性能功率器件供应商，升级成为

新一代数字能源管理系统解决方案的供应商。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目为新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金。本次募集资金投资计划是在公司既有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，是公司把握行业发展机遇，加强核心业务优势的重要举措。本次募投项目建成投产后，将有利于提升公司研发能力，进一步拓展产品类别，完善公司产品矩阵。公司技术积累将进一步增加，公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力将进一步增强。

二、本次募集资金投资项目的具体情况

（一）新型功率器件技术和产品研发及产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	新型功率器件技术和产品研发及产业化项目
实施主体	苏州东微半导体股份有限公司
项目总投资	54,772.31 万元
项目建设期	3 年
项目建设内容	项目将通过场地建设、购置先进研发测试及可靠性验证设备、引进高水平研发人才，完成新产品的的设计、流片、验证及量产导入。项目核心内容包括以下五个方向：①推动公司硅基功率器件向低电荷、低损耗方向迭代升级；②拓展 SiC 器件全电压等级产品，针对含 400V/800V 至 10kV 母线应用场景，重点研发 SiC JFET、SiC SuperJunction-MOSFET 等差异化产品；③推进 GaN HEMT 器件的研发与产业化；④前瞻布局氧化镓（Ga ₂ O ₃ ）等第四代半导体功率器件；⑤同步推进银烧结、双面散热、3D 集成等先进封装技术研发及 8 英寸 SiC 平台迁移。最终实现产品在数据中心电源、新能源汽车、光伏储能、工业电机驱动等目标市场的规模化销售。
项目建设地点	江苏省苏州市

2、项目必要性分析

（1）推进高端 SiC 功率器件国产化，保障产业链自主可控

当前，SiC 功率器件在数据中心电源、新能源汽车、固态变压器等领域被大量应用，但是此类 SiC MOSFET 器件仍然以英飞凌、安森美、意法半导体、罗姆、Wolfspeed 等

国外品牌为主，其国产化需求日益迫切。

公司在 SiC MOSFET 领域已取得关键进展，第二代、第三代 650V 和 1200V 平台多个产品已进入稳定交付阶段，1400V 及更高电压系列产品已通过客户测试并获得订单，650V/750V/1200V 第四代 SiC MOSFET 已进入量产爬坡阶段。本项目将继续拓展公司 SiC 器件从耐压 3300V 至 10kV 的各个平台，推进 SiC JFET、SiC Super Junction MOSFET 等差异化产品的研发，补充公司在高端 SiC 器件领域的产品布局，形成一系列超高耐压 SiC MOSFET 产品及低内阻 SiC JFET 产品，确保数据中心电源、固态变压器等领域的关键 SiC 器件的供应链安全。

（2）加速 GaN 功率器件产业化布局，抢占数据中心供电新赛道

相对于传统 Si 功率器件，GaN 功率器件具有更高的开关频率、更高功率密度以及更低的开关损耗等优点。根据 Yole Group 统计，全球功率氮化镓器件市场规模预计将由 2024 年的 3.55 亿美元增长至 2030 年的 30 亿美元，复合增长率约为 42%。近期，数据中心的蓬勃发展也迅速拉动了高密度电源系统的需求量，进而带动了 GaN 需求的快速增长。

截至 2025 年末，公司在低压 GaN HEMT 技术取得了阶段性突破，多个电压等级产品已完成扩充并积极推进客户验证。本项目将推动高压、中压、低压 GaN HEMT 器件研发及产业化，完善公司的 GaN 产品矩阵，以期把握数据中心电源市场快速增长的窗口期。

（3）前瞻布局第四代半导体氧化镓，抢占下一代技术制高点

随着传统硅基材料逐渐接近物理极限，氧化镓（ Ga_2O_3 ）作为第四代超宽禁带半导体材料，成为了功率半导体领域的重要前沿方向。从材料性能看， Ga_2O_3 禁带宽度约 4.8eV，击穿电场强度约 8MV/cm，其 Baliga 优值的理论极限约为 SiC 的 10 倍，可在相同耐压条件下实现更低导通电阻，适合应用于超高压电力电子系统，在高压电网、数据中心等领域有着广阔的应用前景。

2026 年，氧化镓已经在大尺寸衬底上实现了技术突破，预期未来 2-3 年其良率、一致性和可靠性等问题有望得到解决，并在工业电源、快充桩、电网等领域进入批量使用阶段。根据 Yole 预测，氧化镓也将成为功率半导体市场的主流材料之一。在产业化进程方面，国内多家企业已在积极布局第四代半导体材料及器件的研究与开发。为保持行

业竞争力，公司需前瞻性地布局以氧化镓为代表的第四代半导体技术。

公司已启动 Ga_2O_3 理论研究，并与高校合作完成 SBD 仿真验证，对 Ga_2O_3 衬底供应商进行了评估。本项目将推动公司从理论研究向原型器件的开发过渡，通过开发 SBD 和垂直 MOSFET 原型器件，建立 Ga_2O_3 器件自主设计与工艺能力，为第四代半导体产品进行技术布局，抢占下一代功率器件的技术制高点。

（4）推动硅基功率器件持续迭代，巩固优势产品市场地位

超级结 MOSFET 和中低压屏蔽栅 MOSFET 是公司当前的主要收入来源。2025 年度，公司超级结 MOSFET 产品实现了 9.17 亿元的营业收入，其占主营业务收入的 73.19%，同比增长 17.07%；中低压屏蔽栅 MOSFET 产品实现营业收入 2.71 亿元，占比 21.64%，同比增长 51.04%，二者合计贡献了公司 94.83% 的主营业务收入。

公司第四代超级结 MOSFET 已进入全面放量阶段，第五代产品已实现小批量交付，性能国内领先，第六代超级结 MOSFET 产品验证结果符合预期，研发工作取得阶段性进展；中低压屏蔽栅 MOSFET 方面，公司已优化 25V-200V 全规格段产品性能，相关 SGT 器件已在数据中心电源等领域实现销售。本项目将巩固并扩大公司在超级结 MOSFET 领域的市场地位，继续推动硅基功率器件迭代升级，持续提升器件的性能水平。

（5）推动先进封装技术研发，提升功率模块集成能力

功率模块作为电力电子装置的核心组件，通过将功率半导体器件和控制电路集成，实现电能的高效转换与智能控制。在数据中心算力电源和新能源汽车车载电源等领域，系统级厂商对高功率密度、高散热效率的功率模块需求日益迫切。随着数据中心单功率模块功率从 3kW 向 12kW 甚至更高功率演进和新能源汽车电驱系统功率密度的持续提升，模块化封装方案已成为系统级集成的发展趋势。

在封装技术方面，银烧结、双面散热、3D 集成、DBC/AMB 高导热基板等先进封装技术正成为行业竞争焦点。据 Yole Group 报告，先进封装技术可有效降低寄生参数，减少开关损耗，并通过多种智能保护机制实现设备小型化和高功率密度的同时大幅增强系统的可靠性与稳定性。目前，英飞凌等国际领先厂商已在其车规级功率模块和服务器电源模块中大规模采用银烧结和 DBC 基板技术，实现了优异的散热性能和可靠性。

本项目将重点推进银烧结、双面散热等先进封装技术的研发及产业化，形成覆盖全

电压等级的模块解决方案，进一步提升公司产品在高端市场的竞争力和客户粘性。

3、项目可行性分析

（1）政策可行性：高度契合国家产业导向

本项目覆盖硅基功率器件迭代升级、SiC/GaN 第三代半导体产业化以及氧化镓等第四代半导体前瞻布局，符合国家关于集成电路、先进材料、宽禁带半导体和未来产业的政策导向。“十五五”规划、2026 年政府工作报告、《关于推动能源电子产业发展的指导意见》《制造业可靠性提升实施意见》《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》等政策文件，均对集成电路、先进半导体、功率半导体器件、标准体系建设和可靠性提升等方向给予支持。同时，苏州工业园区深化开放创新综合试验等地方政策亦提出前瞻布局先进半导体技术及应用。项目所在地产业基础较好，政策环境与公司产品方向匹配，有助于公司围绕新型功率器件开展持续研发、产业化及客户导入。

（2）技术可行性：公司已建立扎实的研发基础与量产能力

公司在功率半导体领域具有超过十五年的技术积累，在产品和技术方面，公司第四代超级结 MOSFET 已规模化量产交付，第五代产品小批量交付，性能国内领先，第六代超级结 MOSFET 产品验证结果符合预期，研发工作取得阶段性进展；中低压屏蔽栅 MOSFET、IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT 及功率模块等方向均已有技术和产品积累。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已获得授权且尚在有效期内的专利共 202 项，其中包括 195 项发明专利、7 项实用新型专利，并获得国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业等荣誉，为本项目的研发和产业化提供了技术保障。

（3）市场可行性：市场持续放量、客户基础扎实，产能消化有充分支撑

本项目产品面向数据中心、新能源汽车、光伏储能、通信电源及工业电机驱动等增长较快的应用领域。根据 Frost&Sullivan 预测，2030 年服务器规模将达到约 1,950 万台，其中传统服务器未来规模基本保持稳定，算力服务器在 2025 年-2030 年期间将以 21.2% 的年复合增长率快速增长，成为带动市场规模增长的重要分支。随着当前算力需求的大幅提升，服务器机柜功率量级大幅攀升，传统低压供电存在电流、铜耗、多级损耗等物理瓶颈，800V 高压直流架构成为必然演进方向，在高压整流、高频降压、固态保护、固态变压器等环节均需大量 SiC/GaN 第三代功率器件，带来持续增量需求；而在中低压控制、驱动、辅助电源、信号处理等基础模块，成熟硅基芯片依靠规模化、高性价比

优势保障服务器整机基础供电与控制系统稳定运行，未来需求量也将同步增长。整体来看，新一代算力服务器供电系统形成“硅基打底、第三代半导体突破高端功率瓶颈”的产业格局，两类产品相互配套、共同受益于算力基础设施扩张红利。

新能源汽车和光储市场亦为功率器件提供了长期的需求支撑。根据 IEA 数据，2025 年全球电动汽车销量突破 2,000 万辆，预计 2026 年达到 2,300 万辆；根据中国汽车工业协会数据，中国 2025 年新能源汽车产销分别为 1,662.60 万辆和 1,649 万辆，新车销量占比达 47.90%。光伏储能方面，根据国家能源局数据，2025 年全国光伏新增并网容量 3.17 亿千瓦，根据 CNESA 数据，在理想场景下，2030 年中国新型储能累计装机规模将达到 450.7GW，2026-2030 年复合年增长率为 25.5%。

公司已在 5G 基站电源、数据中心服务器电源、车载充电机、新能源汽车直流充电桩、光伏逆变及储能、电机驱动等领域积累了中兴康讯、北斗星电子、思格新能源、升华电源、特来电、优必选等客户。现有客户群体与募投项目产品应用场景重合度较高，有助于新产品验证导入和新增产能消化。此外，公司通过“经销+直销”相结合的销售模式，已建立了广泛的客户网络和供应链体系，可有效保障新增产能的消化。

（4）供应链可行性：与头部代工厂建立长期稳定协同合作关系

公司采用 Fabless 模式，通过与晶圆制造和封装测试厂商建立长期合作保障供应链稳定。在晶圆代工端，公司与华虹宏力、粤芯半导体、DB HiTek 等代工厂保持稳定的技术与业务合作；为保障第三代半导体产品研发与产能，公司亦与多家 SiC 代工厂开展合作，并通过前瞻性采购策略应对产能周期波动。在封测端，公司通过整合供应链资源，与合作伙伴共同开发了适用于不同产品特性的封装方案和测试技术。

公司具备硅基功率器件在 8 英寸、12 英寸产线的量产经验，以及 SiC 器件从 6 英寸到 8 英寸的技术转移能力，这些均为本项目的顺利实施提供了技术基础。同时，公司多年以来持续协同代工厂合作伙伴进行多种创新性的工艺流程开发，实现了双方技术能力的共同提升。公司与产业上下游的深度协同能力，可以为本次募投项目的顺利开展提供坚实的产业链上的保障。

4、项目实施和投资概算

本项目总投资额 54,772.31 万元，具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建设投资	7,623.00	13.92%
1.1	建筑工程	1,680.00	3.07%
1.2	硬件设备购置费用	5,343.00	9.75%
1.3	软件购置费用	600.00	1.10%
2	研发开发费用	44,921.84	82.02%
2.1	人员费用	3,971.84	7.25%
2.2	开发费用	40,950.00	74.76%
3	铺底流动资金	2,227.47	4.07%
4	项目总投资	54,772.31	100.00%

5、项目建设进度安排

本项目建设期为 36 个月，项目实施进度安排具体如下：

序号	项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	建筑工程及装修	*	*	*	*	*	*	*	*				
2	设备购置与安装调试		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3	人员的招聘与培训		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	产品研发		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	产品测试及试产									*	*	*	*

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司或市场同类型产品的销售单价为基准，基于谨慎性原则，完全达产年度预计销售收入为 145,717.50 万元。

本项目的成本主要包括产品的晶圆成本、加工成本，系参照公司或市场同类型产品成本占比确定。销售费用系参考公司历史销售费用占比确定，管理费用系参考房屋建筑物折旧摊销费、公司历史管理费用占比确定，研发费用系根据项目相关的人员成本、折旧摊销费、公司历史研发费用占比确定。折旧摊销费用按平均年限法计算：房屋建筑物按 20 年折旧，残值率 3%；硬件设备按 5 年折旧，残值率 3%；软件按 5 年摊销，残值

率 0%。

增值税进项税额中房屋建筑物产生的进项税按照 9%测算，设备软件和直接材料采购产生的进项税按照 13%测算，公司销售产品产生的销项税按 13%测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；企业所得税率按 15%测算。

经测算，本项目税后财务内部收益率为 15%，项目税后静态投资回收期为 8.02 年（含建设期），具有良好的经济效益。

7、项目土地、备案、环评事项及进展情况

本项目已取得土地证，土地证号为苏（2026）苏州工业园区不动产权第 0000077 号，项目用地为国有出让工业用地。本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：苏园行审备〔2026〕886 号），已取得《苏州工业园区建设项目环境影响评价与排污许可审批意见》（H20260167）。

（二）新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目

1、项目基本情况

项目名称	新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目
实施主体	苏州东微半导体股份有限公司
项目总投资	45,897.87 万元
项目建设期	3 年
项目建设内容	项目将通过场地建设、购置先进研发测试及可靠性验证设备、引进高水平研发人才，完成新产品的的设计、流片、验证及量产导入。项目拟研发新一代功率管理控制芯片，包括：①数字电源 DSP/MCU；②48V IBC（中间母线转换器）数字控制器；③备份电源（BBU）数字控制器；④48V 系统热插拔/eFuse 控制器、高压固态断路器控制器；⑤800V 高压系统辅助电源 IC；⑥配套功率器件的栅极驱动 IC。
项目建设地点	江苏省苏州市

2、项目必要性分析

（1）打破国外垄断，实现高端电源管理控制芯片自主可控

高端功率管理控制芯片是数据中心供电系统、新能源汽车电源管理、高端工业电源等关键设施的核心部件。目前，数据中心供电控制、数字电源 DSP、高可靠性栅极驱动等高端控制芯片领域长期由国外厂商主导，比如其中 48V IBC 数字控制器市场绝大部分份额由英飞凌 XDP 系列占据，其他数字电源 DSP 领域则长期以德州仪器（TI）C2000 系列为主，英飞凌与德州仪器均建立了极高的市场壁垒。

从国产化角度看，在中高端产品领域国际厂商仍占据较大份额，进口替代市场空间广阔。电源管理芯片国产替代虽在快充等中低端领域加速，但在数据中心、车规级和高端工业电源和电机驱动场景仍存在一定短板。在全球地缘政治及国际贸易政策环境不断变化的背景下，关键控制芯片的供应链风险日益突出，一旦国际供应链受阻，将直接威胁我国数据中心、通信基站、新能源汽车、新型电网等关键基础设施的建设和运行安全。

本项目拟研发 48V IBC 数字控制器、数字电源 DSP、智能 eFuse/热插拔控制器、高压固态断路器控制芯片等产品，对标英飞凌 XDP 系列和 TI C2000 系列等国际主流产品。项目的实施将填补高端控制芯片领域的技术空白，大幅提升公司高端功率管理控制芯片的自研供给能力，稳固产品供应链稳定性，进一步增强企业核心竞争力，为公司拓展集成电路业务版图、巩固行业市场地位打下坚实基础。

（2）构建“IC+功率”系统级方案，提升客户粘性与单客户价值

数据中心电源、新能源汽车电驱系统等应用场景对效率、功率密度和可靠性要求较高，客户需求正在从分立采购功率器件和控制芯片，转向能够深度协同的“控制-驱动-执行”一体化解决方案。若客户需分别采购功率器件、控制芯片和栅极驱动 IC，将面临兼容性验证复杂、调试周期较长、多供应商协同困难等问题。

根据 Yole Group 报告，全球功率电子市场 2024 至 2030 年预计以 8.7% 的复合增长率稳步回升。在国际竞争中，德州仪器、英飞凌等厂商均已形成“控制+驱动+执行”的系统级产品矩阵，实现垄断通信基站、无人机等领域的高端电源管理芯片、栅极驱动等芯片供应。公司已具备 MOSFET、TGBT、SiC、GaN 等功率器件基础，本项目补齐控制芯片和驱动 IC 能力后，公司将进一步提升方案完整性、客户粘性和单客户价值量。

（3）抢占数据中心及高压供电系统的新兴市场

当前数据中心建设提速带动服务器功率密度和供电效率要求持续提升，推动高端电

源及配套数字电源 IC 市场需求快速增长。根据 Global Growth Insights 数据，全球数字电源 IC 市场规模在 2025 年约为 672.90 亿美元，预计到 2035 年将扩张至 2,867.80 亿美元，预测期复合年增长率约 15.60%。数据中心 48V IBC 控制器、数字热插拔控制器、高压固态断路器控制芯片等产品作为电源模组价值量最高的核心部件之一，正处于市场爆发初期，增长潜力巨大。

在当前算力走向高密度、连续满载、强瞬态冲击之后，高压架构是数据中心供电系统发展的确定方向，高压供电系统对 IBC 控制器、数字热插拔控制器、高压固态断路器控制芯片等配套控制芯片需求将持续增加。若错失当前市场窗口期，公司将面临更为激烈的国际竞争和更高的客户导入壁垒，一旦国外厂商的下一代产品完成市场覆盖，客户将更加难以替换。本项目产品精准卡位 IBC 控制器、数字热插拔控制器、高压固态断路器控制芯片、电源 DSP 等高增长、高壁垒赛道，有助于公司在市场蓝海阶段建立先发优势，快速形成收入。通过抢先获得头部客户的验证和导入，公司有望在全球功率管理控制芯片市场中占据一席之地。

（4）发挥技术与产业链协同优势，延伸公司价值链条

公司对 MOSFET、IGBT、SiC、GaN 等各类功率器件的动态特性、开关损耗和驱动需求具有较深理解。根据 Global Growth Insights 数据，全球栅极驱动 IC 市场规模预计到 2035 年达到约 22.20 亿美元。公司对功率器件的认知有助于开发更匹配功率管特性的栅极驱动 IC 和控制芯片，降低开关损耗、提升系统效率。

在封装技术方面，公司已在高密度功率模块领域取得进展，模块产品可应用于算力服务器电源、车载 OBC、主驱电控、车载热管理系统等领域；供应链方面，公司采用 Fabless 模式，与华虹宏力、粤芯半导体等代工厂保持稳定合作，控制芯片产品采用 55nm-180nm 成熟制程，具备较好的代工和封测基础。本项目将进一步完善公司的产品生态，从单一功率器件供应商升级为“控制—驱动—执行”全链路系统解决方案提供商，显著提升公司在产业链中的价值地位和议价能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

3、项目可行性分析

（1）政策可行性：高度契合国家产业导向，获得多维度政策支持

本项目聚焦功率管理控制芯片研发及产业化，属于集成电路设计领域核心环节，符合国家关于集成电路关键核心技术攻关的政策方向。“十五五”规划、2026 年政府工作

报告以及《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035 年）》等政策，均强调推动集成电路等重点领域关键技术突破和标准体系建设。

商务部于 2024 年 11 月发布的《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》，明确支持苏州工业园区建设未来产业创新试验区，前瞻布局先进半导体技术及应用等重点产业。

在财税金融和人才方面，高新技术企业税收优惠、集成电路企业所得税减免、研发费用加计扣除、数字人才培养等政策为公司开展高端控制芯片研发提供外部支持。

综上所述，本项目契合各级产业扶持政策导向，能够享受相应的配套扶持举措，项目落地具备良好的政策条件。

（2）市场可行性：下游需求旺盛，国产替代空间巨大

功率管理控制芯片市场总体空间广阔。根据行业研究数据，2025 年全球电源管理集成电路（PMIC）市场规模达到 1,837.37 亿元人民币，中国市场达到 562.24 亿元人民币。

数据中心电源控制芯片需求快速增长。全球服务器电源芯片市场预计将从 2025 年的 3.26 亿美元增长至 2032 年的 7.91 亿美元；数据中心服务器功率模块市场扩张，将直接带动 IBC 数字控制器、数字热插拔控制器、智能 eFuse 等控制芯片需求。

在栅极驱动 IC 市场，随着 SiC 和 GaN 器件的快速普及，配套驱动芯片需求同步增长。根据 Global Growth Insights 数据，全球栅极驱动 IC 市场 2025 年市场规模为 13.60 亿美元，预计到 2035 年市场规模将达到约 22.20 亿美元。本项目研发的配套栅极驱动 IC 产品，将直接受益于 SiC 和 GaN 器件渗透率提升带来的增量市场。

国内数据中心服务器电源、车载充电机、新能源汽车等领域的厂商对供应链自主可控的要求日益提高，对国产高端控制芯片的验证和导入意愿强烈，公司凭借优秀的半导体器件与工艺创新能力，已获得上述领域重要客户的认可。本项目的控制芯片产品未来市场需求广阔，产品可依托公司现有销售渠道和客户资源快速导入市场，验证周期较新进入者有望大幅缩短，产能消化具有明确的市场支撑。

（3）技术可行性：公司已提前储备了扎实的数字芯片设计能力与研发基础

2025 年起，公司持续开展 IC 领域人才储备，不断壮大专业研发团队，并于 2026

年完成对深圳慧能泰的战略性收购整合，形成混合信号处理与数字控制环路设计、高精度 ADC/DAC、多种通信接口、高压辅助电源设计、栅极驱动 IC 设计等能力。

在产品进展方面，公司已有多款数字电源 DSP 产品获得客户验证，IBC 数字控制器开发取得实质性进展，超高压 1700V 辅助电源 IC 已基本完成验证。公司已形成覆盖超级结 MOSFET、中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT 及高密度功率模块的完整产品矩阵。公司现有功率器件产品矩阵和对器件特性的理解，支撑控制芯片与功率器件的系统级协同优化，凭借“对功率器件的深刻理解+数字芯片设计能力”这一独特组合，公司的控制芯片产品有望在系统级优化方面形成突出优势。本项目依托公司的人才、技术储备和对产品的深刻理解，具有技术可行性。

（4）供应链可行性：Fabless 模式与代工厂深度协同，封测产能保障充分

公司采用 Fabless 经营模式，专注芯片设计研发和质量管理，将晶圆制造、封装和测试委外给专业厂商完成，有利于将资源集中于设计与产品迭代。本项目控制芯片产品主要采用 55nm 至 180nm 成熟制程，公司与华虹宏力、粤芯半导体、DB HiTek 等代工厂已建立长期稳定合作，上述制程段工艺成熟、产能相对充足。

在封装测试端，公司与头部封测企业保持协同，可根据不同产品特性共同开发封装方案和测试策略。控制芯片与公司现有功率器件在封装和系统集成层面具有协同效应，相关经验可迁移至控制芯片和驱动 IC 封装方案设计，从而降低项目实施风险。

4、项目实施和投资概算

本项目总投资额 45,897.87 万元，具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建设投资	9,381.47	20.44%
1.1	建筑工程	1,880.00	4.10%
1.2	硬件设备购置费用	4,812.00	10.48%
1.3	软件购置费用	2,689.47	5.86%
2	研发费用	33,374.40	72.71%
2.1	人员费用	4,934.40	10.75%
2.2	开发费用	28,440.00	61.96%
3	铺底流动资金	3,142.00	6.85%
4	项目总投资	45,897.87	100.00%

5、项目建设进度安排

本项目建设期为 36 个月，项目实施进度安排具体如下：

序号	项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	建筑工程及装修	*	*	*	*	*	*	*	*				
2	设备购置与安装调试		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
3	人员的招聘与培训		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
4	产品研发		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
5	产品测试及试产									*	*	*	*

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

本次募投项目预计所有收入全部来源于产品销售收入，本项目营业收入的测算系以公司或市场同类型产品的销售单价为基准，基于谨慎性原则，完全达产年度预计销售收入为 60,835.00 万元。

本项目的成本主要包括产品的晶圆成本、加工成本，系参照公司或市场同类型产品成本占比确定。销售费用系参考公司历史销售费用占比确定，管理费用系参考房屋建筑物折旧摊销费、公司历史管理费用占比确定，研发费用系根据项目相关的人员成本、折旧摊销费、公司历史研发费用占比确定。折旧摊销费用按平均年限法计算：房屋建筑物按 20 年折旧，残值率 3%；硬件设备按 5 年折旧，残值率 3%；软件按 5 年摊销，残值率 0%。

增值税进项税额中房屋建筑物产生的进项税按照 9%测算，设备软件和直接材料采购产生的进项税按照 13%测算，公司销售产品产生的销项税按 13%测算；城市维护建设税、教育费附加税、地方教育附加税分别按照增值税的 7%、3%、2%进行计提；企业所得税率按 15%测算。

经测算，本项目税后财务内部收益率为 13%，项目税后静态投资回收期为 7.96 年（含建设期），具有良好的经济效益。

7、项目土地、备案、环评事项及进展情况

本项目已取得土地证，土地证号为苏（2026）苏州工业园区不动产权第 0000077 号，项目用地为国有出让工业用地。本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：苏园行审备〔2026〕887 号），已取得《苏州工业园区建设项目环境影响评价与排污许可审批意见》（H20260167）。

（三）研发中心建设项目

1、项目基本情况

项目名称	研发中心建设项目
实施主体	苏州东微半导体股份有限公司
项目总投资	32,918.00 万元
项目建设期	36 个月
项目建设内容	本项目拟在江苏省苏州市建设公司新一代研发中心，系统升级研发测试基础设施和技术平台。项目建设内容主要包括以下三个方向： ①CNAS/可靠性/器件应用实验室升级。按照 CNAS 标准建设可靠性实验室，配置 DHTOL（高温工作寿命测试系统）、HTFB（高温正偏测试系统）、PC（功率循环测试系统）、H3TRB（高温高湿反偏测试系统）、HAST（高加速应力测试系统）、双脉冲测试系统等关键测试设备，扩充 SiC/GaN 第三代半导体器件全参数可靠性测试能力。同步建设器件应用实验室，配备高精度半导体参数分析仪、热阻测试仪、雪崩能量测试系统等先进测试设备，支撑新产品的全面性能评估与应用验证。 ②TO-247 快速封装验证产品线建设。建设适配中大功率器件的 TO-247 封装快速打样验证产线，打通从晶圆减薄、划片、焊接、键合到塑封、测试的全流程封装验证能力，填补 Fabless 模式下“中试”环节的空白，加速新产品从设计验证到量产导入的转化进程。 ③IC 模组实验室建设。建设面向高密度功率模组研发的 IC 模组实验室，配套功率模组设计仿真平台、热管理测试系统、电磁兼容测试系统及可靠性验证设备，支撑公司从功率器件到系统级模组的一体化研发能力构建
项目建设地点	江苏省苏州市

2、项目必要性分析

（1）系统性提升器件可靠性验证能力，突破车规级认证瓶颈

第三代半导体器件是公司未来业务增长的关键引擎。然而，第三代半导体器件因其宽禁带材料特性和高频高压应用场景，对可靠性测试提出了远高于硅基器件的严苛要求，

包括更宽温度范围下的功率循环测试、更高电压等级下的高温反偏测试、更长时间的高温高湿反偏测试等。

目前，公司在 SiC 器件的车规级可靠性测试方面对外部第三方测试机构依赖度较高，测试排期受限于外部资源、验证周期较长，而且在产品开发初期快速迭代阶段的测试灵活性不足。通过扩充 CNAS 标准可靠性实验室并配置 DHTOL、HTFB、PC、H3TRB、HAST、双脉冲测试等关键设备，公司将具备覆盖器件全参数、全工况的车规级可靠性自测能力，有效突破车规认证瓶颈，加速产品在整车客户端的导入进程。

（2）填补封装测试环节空白，加速新产品产业化周期

作为采取 Fabless 模式的功率器件设计公司，新产品在晶圆制造完成后，需通过封测厂进行封装试制和初步测试，受封测厂产线排期、产能分配及技术沟通效率等因素影响，单次封装验证周期往往需要数周甚至更长时间，若验证结果不理想则需要多轮迭代，显著延长了新产品的研发周期。

本项目的快速封装验证产线建设，将使公司在内部完成从晶圆减薄、划片、焊接、键合到塑封、测试的全流程封装验证，实现“当天设计、当天封装、当天测试”的快速迭代能力。这不仅将大幅缩短新产品从设计定型到量产导入的周期，降低对外部封测资源的依赖和试错成本，更将显著提升公司对下游客户需求的快速响应能力，在竞争日益激烈的功率半导体市场中建立时间优势。

（3）构建模组级研发能力，支撑高密度功率模组业务拓展

功率模组是公司产品向高附加值方向延伸的核心方向，也是公司从单一器件供应商向系统级方案提供商转型升级的关键载体。随着数据中心电源和新能源汽车电驱系统对功率密度的要求持续提升，功率模组的设计复杂度不断增加，研发过程中对模组级仿真、测试和验证能力的需求日益迫切。

目前，公司的功率模组研发在模组级热管理测试、电磁兼容验证和系统级可靠性评估等方面仍存在一定短板，研发效率和验证充分性有待提高。本项目通过建设模组实验室，配备模组设计仿真平台、热管理测试系统、电磁兼容测试系统及可靠性验证设备，可显著提升功率模组产品的研发效率、技术水平和市场竞争力，为公司功率模组业务的规模化发展提供有力支撑。

（4）升级研发基础设施，增强核心人才吸引力

研发人才是功率半导体设计公司的核心资产，先进完善的研发测试基础设施是吸引和留住高端研发人才的关键条件。当前，公司在功率器件设计、第三代半导体器件开发、控制芯片设计等方向持续加大研发投入，研发团队规模快速扩充，对研发实验场地、测试设备和仿真平台的需求持续增长。现有的研发办公空间和测试场地容量已趋于饱和，部分先进测试设备尚待补充配置。

通过本项目的实施，公司将扩充高标准的 CNAS 可靠性实验室、封装验证产线和功率模组、IC 功率器件合封模组实验室，同时完成研发场地的扩容升级。良好的研发环境和先进的实验条件将显著增强公司对高端技术人才的吸引力，为公司在功率半导体领域持续保持技术竞争优势提供坚实的人才保障。

3、项目可行性分析

（1）企业自身实力雄厚，为研发中心建设提供坚实保障

公司作为国内领先的功率器件设计企业，在资金实力、客户资源、管理能力等方面具备开展本项目的坚实基础。在资金层面，截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产 337,155.40 万元，归属于上市公司股东的净资产 302,382.76 万元，财务状况稳健，具备充足的资金保障能力支持本项目的建设投入。

在客户资源层面，公司深耕高性能功率器件领域多年，已积累较为丰富且优质的客户资源，并与下游新能源、光伏储能、数据中心、工业电源、消费电子等领域客户建立了稳定合作关系。上述客户群体应用场景多元、产品迭代需求持续，为研发中心的测试能力布局和研发方向选择提供了明确的市场导向，也保障了研发成果的高效产业化转化。

在管理层面，公司于 2022 年 2 月在上海证券交易所科创板上市，建立了完善的法人治理结构和内部控制体系，具备规范的研发管理、财务管理和项目管理能力，能够有效统筹推进研发中心建设、设备采购、人才招聘等各项工作的开展。

（2）技术基础扎实，具备研发平台建设与运行的核心能力

公司长期深耕高性能功率器件研发，在超级结 MOS、屏蔽栅 MOS、原创 Tri-gate IGBT、SiC 宽禁带半导体领域形成多项独家器件结构与工艺专利，搭建覆盖多电压等级、多应用场景的完整产品研发平台，配套自有可靠性测试实验室保障新品快速验证落地。公司多品类器件拥有原创核心技术，产品矩阵全覆盖高端高景气赛道，核心研发团队具备国际一线半导体企业产业化经验，持续强化差异化技术壁垒与产品商业化转化能力。

在研发团队方面，公司拥有一支高素质的技术研发团队，核心技术人员均具有丰富的功率器件设计、工艺开发和测试验证经验。截至 2026 年 6 月 30 日，公司研发人员数量为 113 名，占员工总数的 41.09%，持续研发投入和团队扩充为项目实施提供基础，为研发中心的建设和运行提供了有力的技术人才支撑。

在标准认证方面，公司对 CNAS 实验室认证标准和质量体系要求有深入了解，具备按照 CNAS 标准建设和管理可靠性实验室的能力。在封装技术方面，公司在高密度功率模块封装领域已积累了先进封装技术经验，为快速封装验证产线的建设提供了技术基础。在模组开发方面，公司的高密度功率模块产品已在算力服务器电源、车载 OBC 等应用领域逐步量产，积累了丰富的模组设计、测试和应用经验，为模组实验室的建设提供了直接的技术储备。

（3）市场需求旺盛，为研发成果转化提供广阔空间

本项目对应的研发能力提升方向均具有旺盛的下游市场需求和广阔的发展前景，为研发成果的快速产业化提供了坚实保障。

在可靠性测试方面，随着数据中心电源对功率器件长期工作寿命要求的提升，以及新能源汽车 800V 高压平台对车规级 SiC 器件可靠性的严苛要求，具备 CNAS 认证资质的自建可靠性测试能力将直接服务于公司新产品的客户认证和导入进程。公司现有客户群体对供应链自主可控的要求日益提高，具备车规级可靠性自测能力的供应商在客户导入过程中将具有显著的竞争优势。

在封装验证方面，快速封装验证能力的建设将直接支撑公司多产品线（超级结 MOSFET、SiC MOSFET、GaN HEMT、TGBT 等）的快速迭代开发。据行业趋势判断，功率器件产品迭代周期正在缩短，快速封装验证能力将成为提升新产品上市速度的关键竞争要素。

在功率模组方面，根据 QYResearch 数据，2024 年全球数据中心用功率半导体器件市场规模约为 5.34 亿美元，预计 2031 年将达到 12.40 亿美元，2025-2031 期间年复合增长率为 11.0%，其中电源供应单元和电压调节模块占数据中心服务器功率半导体需求的比重较高。公司高密度功率模块产品线已在算力服务器电源、车载 OBC、主驱电控等领域逐步量产，模组实验室的建成将进一步提升公司功率模组产品的技术水平和迭代速度，充分受益于下游市场需求扩张。

（4）政策支持有力，为研发中心建设提供良好环境

我国及地方政府高度重视半导体产业的高质量发展，出台了一系列针对性扶持政策，为公司建设研发中心提供了良好的政策环境。在国家层面，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》将集成电路列为重点突破领域，《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》从财税、投融资、研究开发等多维度对集成电路企业给予系统性支持。工业和信息化部等五部门印发的《制造业可靠性提升实施意见》明确支持企业加强可靠性测试能力建设，提升核心基础零部件和元器件的可靠性水平。

4、项目实施和投资概算

本项目总投资额 32,918.00 万元，具体投资明细如下：

序号	项目	项目资金（万元）	占比
1	建设投资	18,506.00	56.22%
1.1	建筑工程	5,568.00	16.91%
1.2	硬件设备购置费用	12,098.00	36.75%
1.3	软件购置费用	840.00	2.55%
2	研发费用	14,412.00	43.78%
2.1	人员费用	6,611.00	20.08%
2.2	研发试验费	4,097.00	12.45%
2.3	合作开发费	2,698.00	8.20%
2.4	专利费用	1,006.00	3.06%
3	项目总投资	32,918.00	100.00%

5、项目建设进度安排

序号	项目	T+1 年				T+2 年				T+3 年			
		Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
1	建筑工程及装修	*	*	*	*								
2	设备购置与安装调试		*	*	*								
3	人员的招聘与培训		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
4	研发专题实施		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

6、效益预测的假设条件及主要计算过程

本项目为研发类项目，不适用项目经济效益分析。

7、项目土地、备案、环评事项及进展情况

本项目已取得土地证，土地证号为苏（2026）苏州工业园区不动产权第 0000077 号，项目用地为国有出让工业用地。本项目已取得《江苏省投资项目备案证》（备案证号：苏园行审备（2026）888 号），已取得《苏州工业园区建设项目环境影响评价与排污许可审批意见》（H20260167）。

（四）补充流动资金

1、项目基本情况

除上述项目外，为满足公司业务发展对流动资金的需求，公司拟使用本次募集资金中的 10,000.00 万元补充公司流动资金。

2、项目实施的必要性和合理性

近年来，公司业务保持快速发展，收入和资产规模稳步提升。随着业务规模的扩大，公司仅依靠内部经营积累和间接融资较难满足业务扩张对营运资金的需求。本次公司拟将募集资金中的 10,000.00 万元用于补充流动资金，符合公司所处行业发展现状及公司业务发展需求。募集资金到位后，公司营运资金需求将得到有效满足，资产结构更加稳健，可进一步提升公司的整体抗风险能力，保障公司持续稳定发展，具备必要性和合理性。

3、项目实施的可行性

（1）本次向不特定对象发行可转债募集资金用于补充流动资金符合法律法规的规定，本次募集资金部分用于补充流动资金符合《上市公司证券发行注册管理办法》《证券期货法律适用意见第 18 号》中关于募集资金使用的相关规定，方案切实可行。本次发行的部分募集资金用于补充流动资金，符合公司当前的实际发展情况以及所处行业发展的相关产业政策和行业现状，有利于增强公司的资本实力，满足公司经营规模快速增长的需求，为公司未来业务的发展提供资金支持，推动公司长期持续稳定发展。

（2）公司内部治理规范，内控完善

公司已根据相关法律、法规和规范性文件的规定，建立了有效的法人治理结构和内

部控制环境。为规范募集资金的管理和运用，公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、用途以及管理与监督等方面做出了明确的规定。

4、公司流动资金需求测算

2023年至2025年，公司营业收入和业务规模取得显著增长，实现营业收入分别为97,285.03万元、100,322.00万元、125,268.76万元，2023年至2025年年复合增长率达到13.47%，2026年上半年营业收入较同期增长19.58%。充分考虑公司业务发展、下游市场需求、公司行业地位、未来战略规划等，2026年至2029年预测期公司营业收入增长率按13.47%估算。根据公司的营业收入预测，按2023年末、2024年末、2025年末应收票据、应收账款、应收款项融资、预付款项、存货、应付票据、应付账款、合同负债、其他应收款、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款占营业收入的百分比的平均值进行测算，2027年至2029年，公司流动资金缺口为31,268.41万元，具体测算如下：

单位：万元

项目	2025年	2026年（E）	2027-2029年平均销售百分比	2027年（E）	2028年（E）	2029年（E）
营业收入	125,268.76	142,142.46	-	161,289.05	183,014.68	207,666.76
应收票据	4,842.25	6,717.83	4.73%	7,622.72	8,649.50	9,814.59
应收账款	15,514.40	19,188.64	13.50%	21,773.35	24,706.22	28,034.15
应收款项融资	2,002.26	2,371.22	1.67%	2,690.62	3,053.05	3,464.30
预付款项	3,598.61	2,286.40	1.61%	2,594.37	2,943.84	3,340.37
其他应收款	24.47	402.43	0.28%	456.64	518.15	587.95
存货	54,789.84	54,330.26	38.22%	61,648.54	69,952.60	79,375.21
经营性流动资产合计	80,771.83	85,296.78	60.01%	96,786.25	109,823.36	124,616.57
应付票据	-	-	0.00%	-	-	-
应付账款	8,775.57	14,938.74	10.51%	16,950.99	19,234.29	21,825.14
预收账款	-	-	0.00%	-	-	-
合同负债	52.26	229.06	0.16%	259.91	294.92	334.65
应付职工薪酬	1,821.27	1,784.17	1.26%	2,024.50	2,297.20	2,606.64
应交税费	51.16	39.66	0.03%	45.00	51.06	57.94
其他应付款	1,083.00	474.30	0.33%	538.19	610.68	692.94
经营性流动负债合计	11,783.25	17,465.93	12.29%	19,818.59	22,488.15	25,517.31
流动资金占用额	68,988.58	67,830.85	47.72%	76,967.66	87,335.21	99,099.26
流动资金需求		-	-	9,136.82	10,367.54	11,764.05

项目	2025 年	2026 年（E）	2027-2029 年平均 销售百分比	2027 年（E）	2028 年（E）	2029 年（E）
流动资金需求合计				31,268.41		

注：上述测算仅以测算流动资金缺口为目的，并不构成公司未来盈利预测。

公司本次拟使用募集资金补充流动资金金额为 10,000 万元，低于公司 2027 年至 2029 年流动资金缺口，本次募投项目补充流动资金具有合理性。

三、本次募集资金用于研发投入的情况

本次募投项目新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目均涉及研发投入，具体情况如下：

（一）研发投入的主要内容及技术可行性

1、新型功率器件技术和产品研发及产业化项目

（1）项目主要内容

项目将通过场地建设、购置先进研发测试及可靠性验证设备、引进高水平研发人才，完成新产品的的设计、流片、验证及量产导入。项目核心内容包括以下五个方向：①推动公司硅基功率器件向低电荷、低损耗方向迭代升级；②拓展 SiC 器件全电压等级产品，针对含 400V/800V 至 10kV 母线应用场景，重点研发 SiC JFET、SiC SuperJunction-MOSFET 等差异化产品；③推进 GaN HEMT 器件的研发与产业化；④前瞻布局氧化镓（Ga₂O₃）等第四代半导体功率器件；⑤同步推进银烧结、双面散热、3D 集成等先进封装技术研发及 8 英寸 SiC 平台迁移。最终实现产品在数据中心电源、新能源汽车、光伏储能、工业电机驱动等目标市场的规模化销售。

（2）技术可行性

本项目的技术可行性参见本节之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）新型功率器件技术和产品研发及产业化项目”之“3、项目可行性分析”之“（2）技术可行性：公司已建立扎实的研发基础与量产能力”。

2、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目

（1）项目主要内容

项目将通过场地建设、购置先进研发测试及可靠性验证设备、引进高水平研发人才，完成新产品的的设计、流片、验证及量产导入。项目拟研发新一代功率管理控制芯片，包

括：①数字电源 DSP/MCU；②48V IBC（中间母线转换器）数字控制器；③备份电源（BBU）数字控制器；④48V 系统热插拔/eFuse 控制器、高压固态断路器控制器；⑤800V 高压系统辅助电源 IC；⑥配套功率器件的栅极驱动 IC。

（2）技术可行性

本项目的技术可行性参见本节之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（二）新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目”之“3、项目可行性分析”之“（3）技术可行性：公司已提前储备了扎实的数字芯片设计能力与研发基础”。

3、研发中心建设项目

（1）项目主要内容

本项目拟在江苏省苏州市建设公司新一代研发中心，系统升级研发测试基础设施和技术平台。项目建设内容主要包括以下三个方向：

①CNAS/可靠性/器件应用实验室升级。按照 CNAS 标准建设可靠性实验室，配置 DHTOL（高温工作寿命测试系统）、HTFB（高温正偏测试系统）、PC（功率循环测试系统）、H3TRB（高温高湿反偏测试系统）、HAST（高加速应力测试系统）、双脉冲测试系统等关键测试设备，扩充 SiC/GaN 第三代半导体器件全参数可靠性测试能力。同步建设器件应用实验室，配备高精度半导体参数分析仪、热阻测试仪、雪崩能量测试系统等先进测试设备，支撑新产品的全面性能评估与应用验证。

②TO-247 快速封装验证产品线建设。建设适配中大功率器件的 TO-247 封装快速打样验证产线，打通从晶圆减薄、划片、焊接、键合到塑封、测试的全流程封装验证能力，填补 Fabless 模式下“中试”环节的空白，加速新产品从设计验证到量产导入的转化进程。

③IC 模组实验室建设。建设面向高密度功率模组研发的 IC 模组实验室，配套功率模组设计仿真平台、热管理测试系统、电磁兼容测试系统及可靠性验证设备，支撑公司从功率器件到系统级模组的一体化研发能力构建。

（2）技术可行性

本项目的技术可行性参见本节之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（三）研发中心建设项目”之“3、项目可行性分析”之“（2）技术基础扎实，具备研发平台

建设与运行的核心能力”。

（二）研发预算及时间安排

（1）新型功率器件技术和产品研发及产业化项目预算总投入 54,772.31 万元，其中研发投入 44,921.84 万元，费用构成和项目时间安排，参见本节之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）新型功率器件技术和产品研发及产业化项目”之“4、项目实施和投资概算”和“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（一）新型功率器件技术和产品研发及产业化项目”之“5、项目建设进度安排”。

（2）新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目预算总投入 45,897.87 万元，其中研发投入 33,374.40 万元，费用构成和项目时间安排，参见本节之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（二）新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目”之“4、项目实施和投资概算”和“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（二）新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目”之“5、项目建设进度安排”。

（3）研发中心建设项目预算总投入 32,918.00 万元，其中研发投入 14,412.00 万元，费用构成和项目时间安排，参见本节之“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（三）研发中心建设项目”之“4、项目实施和投资概算”和“二、本次募集资金投资项目的具体情况”之“（三）研发中心建设项目”之“5、项目建设进度安排”。

（三）目前研发投入及进展

公司目前研发投入及进展详见本募集说明书“第四节 发行人基本情况”之“十一、与公司产品有关的技术情况”相关内容。

（四）预计未来研发费用资本化情况

本次募投项目不涉及研发费用资本化。

（五）已取得及预计取得的研发成果

公司在高性能功率器件和 IC 产品领域具有竞争优势，已掌握 12 项核心技术均应用于公司主营业务。截至 2026 年 6 月 30 日，公司已获得授权且尚在有效期内的专利共 202 项，其中包括 195 项发明专利、7 项实用新型专利。

本次募投项目建成后，将显著增强公司在高端功率半导体领域的技术壁垒和产品供应能力，助力国产替代进程。新型功率器件技术和产品研发及产业化项目实施后公司将

持续提升新型功率器件的研发深度和产品化能力，完善面向数据中心电源、新能源汽车、光伏储能、工业电机驱动等应用领域的技术和产品储备。新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目实施后，公司将在现有功率器件基础上，扩展 48V IBC 数字控制器、数字电源 DSP、智能 eFuse 控制器、高压固态断路器控制芯片等产品。研发中心建设项目实施后将为公司研发项目提供全流程的可靠性验证支撑、封装测试保障和模组级研发平台。

四、本次募集资金投资于科技创新领域的说明，以及募投项目实施促进公司科技创新水平提升的方式

（一）本次募集资金主要投向科技创新领域

公司专注于高性能功率半导体的研发和销售，产品涵盖高性能功率器件与 IC 产品。在功率器件领域，公司主要产品包括 GreenMOS 系列超级结 MOSFET、SFGMOS 系列及 FSMOS 系列中低压屏蔽栅 MOSFET、TGBT 系列 IGBT 产品、SiC 器件（含 Si²C MOSFET）以及高密度功率模块。在 IC 产品领域，公司主要产品包括数模混合的快速充电控制芯片和开关电源控制芯片。公司致力于提供从信号处理、逻辑控制到功率输出的完整“控制—驱动—执行”全链路解决方案，逐步从高性能功率器件供应商，升级成为新一代数字能源管理系统解决方案的供应商。

本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 143,588.00 万元（含 143,588.00 万元），扣除发行费用后净额将用于新型功率器件技术和产品研发及产业化项目、新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目、研发中心建设项目和补充流动资金，系围绕公司主营业务展开。

近年来，国家持续将集成电路、先进半导体及功率半导体器件作为战略性新兴产业和未来产业的重要发展方向。2026 年 3 月，国务院发布《2026 年政府工作报告》，提出培育壮大新兴产业和未来产业，实施产业创新工程，打造集成电路、航空航天、生物医药、低空经济等新兴支柱产业。同月，全国人大发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》，提出聚焦战略必争领域和产业链供应链薄弱环节，全链条推动集成电路、先进材料等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。

围绕集成电路产业链完善及下游新兴应用需求，国家有关部门亦出台了多项具体支持政策。2023 年 1 月，工业和信息化部等六部门发布《关于推动能源电子产业发展的

指导意见》，提出加快功率半导体器件等在光伏发电、风力发电、电力传输、新能源汽车、轨道交通等领域的推广应用；2023年8月，工业和信息化部、科技部等四部门发布《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》，提出开展车用芯片、消费电子用芯片等应用标准研究，确立研制功率半导体器件等基础器件标准；2024年11月，商务部发布《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》，提出建设未来产业创新试验区，前瞻布局先进半导体技术及应用等重点产业。公司本次募投项目围绕新型功率器件、功率管理控制芯片及研发中心建设展开，产品应用覆盖数据中心电源、新能源汽车、光伏储能、工业电源等领域，符合国家关于集成电路关键技术攻关、功率半导体器件推广应用及可靠性能力提升的政策导向。

综上，本次募集资金投资项目将紧密围绕公司主营业务和科技创新领域开展，项目实施后将提升公司产品的测试能力和保障供应链安全，进一步实现自主可控；项目实施后，将显著增强公司在高端功率半导体领域的技术壁垒和产品供应能力，助力国产替代进程。本次募集资金投资项目符合国家产业政策，属于科技创新领域。

（二）本次募投项目促进公司科技创新水平提升

通过本次募投项目“新型功率器件技术和产品研发及产业化项目”的实施，公司将围绕硅基功率器件持续迭代、SiC/GaN功率器件研发及产业化、氧化镓器件前瞻布局等方向开展研发工作，进一步强化公司在高端功率半导体领域的技术攻关能力。项目实施后，公司将持续提升新型功率器件的研发深度和产品化能力，完善面向数据中心电源、新能源汽车、光伏储能、工业电机驱动等应用领域的技术和产品储备，有利于推动公司科技创新水平的持续提升。

通过本次募投项目“新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目”的实施，公司将在现有功率器件研发基础上，开展48V IBC数字控制器、数字电源DSP、智能eFuse控制器、高压固态断路器控制芯片等产品研发，推动研发方向由功率器件进一步延伸至功率管理控制芯片及配套驱动产品。项目实施有助于公司完善“控制—驱动—功率”相关技术布局，增强公司在高端功率半导体领域的研发能力、技术壁垒和产品供应能力，显著提升公司在产业链中的价值地位和议价能力，为公司长期可持续发展奠定坚实基础。

通过本次募投项目“研发中心建设项目”的实施，公司将扩充CNAS标准可靠性实验室、TO-247快速封装验证产线和模组实验室，研发中心建成后将提供全流程的可

靠性验证支撑、封装测试保障和模组级研发平台，形成“设计-封装验证-可靠性测试-模组开发”的完整研发闭环，显著提升公司整体研发效率和产品竞争力，进一步夯实公司科技创新能力。

五、本次募集资金对公司经营管理和财务状况的影响

（一）对公司经营管理的影响

本项目是在公司现有主营业务的基础上，结合国家产业政策和行业发展特点，以现有技术为依托实施的投资计划，通过对新型功率器件系列产品、新一代功率管理控制芯片的研发及产业化建设，提升公司研发能力，进一步拓展产品类别，完善公司产品矩阵。项目投产后，公司技术积累将进一步增加，切实增强公司市场竞争能力、可持续发展能力和抵抗市场变化风险的能力。本项目的实施将创造新的利润增长点，符合公司中长期的发展战略。

（二）对公司财务状况的影响

本次向不特定对象发行可转债募集资金到位后，公司的货币资金、总资产和总负债规模将相应增加，可为公司的后续发展提供有力保障。本次可转债转股前，公司使用募集资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。随着可转债持有人未来陆续转股，公司的资产负债率将逐步降低，有利于优化公司的资本结构、提升公司的抗风险能力。

本次发行募集资金到位后，可能短期内会导致公司净资产收益率、每股收益等财务指标出现一定幅度摊薄，但本次可转债募集资金投资项目符合国家产业政策要求和行业市场发展趋势，随着本次募投项目效益的实现，公司长期盈利能力将会得到显著增强，经营业绩预计会有一定程度的提升。

六、本次募集资金投资项目的资本性投入情况

本次募集资金投资项目的资本化情况如下表所示：

单位：万元

项目名称	序号	项目构成	投资金额	拟投入募集资金金额	其中：资本性投入
新型功率器件技术和产品研发及产业化项目	1	建设投资	7,623.00	7,623.00	7,623.00
	2	研发开发费用-人员费用	3,971.84	3,971.84	-
	3	研发开发费用-开发费用	40,950.00	40,950.00	39,600.00

	4	铺底流动资金	2,227.47	2,227.46	-
	小计		54,772.31	54,772.30	47,223.00
新一代功率管理控制芯片研发及产业化项目	1	建设投资	9,381.47	9,381.47	9,381.47
	2	研发开发费用-人员费用	4,934.40	4,934.40	-
	3	研发开发费用-开发费用	28,440.00	28,440.00	27,240.00
	4	铺底流动资金	3,142.00	3,141.83	-
	小计		45,897.87	45,897.70	36,621.47
研发中心建设项目	1	建设投资	18,506.00	18,506.00	18,506.00
	2	研发费用	14,412.00	14,412.00	-
	小计		32,918.00	32,918.00	18,506.00
补充流动资金项目	1	补充流动资金	10,000.00	10,000.00	-
募投项目合计	非资本性支出合计		41,237.53		
	非资本性支出占比		28.72%		

由上表可见，公司本次募投项目中非资本性支出为 41,237.53 万元，占本次发行拟使用募集资金总额的 28.72%，符合不超过 30%的规定。

第八节 历次募集资金运用

一、最近五年内募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

2022 年 2 月，发行人完成首次公开发行并于上交所科创板上市。最近五年内，发行人仅通过首次公开发行的方式募集资金，具体情况如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州东微半导体股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4040 号），同意公司首次公开发行股票注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,844,092 股，本次发行价格为每股人民币 130.00 元，募集资金总额为人民币 2,189,731,960.00 元，扣除保荐承销费 155,127,216.60 元（不含增值税）后的募集资金为 2,034,604,743.40 元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 1 月 28 日汇入公司募集资金监管账户。另扣除剩余保荐承销费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 28,048,153.30 元后，实际募集资金净额为人民币 2,006,556,590.10 元。

上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022 年 1 月 28 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕42 号）。

（二）募集资金管理与存放情况

公司募集资金全部存放在募集资金专户内，截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存储具体情况如下：

单位：元

银行名称	银行账号	余额
宁波银行股份有限公司苏州工业园区支行	75250122000318288	-
上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行	89010078801200006972	-
招商银行股份有限公司苏州独墅湖支行	512906076910302	-
交通银行股份有限公司苏州科技支行	325060700013000751708	-
苏州银行股份有限公司工业园区支行	51549300001103	23,581,989.67
中信银行股份有限公司苏州工业园区支行	8112001011868888888	-
合计		23,581,989.67

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金使用情况对照表

发行人前次募集资金净额为 200,655.66 万元，按照募集资金用途，计划用于“超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目”、“新结构功率器件研发及产业化项目”、“研发工程中心建设项目”和“科技与发展储备资金”项目。截至 2026 年 6 月 30 日，发行人实际已投入资金 198,901.03 万元。前次募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：			200,655.66			已累计使用募集资金总额：			198,901.03	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：				
						2022 年：			51,518.94	
						2023 年：			51,380.44	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2024 年：		35,796.31		
						2025 年：		40,527.18		
						2026 年 1-6 月：		19,678.16		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募	项目达到预
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承	募集后承	实际投资	募集前承	募集后承	实际投资	集后承诺	定可使用状
			诺投资金	诺投资金	金额	诺投资金	诺投资金	金额	投资金额	态日期（或
			额	额		额	额		的差额	截止日项目
										完工程度）
1	超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	20,414.58	20,414.58	20,639.92	20,414.58	20,414.58	20,639.92	225.34	2023 年 8 月
2	新结构功率器件研发及产业化项目	新结构功率器件研发及产业化项目	10,770.32	10,770.32	10,105.71	10,770.32	10,770.32	10,105.71	-664.61	2024 年 7 月
3	研发工程中心建设项目	研发工程中心建设项目	16,984.20	16,984.20	11,982.18	16,984.20	16,984.20	11,982.18	-5,002.02	2025 年 8 月
4	科技与发展储备资金	科技与发展储备资金	45,700.00	45,700.00	43,893.20	45,700.00	45,700.00	43,893.20	-1,806.80	不适用
承诺投资项目小计			93,869.10	93,869.10	86,621.01	93,869.10	93,869.10	86,621.01	-7,248.09	-
超募资金投向										
1	永久补充流动资金		-	104,184.70	109,678.16	-	104,184.70	109,678.16	5,493.46	不适用
2	回购股份		-	2,601.86	2,601.86	-	2,601.86	2,601.86	-	不适用
超募资金投向小计			-	106,786.56	112,280.02	-	106,786.56	112,280.02	5,493.46	-
合计			93,869.10	200,655.66	198,901.03	93,869.10	200,655.66	198,901.03	-1,754.63	-

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目实际投资金额 20,639.92 万元，募集后承诺投资金额 20,414.58 万元，实际投资总额超出承诺投资金额 225.34 万元，超出金额系闲置募集资金在存放期间所产生的利息收入净额和理财产品收益。

新结构功率器件研发及产业化项目实际投资金额 10,105.71 万元，募集后承诺投资金额 10,770.32 万元，实际投资总额低于承诺投资金额 664.61 万元。根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《苏州东微半导体股份有限公司募集资金管理制度》相关规定，节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于 1,000 万元的，可以豁免履行审议程序。公司已将该项目结余资金转入公司自有资金账户，用于永久补充流动资金。

研发工程中心建设项目实际投资金额 11,982.18 万元，募集后承诺投资金额 16,984.20 万元，实际投资总额低于承诺投资金额 5,002.03 万元。研发工程中心建设项目的差异主要来源于项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用管理的相关规定，秉持节约、合理、高效的原则，在保障项目质量并有效控制实施风险的前提下，加强各环节费用的管控与监督，通过对各项资源的合理调度与优化配置，有效降低了项目建设成本与费用支出，从而形成资金节余。公司于 2025 年 9 月 30 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目之“研发工程中心建设项目”已于彼时达成预定可使用状态，同意予以结项。为提高募集资金使用效率，优化资源配置，提升公司经营效益，公司将该项目节余募集资金用于永久补充流动资金。

科技与发展储备资金实际投资金额 43,893.20 万元，募集后承诺投资金额 45,700.00 万元，实际投资总额低于承诺投资金额的原因系项目尚未结项，后续仍将投入资金。

截至 2026 年 6 月 30 日，超募资金总额 106,786.56 万元已全部使用完毕，实际使用 2,601.86 万元用于回购股份、109,678.16 万元用于永久补充流动资金。实际投资总额超出承诺投资金额 5,493.46 万元，超出金额系闲置募集资金在存放期间所产生的利息收入净额和理财产品收益。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人不存在变更募集资金投资项目的情况。

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、截至 2026 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。

2、前次募集资金投资项目置换情况

2022 年 6 月 27 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 8,241.35 万元（其中项目预先投入 5,656.52 万元，发行费用 2,584.83 万元）。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司该情况进行了审验，并出具了《鉴证报告》（天健审〔2022〕7317 号）。公司保荐机构、监事会、独立董事对上述以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项均发表了同意意见。

截至 2026 年 6 月 30 日，前述以募集资金置换预先投入的自筹资金已实施完成，具体置换情况如下：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	募集资金计划使用金额	以自筹资金预先投入金额	置换金额
超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	20,414.58	20,414.58	4,668.76	4,668.76
新结构功率器件研发及产业化项目	10,770.32	10,770.32	987.76	987.76
合计	31,184.90	31,184.90	5,656.52	5,656.52

（四）临时闲置募集资金情况

公司于 2022 年 2 月 28 日召开了公司第一届董事会第八次会议、第一届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 150,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，到期后将归还至公司募集资金专项账户。

公司于 2023 年 2 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 145,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2024 年 2 月 22 日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 100,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2025 年 2 月 20 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 67,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

公司于 2026 年 2 月 12 日召开第二届董事会审计委员会第十五次会议及第二届董事会第二十次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币 21,900 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理均已收回。

（五）尚未使用募集资金情况

截至 2026 年 6 月 30 日，公司前次募集资金净额 200,655.66 万元，实际使用募集资金 198,901.03 万元，考虑闲置资金现金管理收益、已完结项目剩余募集资金补流的情况，尚未使用募集资金 2,358.20 万元，尚未使用募集资金比例为 1.18%。

1、未使用完毕的原因

未使用完毕的项目均系科技与发展储备资金项目，该项目细分为产业并购与补充流动资金。其中，产业并购及整合项目投资范围为汽车级功率器件设计、SiC 功率器件设计以及模块设计应用等方向投资并购国内外优质企业。目前公司正围绕上述方向持续寻源，尚需一定时间推进落实，故该部分募集资金暂未使用完毕。

2、剩余资金的使用计划和安排

公司将持续围绕汽车级功率器件设计、SiC 功率器件设计以及模块设计应用等方向推进相关工作，并根据项目进展及时合规使用募集资金。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次募集资金投资项目实现效益情况

公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表如下：

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年及一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益	备注
序号	项目名称			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年 1-6 月			
1	超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
2	新结构功率器件研发及产业化项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	研发工程中心建设项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	科技与发展储备资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目基于公司深槽超级结技术以及屏蔽栅技术的丰富积累，对高压超级结 MOSFET 产品及中低压屏蔽栅 MOSFET 产品的设

计及工艺技术等方面进行改进和提升。该项目的效益反映在公司的超级结与屏蔽栅功率器件整体经济效益中，无法单独核算。

新结构功率器件研发及产业化项目拟推出的新产品主要涉及 Tri-gate 结构 IGBT 器件设计及其工艺技术、Super-Silicon 超级硅 MOSFET 设计及其工艺技术及 Hybrid-FET 器件及其制造技术。其中，IGBT 产品是在公司原创的 Tri-gate 结构 IGBT 器件设计及其工艺技术的基础之上进一步提高开关速度性能的产品，适用于频率更高的电路场合；超级硅功率器件是公司在原创的超级硅器件技术之上进一步优化升级诞生的产品，适用于超高频率的电路场合，可实现接近 GaN、SiC 功率器件的效率；新一代高速大电流功率器件采用公司原创的 Hybrid-FET 器件技术，在大幅提高功率器件功率密度的同时，维持较高的开关速度。该项目的效益反映在公司的新结构功率器件整体经济效益中，无法单独核算。

研发工程中心建设项目有助于提升公司创新水平和效率，营造良好的实验环境，吸引高端技术人才的加入，加快科研成果转化，为公司的可持续发展提供更有力的技术支撑，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

科技与发展储备资金项目将有效增强公司的经营能力和研发能力，提高公司的偿债能力，降低公司的流动性风险及经营风险，从而提高公司的市场竞争力，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。

（七）前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明

截至 2026 年 6 月 30 日，发行人不存在前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况。

三、前次募集资金使用对发行人科技创新的作用

前次募集资金投资项目与公司业务关系密切，是对公司原有业务进行的升级、延伸与补充，全部投向科技创新领域。超级结与屏蔽栅功率器件产品升级及产业化项目基于公司深槽超级结技术以及屏蔽栅技术的丰富积累，对高压超级结 MOSFET 产品及中低压屏蔽栅 MOSFET 产品的设计及工艺技术等方面进行改进和提升。新结构功率器件研发及产业化项目推动公司发展 Tri-gate 结构 IGBT 器件设计及其工艺技术、Super-Silicon 超级硅 MOSFET 设计及其工艺技术及 Hybrid-FET 器件及其制造技术。研发工程中心建设项目，依靠公司在超级结 MOSFET 领域积累的技术领先优势及设计和开发平台，围

绕 SiC 器件、新型硅基高压功率器件方向进行产品技术的创新研发，开发新的技术方案，增加功率器件失效性和可靠性的固定资产投入，优化实验环境，提升测试效率，进一步保障产品质量。科技与发展储备资金有效增强公司的经营能力和研发能力，提高公司的偿债能力，降低公司的流动性风险及经营风险，进而提高了公司市场竞争力。募集资金投资项目契合公司产品线的拓展、延伸以及现有研发能力提高的需要，进一步提高公司的市场地位及核心竞争力。

四、会计师对前次募集资金运用所出具的专项报告结论

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州东微半导体股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（致同专字（2026）第 332A018352 号）结论为：东微半导体公司董事会编制的截至 2026 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如实反映了东微半导体公司前次募集资金使用情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

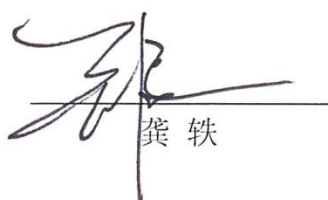
截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

第九节 声明

一、发行人及全体董事、审计委员会、高级管理人员声明

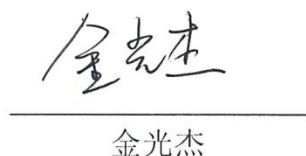
本公司及全体董事、审计委员会以及高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

全体董事：


龚 轶


王鹏飞

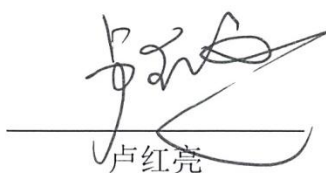

卢万松


金光杰


李 麟


黄清华


毕嘉露


卢红亮

苏州东微半导体股份有限公司

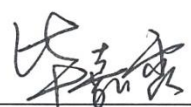


一、发行人及全体董事、审计委员会、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会以及高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

审计委员会成员：


黄清华


毕嘉露


金光杰

苏州东微半导体股份有限公司



一、发行人及全体董事、审计委员会、高级管理人员声明

本公司及全体董事、审计委员会以及高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

高级管理人员：



龚 轶



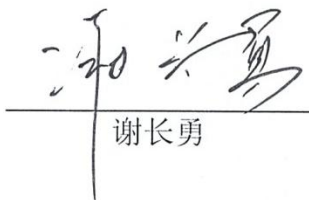
王鹏飞



卢万松



李 麟



谢长勇

苏州东微半导体股份有限公司



2016年9月30日

二、发行人实际控制人声明

本公司或本人承诺本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

公司实际控制人：


王鹏飞


龚 轶

苏州东微半导体股份有限公司



三、保荐人（主承销商）声明

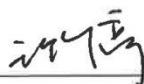
本公司已对募集说明书进行了核查，确认本募集说明书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

法定代表人：



陈 亮

保荐代表人：

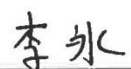


王竹亭



李 扬

项目协办人：



李 冰



中国国际金融股份有限公司

2026 年 9 月 30 日

保荐人董事长声明

本人已认真阅读苏州东微半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

董事长：



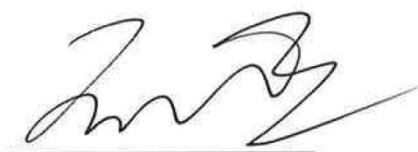
陈 亮



保荐人总裁声明

本人已认真阅读苏州东微半导体股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书的全部内容，确认募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

总裁：



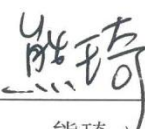
王曙光

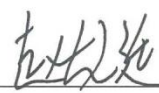


四、发行人律师声明

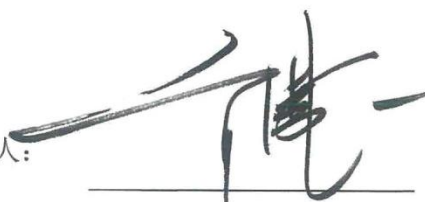
本所及经办律师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在募集说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

经办律师：


熊琦


赵龙廷

律师事务所负责人：


章靖忠


浙江天册律师事务所
2026年9月30日

五、会计师事务所声明

本所及签字注册会计师已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在募集说明书中引用的审计报告等文件的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

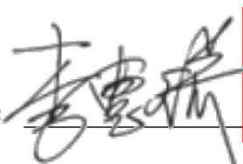
签字注册会计师：


中国注册会计师
傅智勇
110000152566
傅智勇



中国注册会计师
王强
330000012842
王强

会计师事务所负责人：


中国注册会计师
李惠琦
110000150172
李惠琦

致同会计师事务所（特殊普通合伙）



六、资信评级机构声明

本机构及签字资信评级人员已阅读募集说明书，确认募集说明书内容与本机构出具的资信评级报告不存在矛盾。本机构及签字资信评级人员对发行人在募集说明书中引用的资信评级报告的内容无异议，确认募集说明书不因引用上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

签字资信评级人员：

董斌

董斌

伏美亦

伏美亦

资信评级机构负责人：

张剑文

张剑文

中证鹏元资信评估股份有限公司

2026年9月20日



七、董事会关于本次发行的相关声明及承诺

（一）关于未来十二个月内其他股权融资计划的声明

关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融资计划，公司作出如下声明：

“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。”

（二）关于应对本次发行可转债摊薄即期回报采取的措施

由于本次发行可能导致公司每股收益有所下降，为有效防范即期回报被摊薄的风险，提高公司持续回报股东的能力，公司将采取多项措施，具体如下：

1、提升公司的盈利能力和发展潜力，扩大公司业务规模

公司将继续立足于高性能功率器件和控制驱动 IC 相关核心关键技术的研发，并加快推动技术产业化应用工作，一方面，公司将持续增强现有产品竞争力，拓展优质客户，提高公司的市场地位、盈利能力和综合实力；另一方面，公司也将继续加强对新产品的研发力度，加快推动新产品的产业化进程。

2、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

公司已按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范性文件的要求制定了募集资金管理办法，对募集资金的专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序、风险控制、信息披露、监督和责任追究等内容进行了明确的规定，公司将根据相关法律法规和募集资金管理办法的相关要求，规范募集资金的管理与使用，确保本次募集资金专项用于募投项目。

本次发行募集资金到位后，公司董事会将持续监督公司对募集资金进行专项存储、定期对募集资金进行内部审计、配合监管银行和保荐人对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

3、完善公司治理结构，提升经营和管理效率

公司将严格遵循相关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利；确保董事会能够按照法律法规和《公司章程》的规定行使职权，作出科学、

迅速和谨慎的决策；确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益；确保审计委员会能够独立有效地行使对董事、高级管理人员及公司财务的监督权和检查权；为公司发展提供制度保障，提升经营和管理效率。

4、完善利润分配政策，强化投资者回报机制

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司已制定了健全有效的利润分配政策和股东回报机制。公司将严格执行《公司章程》等相关规定，切实维护投资者合法权益，强化中小投资者权益保障机制，结合公司经营情况与发展规划，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，努力提升股东回报水平。

上述填补回报措施的实施，有利于增强公司的核心竞争力和持续盈利能力，增厚未来收益，填补股东回报。由于公司经营所面临的风险客观存在，上述填补回报措施的制定和实施，不等于对公司未来利润做出保证。

（三）公司实际控制人及其一致行动人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺

1、公司实际控制人及其一致行动人的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司实际控制人及其一致行动人作如下承诺：

（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

（2）本人将切实履行公司制定的有关填补回报相关措施以及本承诺。若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

（3）自本承诺出具之日起至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

2、公司董事、高级管理人员的承诺

为确保公司填补回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作如下

承诺：

（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

（3）本人承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

（5）公司未来如实施股权激励计划，本人承诺股权激励行权条件与填补回报措施的执行情况相挂钩；

（6）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本承诺。若违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，本人同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任；

（7）本承诺出具日至公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会、上海证券交易所等证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照监管机构的最新规定出具补充承诺。

苏州东微半导体股份有限公司董事会



第十节 备查文件

- （一）发行人最近三年一期的财务报告及审计报告；
- （二）保荐机构出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
- （三）法律意见书和律师工作报告；
- （四）董事会编制、股东会批准的关于前次募集资金使用情况的报告以及会计师出具的审核报告；
- （五）资信评级机构出具的资信评级报告；
- （六）其他与本次发行有关的重要文件。

附录一：发行人及其子公司拥有的境内注册商标

序号	商标	注册证号	专用权期限	国际分类	权利人	取得方式
1	Hybrid FET	57480526	2022. 01. 28– 2032. 01. 27	9	东微半导	原始取得
2	东微半导体	48513937	2021. 04. 07– 2031. 04. 06	9	东微半导	原始取得
3	 东微半导体 ORIENTAL SEMI	48519359	2021. 12. 28– 2031. 12. 27	9	东微半导	原始取得
4	ORIENTAL SEMI	48536604	2021. 04. 07– 2031. 04. 06	9	东微半导	原始取得
5		36288047	2019. 09. 28– 2029. 09. 27	9	东微半导	原始取得
6	SuperSi	22473389	2018. 02. 07– 2028. 02. 06	9	东微半导	原始取得
7	SFGMos	20372017	2017. 08. 07– 2027. 08. 06	9	东微半导	原始取得
8	FSMOS	18694823	2017. 01. 28– 2037. 01. 27	9	东微半导	原始取得
9	SFGT	18694824	2017. 05. 14– 2027. 05. 13	9	东微半导	原始取得
10	IGDT	18694825	2017. 01. 28– 2027. 01. 27	9	东微半导	原始取得
11	GreenMOS	15410291	2015. 11. 07– 2035. 11. 06	9	东微半导	原始取得
12	 Oriental Semiconductor	15222057	2015. 12. 07– 2035. 12. 06	9	东微半导	原始取得
13	东 微	15221981	2015. 10. 07– 2035. 10. 06	9	东微半导	原始取得
14	 ORIENTAL	15222006	2015. 12. 07– 2035. 12. 06	9	东微半导	原始取得
15	引擎魔法	13147516	2025. 04. 21– 2035. 04. 20	9	东微半导	原始取得

序号	商标	注册证号	专用权期限	国际分类	权利人	取得方式
16		13147496	2025. 01. 14– 2035. 01. 13	9	东微半导	原始取得
17		74882724	2024. 07. 14– 2034. 07. 13	40	深圳慧能泰	原始取得
18		71567331	2023. 10. 28– 2033. 10. 27	28	深圳慧能泰	原始取得
19		71568426	2023. 11. 07– 2033. 11. 06	21	深圳慧能泰	原始取得
20		71545634	2023. 11. 07– 2033. 11. 06	39	深圳慧能泰	原始取得
21		71568781	2023. 10. 28– 2033. 10. 27	41	深圳慧能泰	原始取得
22		71546909	2023. 10. 28– 2033. 10. 27	34	深圳慧能泰	原始取得
23		71565237	2023. 11. 07– 2033. 11. 06	8	深圳慧能泰	原始取得
24		71551501	2023. 10. 28– 2033. 10. 27	16	深圳慧能泰	原始取得
25		71559357	2023. 10. 28– 2033. 10. 27	1	深圳慧能泰	原始取得
26		71559383	2023. 11. 07– 2033. 11. 06	6	深圳慧能泰	原始取得
27		71547627	2023. 10. 28– 2033. 10. 27	4	深圳慧能泰	原始取得
28		71569203	2023. 10. 28– 2033. 10. 27	10	深圳慧能泰	原始取得

序号	商标	注册证号	专用权期限	国际分类	权利人	取得方式
29		71551484	2024. 01. 28– 2034. 01. 27	12	深圳慧能泰	原始取得
30		71567352	2023. 10. 28– 2033. 10. 27	37	深圳慧能泰	原始取得
31		71544432	2023. 11. 07– 2033. 11. 06	20	深圳慧能泰	原始取得
32		69378923	2024. 05. 21– 2034. 05. 20	9	深圳慧能泰	原始取得
33	HySwitch	68400506	2025. 04. 14– 2035. 04. 13	9	深圳慧能泰	原始取得
34	HyBitWatt	68403170	2025. 04. 14– 2035. 04. 13	9	深圳慧能泰	原始取得
35	HyCtrl	68406200	2025. 04. 14– 2035. 04. 13	9	深圳慧能泰	原始取得
36	BCR	49210754	2021. 05. 28– 2031. 05. 27	9	深圳慧能泰	原始取得
37		19541654	2017. 05. 21– 2027. 05. 20	9	深圳慧能泰	原始取得
38	慧能泰	18778741	2017. 02. 07– 2027. 02. 06	9	深圳慧能泰	原始取得

附录二：发行人及其子公司拥有的境外注册商标

序号	商标	注册号	商标类别	权利人	有效期至	注册国家或地区
1	Hynetek	UK00003675968	9	深圳慧能泰	2021.08.01-2031.08.02	英国
2	Hynetek	02210736	9	深圳慧能泰	2022.04.01-2032.03.31	台湾
3	Hynetek	6826398	9	深圳慧能泰	2022.08.23-2032.08.22	美国
4	Hynetek	018526716	9	深圳慧能泰	2021.08.04-2031.08.04	欧盟
5	HyBitWatt	018796019	9	深圳慧能泰	2022.11.18-2032.11.18	欧盟
6	HyCtrl	018796000	9	深圳慧能泰	2022.11.18-2032.11.18	欧盟
7	HySwitch	018795998	9	深圳慧能泰	2022.11.18-2032.11.18	欧盟
8	Hynetek	6537089	9	深圳慧能泰	2022.03.30-2032.03.30	日本
9	HySwitch	6696998	9	深圳慧能泰	2023.05.10-2033.05.10	日本
10	HyCtrl	6696999	9	深圳慧能泰	2023.05.10-2033.05.10	日本
11	HyBitWatt	6696997	9	深圳慧能泰	2023.05.10-2033.05.10	日本
12	HySwitch	5694072	9	深圳慧能泰	2022.11.22-2032.11.22	印度
13	HyCtrl	5694073	9	深圳慧能泰	2022.11.22-2032.11.22	印度
14	HyBitWatt	5694074	9	深圳慧能泰	2022.11.22-2032.11.22	印度
15	Hynetek	4020130180000	9	深圳慧能泰	2023.04.26-2033.04.26	韩国
16	HySwitch	4022122930000	9	深圳慧能泰	2024.06.24-2034.06.24	韩国
17	HyCtrl	4022122960000	9	深圳慧能泰	2024.06.24-2034.06.24	韩国
18	HyBitWatt	4022122970000	9	深圳慧能泰	2024.06.24-2034.06.24	韩国

附录三：发行人及其子公司拥有的境内专利

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限	取得方式	他项权利
1	东微半导	200810043070.X	半导体存储器器件、半导体存储器阵列及写入方法	发明	2008.01.23	20 年	原始取得	无
2	东微半导	200910027498.X	半导体存储器器件及其制造方法	发明	2009.05.08	20 年	原始取得	无
3	东微半导	200910034400.3	应用于半导体存储器的灵敏放大器电路及其工作方法	发明	2009.08.28	20 年	原始取得	无
4	东微半导	200910234799.X	半导体感光器件的控制方法	发明	2009.11.20	20 年	原始取得	无
5	东微半导	200910234800.9	半导体感光器件及其制造方法和应用	发明	2009.11.20	20 年	原始取得	无
6	东微半导	201010115106.8	一种沟槽型功率 MOS 晶体管的制造方法	发明	2010.02.26	20 年	原始取得	无
7	东微半导	201010115090.0	半导体存储器器件及其制造方法	发明	2010.02.26	20 年	原始取得	无
8	东微半导	201010254185.0	半导体存储器器件及其制造方法	发明	2010.08.16	20 年	原始取得	无
9	东微半导	201310119651.8	一种 U 形沟道的半导体器件及其制造方法	发明	2013.04.09	20 年	原始取得	无
10	东微半导	201310401785.9	一种半浮栅器件的制造方法及器件	发明	2013.09.06	20 年	原始取得	无
11	东微半导	201310433668.0	一种平面沟道的半浮栅器件的制造方法	发明	2013.09.23	20 年	原始取得	无
12	东微半导	201310513086.3	U 形沟道半导体感光器件及其制造方法	发明	2013.10.25	20 年	原始取得	无
13	东微半导	201310552605.7	半浮栅存储器及其制造方法和半浮栅存储器阵列	发明	2013.11.08	20 年	原始取得	无

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限	取得方式	他项权利
14	东微半导	201310554316.0	半导体感光器件及其制造方法	发明	2013.11.08	20 年	原始取得	无
15	东微半导	201310608082.3	一种应用于半浮栅存储单元的电流型灵敏放大器电路	发明	2013.11.27	20 年	原始取得	无
16	东微半导	201410128888.7	半浮栅存储器单元及半浮栅存储器阵列	发明	2014.04.01	20 年	原始取得	无
17	东微半导	201410142711.2	一种半导体存储器的制造方法及其半导体存储器	发明	2014.04.10	20 年	原始取得	无
18	东微半导	201410140574.9	一种半导体感光单元及其半导体感光单元阵列	发明	2014.04.09	20 年	原始取得	无
19	东微半导	201410276695.6	一种基于半浮栅存储器的读写控制电路	发明	2014.06.19	20 年	原始取得	无
20	东微半导	201410399024.9	一种功率 MOSFET 开关管源极驱动拓扑结构的控制电路	发明	2014.08.14	20 年	原始取得	无
21	东微半导	201410777931.2	一种高效率的 LED 驱动控制电路	发明	2014.12.16	20 年	原始取得	无
22	东微半导	201510182461.x	一种沟槽式分栅功率器件的制造方法	发明	2015.04.17	20 年	原始取得	无
23	东微半导	201510323899.5	一种分栅功率器件的制造方法	发明	2015.06.12	20 年	原始取得	无
24	东微半导	201510607295.3	一种集成栅极驱动功率器件及其制备方法	发明	2015.09.22	20 年	原始取得	无
25	东微半导	201610107822.9	超级结功率器件及其制造方法	发明	2016.02.26	20 年	原始取得	无
26	东微半导	201680010382.3	一种半导体超级结功率器件及其制造方法	发明	2016.04.08	20 年	原始取得	无
27	东微半导	201711058063.2	一种 IGBT 功率器	发明	2017.11.01	20 年	原始	无

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限	取得方式	他项权利
			件				取得	
28	东微半导	201711058065.1	一种功率晶体管	发明	2017.11.01	20 年	原始取得	无
29	东微半导	201711058085.9	一种沟槽型功率晶体管	发明	2017.11.01	20 年	原始取得	无
30	东微半导	201711059861.7	一种分栅结构的超结功率器件	发明	2017.11.01	20 年	原始取得	无
31	东微半导	201711058787.7	一种沟槽型 IGBT 功率器件	发明	2017.11.01	20 年	原始取得	无
32	东微半导	201711058078.9	一种分栅结构的功率晶体管	发明	2017.11.01	20 年	原始取得	无
33	东微半导	201711058074.0	一种分栅 IGBT 功率器件	发明	2017.11.01	20 年	原始取得	无
34	东微半导	201711058205.5	一种沟槽型超结功率器件	发明	2017.11.01	20 年	原始取得	无
35	东微半导	201711058204.0	一种功率 MOSFET 器件	发明	2017.11.01	20 年	原始取得	无
36	东微半导	201711489809.5	半导体功率器件	发明	2017.12.29	20 年	原始取得	无
37	东微半导	201711481167.4	半导体超结功率器件	发明	2017.12.29	20 年	原始取得	无
38	东微半导	201810982097.9	半导体功率器件	发明	2018.08.27	20 年	原始取得	无
39	东微半导	201811130401.3	一种半导体存储器	发明	2018.09.27	20 年	原始取得	无
40	东微半导	201811130811.8	半导体存储器及其制造方法	发明	2018.09.27	20 年	原始取得	无
41	东微半导	201811303497.9	半导体功率晶体管及其制造方法	发明	2018.11.02	20 年	原始取得	无
42	东微半导	201911184108.X	半导体功率器件	发明	2019.11.27	20 年	原始取得	无
43	东微半导	201911184048.1	半导体超结功率器件	发明	2019.11.27	20 年	原始取得	无

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限	取得方式	他项权利
44	东微半导	201911184109.4	超结功率器件	发明	2019.11.27	20 年	原始取得	无
45	东微半导	201911183421.1	IGBT 功率器件	发明	2019.11.27	20 年	原始取得	无
46	东微半导	201911204531.1	一种 IGBT 器件	发明	2019.11.29	20 年	原始取得	无
47	东微半导	201911202240.9	一种半导体超结功率器件	发明	2019.11.29	20 年	原始取得	无
48	东微半导	201911223282.0	半导体功率器件的制造方法	发明	2019.12.03	20 年	原始取得	无
49	东微半导	202010372056.5	半导体超结器件的制造方法	发明	2020.05.06	20 年	原始取得	无
50	东微半导	202010372375.6	半导体超结器件的制造方法	发明	2020.05.06	20 年	原始取得	无
51	东微半导	201980005569.8	IGBT 功率器件及其制造方法	发明	2019.01.30	20 年	原始取得	无
52	东微半导	202010373740.5	半导体器件	发明	2020.05.06	20 年	原始取得	无
53	东微半导	202010671084.7	半导体功率器件的制造方法	发明	2020.07.13	20 年	原始取得	无
54	东微半导	202011125896.8	半导体超结器件的制造方法	发明	2020.10.20	20 年	原始取得	无
55	东微半导	202011127631.1	半导体功率器件的制造方法	发明	2020.10.20	20 年	原始取得	无
56	东微半导	202011280137.9	半导体器件的制造方法	发明	2020.11.16	20 年	原始取得	无
57	东微半导	202110191691.8	半导体器件	发明	2021.02.19	20 年	原始取得	无
58	东微半导	202110191872.0	半导体功率器件	发明	2021.02.19	20 年	原始取得	无
59	东微半导	202110195555.6	半导体器件	发明	2021.02.19	20 年	原始取得	无

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限	取得方式	他项权利
60	东微半导	201980091300.6	IGBT 器件	发明	2019.11.27	20 年	原始取得	无
61	东微半导	202111128640.7	半导体超结功率器件	发明	2021.09.26	20 年	原始取得	无
62	东微半导	202111359631.9	半导体超结功率器件	发明	2021.11.17	20 年	原始取得	无
63	东微半导	202111359635.7	半导体超结功率器件	发明	2021.11.17	20 年	原始取得	无
64	东微半导	202111359722.2	半导体超结功率器件	发明	2021.11.17	20 年	原始取得	无
65	东微半导	202111534459.6	IGBT 器件	发明	2021.12.15	20 年	原始取得	无
66	东微半导	202111561080.4	IGBT 器件	发明	2021.12.15	20 年	原始取得	无
67	东微半导	202111576883.7	IGBT 器件及其制造方法	发明	2021.12.22	20 年	原始取得	无
68	东微半导	202111611956.1	半导体二极管	发明	2021.12.27	20 年	原始取得	无
69	东微半导	202210366889.X	IGBT 器件及其制造方法	发明	2022.04.08	20 年	原始取得	无
70	东微半导	202210367143.0	IGBT 器件的制造方法	发明	2022.04.08	20 年	原始取得	无
71	东微半导	202411371340.5	IGBT 器件的制造方法	发明	2024.09.29	20 年	原始取得	无
72	东微半导	202411371344.3	一种 IGBT 器件的制造方法	发明	2024.09.29	20 年	原始取得	无
73	东微半导	202411371352.8	IGBT 器件的制造方法	发明	2024.09.29	20 年	原始取得	无
74	东微半导	202122841877.1	半导体功率器件	实用新型	2021.11.19	10 年	原始取得	无
75	东微半导	202220614408.8	半导体功率器件	实用新型	2022.03.21	10 年	原始取得	无

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限	取得方式	他项权利
76	深圳慧能泰	202310334970.4	过温保护电路、电子芯片与 TYPE-C 数据线	发明	2023.03.27	20 年	原始取得	无
77	深圳慧能泰	202211619706.7	一种图腾柱无桥电路及电源模组	发明	2022.12.15	20 年	原始取得	无
78	深圳慧能泰	202411981181.0	一种通信方法、供电设备、充电设备及存储介质	发明	2024.12.31	20 年	原始取得	无
79	深圳慧能泰	202411799274.1	开关管控制方法、变换器及功率适配器	发明	2024.12.09	20 年	原始取得	无
80	深圳慧能泰	202211647397.4	一种图腾柱无桥电路及电源模组	发明	2022.12.21	20 年	原始取得	无
81	深圳慧能泰	202310216896.6	一种采样电路及其系统	发明	2023.02.27	20 年	原始取得	无
82	深圳慧能泰	202211387646.0	一种保护系统、充电线缆和充电装置	发明	2022.11.07	20 年	原始取得	无
83	深圳慧能泰	202111160255.0	一种保护电路及充电线缆	发明	2021.09.30	20 年	原始取得	无
84	深圳慧能泰	201610657211.1	一种 USBType-C 接口电路	发明	2016.08.11	20 年	原始取得	无
85	深圳慧能泰	201911294694.3	基于 USBType-C 接口电路的功率调节方法及其电路、电子设备	发明	2019.12.16	20 年	原始取得	无
86	深圳慧能泰	202110099906.3	USB 线缆的故障保护电路及其 USB 线缆	发明	2021.01.25	20 年	原始取得	无
87	深圳慧能泰	201710720401.8	一种开关控制方法及数字控制器	发明	2017.08.21	20 年	继受取得	无
88	深圳慧能泰	201710612281.X	开关控制方法、控制器、图腾柱无桥系统及电子设备	发明	2017.07.25	20 年	继受取得	无
89	深圳慧能泰	201611159938.3	一种图腾柱无桥电路及其系统	发明	2016.12.15	20 年	继受取得	无

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限	取得方式	他项权利
90	深圳慧能泰	202110145823.3	一种电子标签芯片与 TYPE-C 数据线	发明	2021.02.02	20 年	原始取得	无
91	深圳慧能泰	202110548912.2	一种隔离电源电路、隔离电源的控制方法与隔离电源	发明	2021.05.20	20 年	原始取得	无
92	深圳慧能泰	202221378509.6	一种充电线缆和充电装置	实用新型	2022.06.02	10 年	原始取得	无
93	深圳慧能泰	202110783825.5	一种电源电路和电源设备	发明	2021.07.12	20 年	原始取得	无
94	深圳慧能泰	202110120877.4	兼容式的充电线缆及其控制方法	发明	2021.01.28	20 年	原始取得	无
95	深圳慧能泰	202011425422.5	一种适用于多路 USB Type-C 的充电系统及充电方法	发明	2020.12.08	20 年	原始取得	无
96	深圳慧能泰	202010285396.4	一种充电线缆、充电装置以及充电线缆保护系统	发明	2020.04.13	20 年	原始取得	无
97	深圳慧能泰	201910967565.X	USB Type-C 接口电路及其充电方法、USB 装置及电子设备	发明	2019.10.12	20 年	原始取得	无
98	深圳慧能泰	202011389870.4	一种 USB 设备检测系统和方法	发明	2020.12.02	20 年	原始取得	无
99	深圳慧能泰	201911067863.X	基于 USB Type-C 接口电路的功率调节方法及其电路、电子设备	发明	2019.11.04	20 年	原始取得	无
100	深圳慧能泰	201610057340.7	一种电流采样电路及图腾柱无桥电路电流采样系统	发明	2016.01.27	20 年	原始取得	无
101	深圳慧能泰	201610326963.X	一种 USB Type-C 接口电路及其控制装置	发明	2016.05.17	20 年	原始取得	无
102	深圳慧能泰	201610327389.X	一种充电方法、充电控制电路以及充电器	发明	2016.05.17	20 年	原始取得	无

序号	权利人	专利号	专利名称	专利类型	申请日期	权利期限	取得方式	他项权利
103	深圳慧能泰	201720910841.5	一种图腾柱无桥系统及电子设备	实用新型	2017.07.25	10 年	继受取得	无
104	深圳慧能泰	201720254138.3	一种电流源电路、芯片及电子设备	实用新型	2017.03.15	10 年	原始取得	无
105	深圳慧能泰	201610152975.5	一种温度检测电路	发明	2016.03.17	20 年	原始取得	无
106	深圳慧能泰	201620870207.9	一种 USB Type-C 接口电路	实用新型	2016.08.11	10 年	原始取得	无
107	深圳慧能泰	201610055084.8	一种 USB Type-C 系统控制电路	发明	2016.01.27	20 年	原始取得	无
108	上海慧能泰	202411047899.2	PD 控制器与 PD 适配器	发明	2024.08.01	20 年	原始取得	无
109	上海慧能泰	202111315357.5	一种电压电流控制电路与集成芯片	发明	2021.11.08	20 年	原始取得	无
110	上海慧能泰	202223406873.1	一种芯片封装结构以及电子设备	实用新型	2022.12.19	10 年	原始取得	无

附录四：发行人及其子公司拥有的境外专利

序号	权属	注册地	专利名称	注册号	类别	申请日期	权利期限	取得方式
1	东微半导	美国	Semiconductor memory device and method of forming the same	8089801	发明	2008.10.09	20 年	原始取得
2	东微半导	美国	Manufacturing method for semi-floating gate device	9472561	发明	2014.04.01	20 年	原始取得
3	东微半导	美国	Semiconductor memory with U-shaped channel	9741727	发明	2014.04.01	20 年	原始取得
4	东微半导	美国	Power MOS transistor and manufacturing method therefor	9698248	发明	2014.08.04	20 年	原始取得
5	东微半导	美国	Method for manufacturing Split-Gate power device	9673299	发明	2016.03.15	20 年	原始取得
6	东微半导	美国	Semiconductor super-junction power device and manufacturing method therefor	10411116	发明	2016.04.08	20 年	原始取得
7	东微半导	美国	IGBT Power device	11081574	发明	2018.10.29	20 年	原始取得
8	东微半导	美国	Power MOSFET device	11296216	发明	2018.10.17	20 年	原始取得
9	东微半导	美国	Semiconductor power device	11189698	发明	2018.11.26	20 年	原始取得
10	东微半导	美国	IGBT Power device and fabrication method therefor	11450763	发明	2019.01.30	20 年	原始取得
11	东微半导	美国	IGBT device	11688799	发明	2019.12.06	20 年	原始取得
12	东微半导	美国	Semiconductor power device	12230703	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
13	东微半导	美国	IGBT device	11990538	发明	2019.11.27	20 年	原始取得
14	东微半导	美国	Semiconductor super-junction power device	11908889	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
15	东微半导	美国	IGBT power device	11721749	发明	2019.12.06	20 年	原始取得
16	东微半导	美国	Semiconductor super-junction power device	12027519	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
17	东微半导	美国	Method for manufacturing a semiconductor super-junction device	11626480	发明	2020.09.22	20 年	原始取得
18	东微半导	美国	Semiconductor power device	12094929	发明	2020.09.28	20 年	原始取得
19	东微半导	美国	Method for	11658209	发明	2020.09.22	20 年	原始取得

序号	权属	注册地	专利名称	注册号	类别	申请日期	权利期限	取得方式
			manufacturing a semiconductor super-junction device					取得
20	东微半导	美国	Manufacturing method of a semiconductor device	12051745	发明	2020.11.20	20 年	原始取得
21	东微半导	美国	Manufacturing method of semiconductor super-junction device	11973107	发明	2020.11.10	20 年	原始取得
22	东微半导	美国	Manufacturing method of semiconductor power device	12015078	发明	2020.11.12	20 年	原始取得
23	东微半导	美国	Semiconductor power device	12648201	发明	2021.11.18	20 年	原始取得
24	东微半导	美国	Semiconductor device including first p-type body region contact region	12581674	发明	2021.11.19	20 年	原始取得
25	东微半导	美国	Insulated gate bipolar transistor device	12402338	发明	2022.07.21	20 年	原始取得
26	东微半导	美国	Insulated gate bipolar transistor device	12396238	发明	2022.06.27	20 年	原始取得
27	东微半导	美国	Super junction semiconductor power device	12527044	发明	2022.06.10	20 年	原始取得
28	东微半导	美国	Super junction semiconductor power device	12501667	发明	2022.06.14	20 年	原始取得
29	东微半导	日本	スプリットゲート型パワーデバイスの製造方法	6310577	发明	2016.03.15	20 年	原始取得
30	东微半导	日本	半導体超接合パワーデバイス及びその製造方法	6423110	发明	2016.04.08	20 年	原始取得
31	东微半导	日本	トレンチ型パワートランジスタ	6732359	发明	2018.10.29	20 年	原始取得
32	东微半导	日本	半導体パワーデバイス	6990890	发明	2018.11.26	20 年	原始取得
33	东微半导	日本	I G B T パワーデバイス	6947915	发明	2018.10.29	20 年	原始取得
34	东微半导	日本	パワー M O S F E T デバイス	6995187	发明	2018.10.17	20 年	原始取得
35	东微半导	日本	半導体スーパージンクシオンパワーデバイス	7177551	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
36	东微半导	日本	半導体パワーデバイス	7173644	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
37	东微半导	日本	半導体スーパージンクシオンパワーデバイス	7173645	发明	2019.12.05	20 年	原始取得

序号	权属	注册地	专利名称	注册号	类别	申请日期	权利期限	取得方式
38	东微半导	日本	I G B T パワーデバイス	7177552	发明	2019.12.06	20 年	原始取得
39	东微半导	日本	I G B T デバイス	7162383	发明	2019.12.06	20 年	原始取得
40	东微半导	日本	半導体超接合デバイスの製造方法	7175449	发明	2020.09.22	20 年	原始取得
41	东微半导	日本	半導体超接合デバイスの製造方法	7175450	发明	2020.09.22	20 年	原始取得
42	东微半导	日本	炭化シリコンデバイス	7350373	发明	2020.11.20	20 年	原始取得
43	东微半导	日本	半導体デバイスの製造方法	7263644	发明	2020.11.20	20 年	原始取得
44	东微半导	日本	半導体パワーデバイス	7348677	发明	2020.09.28	20 年	原始取得
45	东微半导	日本	半導体パワーデバイスの製造方法	7313082	发明	2020.11.12	20 年	原始取得
46	东微半导	日本	半導体スーパー Junction デバイスの製造方法	7291429	发明	2020.11.10	20 年	原始取得
47	东微半导	日本	半導体デバイス	7556603	发明	2021.11.19	20 年	原始取得
48	东微半导	日本	I G B T デバイス	7482571	发明	2022.07.21	20 年	原始取得
49	东微半导	日本	半導体デバイス	7582708	发明	2021.11.19	20 年	原始取得
50	东微半导	日本	半導体超接合パワーデバイス	7471715	发明	2022.06.14	20 年	原始取得
51	东微半导	日本	半導体超接合パワーデバイス	7549929	发明	2022.06.10	20 年	原始取得
52	东微半导	日本	I G B T デバイス	7485433	发明	2022.06.27	20 年	原始取得
53	东微半导	日本	炭化ケイ素デバイスおよびその製造方法	7876247	发明	2024.06.14	20 年	原始取得
54	东微半导	韩国	MANUFACTURING METHOD FOR SPLIT-GATE POWER DEVICE	10-1812440	发明	2016.03.15	20 年	原始取得
55	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR SUPER-JUNCTION POWER DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR	10-1962834	发明	2016.04.08	20 年	原始取得
56	东微半导	韩国	TRENCH POWER TRANSISTOR	10-2206965	发明	2018.10.29	20 年	原始取得
57	东微半导	韩国	POWER MOSFET DEVICE	10-2288862	发明	2018.10.17	20 年	原始取得
58	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR POWER DEVICE	10-2246501	发明	2018.11.26	20 年	原始取得

序号	权属	注册地	专利名称	注册号	类别	申请日期	权利期限	取得方式
59	东微半导	韩国	IGBT POWER DEVICE	10-2292410	发明	2018.10.29	20 年	原始取得
60	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR POWER DEVICE	10-2586617	发明	2020.09.28	20 年	原始取得
61	东微半导	韩国	SILICON CARBIDE DEVICE	10-2572266	发明	2020.11.20	20 年	原始取得
62	东微半导	韩国	MANUFACTURING METHOD FOR SEMICONDUCTOR SUPER-JUNCTION DEVICE	10-2518360	发明	2020.09.22	20 年	原始取得
63	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR SUPER-JUNCTION POWER DEVICE	10-2752883	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
64	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR SUPER-JUNCTION POWER DEVICE	10-2519235	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
65	东微半导	韩国	IGBT DEVICE	10-2732312	发明	2019.12.06	20 年	原始取得
66	东微半导	韩国	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR POWER DEVICE	10-2578494	发明	2020.11.12	20 年	原始取得
67	东微半导	韩国	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR SUPER-JUNCTION DEVICE	10-2607110	发明	2020.11.10	20 年	原始取得
68	东微半导	韩国	SUPER JUNCTION POWER DEVICE	10-2717550	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
69	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR POWER DEVICE	10-2604725	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
70	东微半导	韩国	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR SUPER-JUNCTION DEVICE	10-2532028	发明	2020.09.22	20 年	原始取得
71	东微半导	韩国	METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE	10-2568095	发明	2020.11.20	20 年	原始取得
72	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR DEVICE	10-2741272	发明	2021.11.19	20 年	原始取得
73	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR DEVICE	10-2740867	发明	2021.11.19	20 年	原始取得
74	东微半导	韩国	IGBT DEVICE	10-2718032	发明	2022.06.27	20 年	原始取得
75	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR SUPERJUNCTION POWER DEVICE	10-2757674	发明	2022.06.14	20 年	原始取得
76	东微半导	韩国	IGBT DEVICE	10-2716945	发明	2022.07.21	20 年	原始取得

序号	权属	注册地	专利名称	注册号	类别	申请日期	权利期限	取得方式
77	东微半导	韩国	SEMICONDUCTOR SUPER JUNCTION POWER DEVICE	10-2682528	发明	2022.06.10	20 年	原始取得
78	东微半导	韩国	Method for Manufacturing Semiconductor Power Device	10-2600345	发明	2020.11.12	20 年	原始取得
79	东微半导	韩国	SILICON CARBIDE DEVICE AND MANUFACTURING METHOD THEREFOR	10-2871651	发明	2024.06.14	20 年	原始取得
80	东微半导	德国	Verfahren zur Herstellung eines Splitgate-Leistungsbauelements	112016000050	发明	2016.03.15	20 年	原始取得
81	东微半导	德国	Halbleiter - Super - Junction - Leistungsvorrichtung und Verfahren zum Herstellen derselben	112016001988	发明	2016.04.08	20 年	原始取得
82	东微半导	德国	GRABENLEISTUNGS TRANSISTOR	112018000209	发明	2018.10.29	20 年	原始取得
83	东微半导	德国	IGBT-Vorrichtung	112019006543	发明	2019.12.06	20 年	原始取得
84	东微半导	德国	Halbleiter-Super übergangs-Leistungsbau element	112019006590	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
85	东微半导	德国	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER HALBLEITER-LEISTUNGSVORRICHTUNG	112020002907	发明	2020.11.12	20 年	原始取得
86	东微半导	德国	VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER HALBLEITER-SUPER ÜBERGANGSVORRICHTUNG	112020002916	发明	2020.11.10	20 年	原始取得
87	东微半导	德国	Verfahren zur Herstellung eines Super-Junction-Halbleiterbauelements	112020003067	发明	2020.09.22	20 年	原始取得
88	东微半导	德国	Verfahren zur Herstellung eines Super-Junction-Halbleiterbauelements	112020003068	发明	2020.09.22	20 年	原始取得
89	东微半导	中国台湾	半導體功率器件	I731328	发明	2019.04.26	20 年	原始取得
90	深圳慧能泰	美国	Circuit for sampling current and system for sampling current of Totem-Pole bridgeless circuit	10067166	发明	2016.12.27	20 年	原始取得

序号	权属	注册地	专利名称	注册号	类别	申请日期	权利期限	取得方式
91	深圳慧能泰	美国	USB type-C interface circuit and charging method thereof, USB device	11075534	发明	2019.12.05	20 年	原始取得
92	深圳慧能泰	美国	Fault Detection Circuit, Method and Power Adapter	12313671	发明	2023.09.23	20 年	原始取得

附录五：发行人及其子公司拥有的软件著作权

序号	所有权人	软件名称	登记号	首次发表日	取得方式
1	深圳慧能泰	快充协议芯片自动化测试平台	2023SR1490922	2023.04.21	原始取得

附录六：发行人及其子公司拥有的集成电路布图设计专有权

序号	权利人	登记号	布图设计名称	申请日	公告日	取得方式
1	东微半导	BS.25500687X	GaNHEMT	2025.10.21	2026.03.13	原始取得
2	东微半导	BS.255000057	GaNHEMTESD Circuit	2025.01.07	2025.06.20	原始取得
3	东微半导	BS.245008152	GaNHEMT	2024.07.12	2024.12.11	原始取得
4	东微半导	BS.225001934	TGBT	2022.02.18	2022.11.30	原始取得
5	上海慧能泰	BS.255586213	HUSB332H-X1	2025.10.28	2026.03.27	原始取得
6	上海慧能泰	BS.255586302	HUSB365A-X1	2025.10.28	2026.03.27	原始取得
7	上海慧能泰	BS.255586191	HUSB332F-X1	2025.10.28	2026.03.27	原始取得
8	上海慧能泰	BS.255507089	HUSB353-X1	2025.02.06	2025.08.01	原始取得
9	上海慧能泰	BS.255507062	HUSB237-X1	2025.02.06	2025.08.01	原始取得
10	上海慧能泰	BS.255507070	HUSB338E-X1	2025.02.06	2025.08.01	原始取得
11	上海慧能泰	BS.245543325	HUSB602-X1	2024.06.19	2024.12.13	原始取得
12	上海慧能泰	BS.245511512	U2209_S0AR0	2024.02.26	2024.08.23	继受取得
13	上海慧能泰	BS.245511652	U2305_S0AR0	2024.02.26	2024.08.23	继受取得
14	上海慧能泰	BS.23560612X	HUSB332E-X1	2023.12.12	2024.06.26	原始取得
15	上海慧能泰	BS.235606103	HP2001-X1	2023.12.12	2024.06.26	原始取得
16	上海慧能泰	BS.235606111	HUSB332D-X1	2023.12.12	2024.06.26	原始取得
17	上海慧能泰	BS.245511520	U2210_S0AR0	2024.02.26	2024.08.23	继受取得
18	上海慧能泰	BS.24551161X	U2221_S0AR0	2024.02.26	2024.08.23	继受取得
19	上海慧能泰	BS.245511636	U2223_S0AR0	2024.02.26	2024.08.23	继受取得
20	上海慧能泰	BS.225622203	HUSB601-X1	2022.12.01	2023.07.28	原始取得
21	上海慧能泰	BS.22562219X	HUSB338C-X1	2022.12.01	2023.07.28	原始取得
22	上海慧能泰	BS.225592894	HUSB350C-X1	2022.08.30	2023.03.08	原始取得

序号	权利人	登记号	布图设计名称	申请日	公告日	取得方式
23	上海慧能泰	BS.225592827	HUSB320-X1	2022.08.30	2023.03.08	原始取得
24	上海慧能泰	BS.225593033	HUSB362-X1	2022.08.31	2023.03.08	原始取得
25	上海慧能泰	BS.22559272X	HUSB311C-X1	2022.08.30	2023.03.08	原始取得
26	上海慧能泰	BS.225592843	HUSB332C-X1	2022.08.30	2023.03.08	原始取得
27	上海慧能泰	BS.225592924	HUSB361-X1	2022.08.30	2023.03.08	原始取得
28	深圳慧能泰	BS.25550702X	HUSB366A	2025.02.06	2025.07.04	原始取得
29	深圳慧能泰	BS.255507054	U2312_D0AR0	2025.02.06	2025.07.04	原始取得
30	深圳慧能泰	BS.255506961	HP1020	2025.02.06	2025.07.04	原始取得
31	深圳慧能泰	BS.255507011	HP6000C	2025.02.06	2025.07.04	原始取得
32	深圳慧能泰	BS.255507046	HUSB368	2025.02.06	2025.07.04	原始取得
33	深圳慧能泰	BS.245543716	HUSB382	2024.06.20	2024.12.11	原始取得
34	深圳慧能泰	BS.24554349X	HUSB602	2024.06.19	2024.12.11	原始取得
35	深圳慧能泰	BS.245543392	HUSB237	2024.06.19	2024.12.11	原始取得
36	深圳慧能泰	BS.24554335X	HP1020J	2024.06.19	2024.12.11	原始取得
37	深圳慧能泰	BS.245543422	HUSB353	2024.06.19	2024.12.11	原始取得
38	深圳慧能泰	BS.245543708	HUSB351A	2024.06.20	2024.12.11	原始取得
39	深圳慧能泰	BS.245543686	HUSB332F	2024.06.20	2024.12.11	原始取得
40	深圳慧能泰	BS.245543694	HUSB338D	2024.06.20	2024.12.11	原始取得
41	深圳慧能泰	BS.245543465	HUSB365A	2024.06.19	2024.12.11	原始取得
42	深圳慧能泰	BS.24551483X	U2314_D0AR0	2024.03.08	2024.09.06	原始取得
43	深圳慧能泰	BS.245514805	P2317_D0BR0	2024.03.08	2024.09.06	原始取得
44	深圳慧能泰	BS.245514791	P2202_G1AR0	2024.03.08	2024.09.06	原始取得
45	深圳慧能泰	BS.245514813	U2309_D0AR0	2024.03.08	2024.09.06	原始取得
46	深圳慧能泰	BS.245511431	P2211_C0AR0	2024.02.23	2024.08.23	原始取得

序号	权利人	登记号	布图设计名称	申请日	公告日	取得方式
47	深圳慧能泰	BS.245511539	U2217_Y0AR0	2024.02.26	2024.08.23	原始取得
48	深圳慧能泰	BS.245511458	P2313_S0AR0	2024.02.23	2024.08.23	原始取得
49	深圳慧能泰	BS.24551144X	P2227_S0AR0	2024.02.23	2024.08.23	原始取得
50	深圳慧能泰	BS.245511415	MANGO_C0BR0	2024.02.23	2024.08.23	原始取得
51	深圳慧能泰	BS.245511385	bull_s0ar0	2024.02.23	2024.08.23	原始取得
52	深圳慧能泰	BS.245511407	DRAGON_S0BR0	2024.02.23	2024.08.23	原始取得
53	深圳慧能泰	BS.235604100	HP2001	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
54	深圳慧能泰	BS.235609684	HUSB239B	2023.12.20	2024.06.26	原始取得
55	深圳慧能泰	BS.235604143	HP6000	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
56	深圳慧能泰	BS.235603937	HUSB332H	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
57	深圳慧能泰	BS.235603996	HUSB333	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
58	深圳慧能泰	BS.235604097	HP1010	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
59	深圳慧能泰	BS.235609692	HUSB361B	2023.12.20	2024.06.26	原始取得
60	深圳慧能泰	BS.235604054	HUSB363	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
61	深圳慧能泰	BS.235604119	HP3010	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
62	深圳慧能泰	BS.235604038	HUSB338E	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
63	深圳慧能泰	BS.235604070	HP1001	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
64	深圳慧能泰	BS.23560383X	HP6000B	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
65	深圳慧能泰	BS.235603880	HUSB332E	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
66	深圳慧能泰	BS.235603864	HUSB268H	2023.12.06	2024.06.26	原始取得
67	深圳慧能泰	BS.235585793	HUSB335	2023.10.17	2024.05.17	原始取得
68	深圳慧能泰	BS.235585734	HUSB320B	2023.10.17	2024.05.17	原始取得
69	深圳慧能泰	BS.235530328	HP3600	2023.04.28	2023.11.10	原始取得
70	深圳慧能泰	BS.235530352	HP3600A	2023.04.28	2023.11.10	原始取得

序号	权利人	登记号	布图设计名称	申请日	公告日	取得方式
71	深圳慧能泰	BS.235530395	HUSB332D	2023.04.28	2023.11.10	原始取得
72	深圳慧能泰	BS.235530379	HUSB251	2023.04.28	2023.11.10	原始取得
73	深圳慧能泰	BS.235530360	HUSB239	2023.04.28	2023.11.10	原始取得
74	深圳慧能泰	BS.23553031X	HP3020	2023.04.28	2023.11.10	原始取得
75	深圳慧能泰	BS.235530417	HUSB366	2023.04.28	2023.11.10	原始取得
76	深圳慧能泰	BS.22562205X	HP3000	2022.12.01	2023.07.28	原始取得
77	深圳慧能泰	BS.225622084	HUSB268	2022.12.01	2023.07.28	原始取得
78	深圳慧能泰	BS.225622173	HUSB332C	2022.12.01	2023.07.28	原始取得
79	深圳慧能泰	BS.225622122	HUSB328	2022.12.01	2023.07.28	原始取得
80	深圳慧能泰	BS.225622106	HUSB311A	2022.12.01	2023.07.28	原始取得
81	深圳慧能泰	BS.225622181	HUSB365	2022.12.01	2023.07.28	原始取得
82	深圳慧能泰	BS.225555190	HUSB361A	2022.05.24	2022.12.16	原始取得
83	深圳慧能泰	BS.225521016	HUSB332B	2022.02.25	2022.12.02	原始取得
84	深圳慧能泰	BS.225521377	HUSB362	2022.02.25	2022.12.02	原始取得
85	深圳慧能泰	BS.225520982	HUSB320	2022.02.25	2022.12.02	原始取得
86	深圳慧能泰	BS.225521067	HUSB361	2022.02.25	2022.12.02	原始取得
87	深圳慧能泰	BS.225521040	HUSB360B	2022.02.25	2022.12.02	原始取得
88	深圳慧能泰	BS.225521032	HUSB350C	2022.02.25	2022.12.02	原始取得
89	深圳慧能泰	BS.225520966	HUSB311C	2022.02.25	2022.12.02	原始取得
90	深圳慧能泰	BS.21557964X	HUSB311	2021.07.07	2021.12.17	原始取得
91	深圳慧能泰	BS.215577817	HUSB601	2021.07.02	2021.12.03	原始取得
92	深圳慧能泰	BS.215529413	HUSB338C	2021.03.24	2021.07.07	原始取得
93	深圳慧能泰	BS.215504534	HUSB352	2021.01.14	2021.06.04	原始取得
94	深圳慧能泰	BS.205589685	HUSB332A	2020.10.23	2021.03.03	原始取得

序号	权利人	登记号	布图设计名称	申请日	公告日	取得方式
95	深圳慧能泰	BS.205589626	HUSB238	2020.10.23	2021.02.05	原始取得
96	深圳慧能泰	BS.205589650	HUSB305	2020.10.23	2021.02.05	原始取得
97	深圳慧能泰	BS.205589693	HUSB360	2020.10.23	2021.02.05	继受取得
98	深圳慧能泰	BS.205507115	HUSB350A	2020.03.04	2020.06.12	原始取得
99	深圳慧能泰	BS.205507131	HUSB351	2020.03.04	2020.06.12	原始取得
100	深圳慧能泰	BS.195597869	HUSB331A	2019.06.26	2020.01.01	原始取得
101	深圳慧能泰	BS.195597885	HUSB350	2019.06.26	2020.01.01	原始取得
102	深圳慧能泰	BS.195597877	HUSB332	2019.06.26	2020.01.01	原始取得
103	深圳慧能泰	BS.195593685	HUSB339	2019.05.31	2019.12.27	原始取得
104	深圳慧能泰	BS.185548059	HUSB338	2018.02.05	2018.10.26	原始取得
105	深圳慧能泰	BS.185548040	HUSB330	2018.02.05	2018.10.26	原始取得

附录七：债券持有人会议规则主要内容

债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的生效决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、投反对票或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次可转债的持有人，下同）均有同等约束力。

投资者通过认购、交易、受让、继承或其他合法方式持有本次可转债，均视为其同意《债券持有人会议规则》的所有规定并接受该规则的约束。

本节仅列示了本次可转债之《债券持有人会议规则》的主要内容，投资者在作出相关决策时，请查阅《债券持有人会议规则》的全文。

一、债券持有人行使权利的形式

债券持有人会议由全体债券持有人依据《债券持有人会议规则》组成，债券持有人会议依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集和召开，并对《债券持有人会议规则》规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。

二、债券持有人会议规则的主要条款

（一）债券持有人的权利和义务

1、债券持有人的权利

- （1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
- （2）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转债转为公司 A 股股票；
- （3）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
- （4）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转换公司债券；
- （5）依照法律、行政法规及公司章程的规定获得有关信息；
- （6）按《募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；
- （7）依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；
- （8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

2、债券持有人的义务

- （1）遵守公司发行本次可转债条款的相关规定；
- （2）依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；
- （3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
- （4）除法律法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本次可转债的本金和利息；
- （5）法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。

（二）债券持有人会议的权限范围

（1）当公司提出变更本次《募集说明书》约定的方案时，对是否同意公司的建议作出决议，但债券持有人会议不得作出决议同意公司不支付本次债券本息、变更本次债券利率和期限、取消《募集说明书》中的赎回或回售条款等；

（2）当公司未能按期支付可转换公司债券本息时，对是否同意相关解决方案作出决议，对是否通过诉讼等程序强制公司和担保人（如有）偿还债券本息作出决议，对是否参与公司的整顿、和解、重组或者破产的法律程序作出决议；

（3）当公司减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产时，对是否接受公司提出的建议，以及行使债券持有人依法享有的权利方案作出决议；

（4）当担保人（如有）或担保物（如有）发生重大不利变化时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（5）当发生对债券持有人权益有重大影响的事项时，对行使债券持有人依法享有权利的方案作出决议；

（6）对变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议作出决议；

（7）在法律规定许可的范围内对本规则的修改作出决议；

（8）法律、行政法规和规范性文件规定应当由债券持有人会议作出决议的其他情形。

（三）债券持有人会议的召集

债券持有人会议由公司董事会或债券受托管理人负责召集。

召集人应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起 30 日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开 15 日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券持有人会议：

- （1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
- （2）拟修改《债券持有人会议规则》；
- （3）拟变更、解聘债券受托管理人或变更受托管理协议的主要内容；
- （4）公司不能按期支付本次可转债本息；
- （5）公司发生减资（因实施股权激励或员工持股计划回购股份、业绩承诺回购股份或者公司为维护公司价值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
- （6）公司分立、被托管、解散、申请破产或者依法进入破产程序；
- （7）担保人或担保物（如有）发生重大变化；
- （8）公司董事会、单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人及债券受托管理人书面提议召开；
- （9）公司管理层不能正常履行职责，导致公司债务清偿能力面临严重不确定性；
- （10）公司提出重大债务重组方案的；
- （11）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；
- （12）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转换公司债券持有人会议规则的规定，应当召开债券持有人会议的其他情形。

下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议：

- （1）公司董事会；
- （2）单独或合计持有本次可转债总额 10%以上未偿还债券面值的债券持有人；
- （3）债券受托管理人；

（4）法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。

《债券持有人会议规则》第十条规定的事项发生之日起 15 日内，如公司董事会或债券受托管理人未能按《债券持有人会议规则》或法律法规、上交所业务规则及《公司章程》规定履行其职责，单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

债券持有人会议通知发出后，除非因不可抗力，不得变更债券持有人会议召开时间或取消会议，也不得变更会议通知中列明的议案；因不可抗力确需变更债券持有人会议召开时间、取消会议或者变更会议通知中所列议案的，召集人应在原定债券持有人会议召开日前至少 5 个交易日内以公告的方式通知全体债券持有人并说明原因，但不得因此而变更债券持有人债权登记日。债券持有人会议补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

债券持有人会议通知发出后，如果召开债券持有人会议的拟决议事项消除的，召集人可以公告方式取消该次债券持有人会议并说明原因。

债券持有人会议召集人应在证券监管部门指定的媒体上公告债券持有人会议通知。债券持有人会议的通知应包括以下内容：

- （1）会议召开的时间、地点、召集人及表决方式；
- （2）提交会议审议的事项；
- （3）以明显的文字说明全体债券持有人均有权出席债券持有人会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决；
- （4）确定有权出席债券持有人会议的债券持有人之债权登记日；
- （5）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续，包括但不限于代理债券持有人出席会议的代理人的授权委托书以及送达时间和地点；
- （6）召集人名称、会务常设联系人姓名及电话号码；
- （7）召集人需要通知的其他事项。

债券持有人会议的债权登记日不得早于债券持有人会议召开日期之前 10 日，并不得晚于债券持有人会议召开日期之前 3 日。于债权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的本次未偿还债券的可转债持

有人，为有权出席该次债券持有人会议的债券持有人。

债券持有人会议应设置会场，以现场会议形式召开。公司亦可采取网络或证券监管机构认可的其他方式为债券持有人参加会议提供便利。债券持有人通过上述方式参加会议的，视为出席。

符合《债券持有人会议规则》规定发出债券持有人会议通知的机构或人员，为当次会议召集人。

召集人召开债券持有人会议时应当聘请律师对以下事项出具法律意见：

- （1）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件、公司章程及《债券持有人会议规则》的规定；
- （2）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- （3）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- （4）应召集人要求对其他有关事项出具法律意见。

（四）债券持有人会议的议案、出席人员及其权利

提交债券持有人会议审议的议案由召集人负责起草。议案内容应符合法律、法规的规定，在债券持有人会议的权限范围内，并有明确的议题和具体决议事项。

债券持有人会议审议事项由召集人根据《债券持有人会议规则》第八条和第十条的规定决定。

单独或合并代表持有本次可转债未偿还债券面值总额 10%以上的债券持有人有权向债券持有人会议提出临时议案。公司及其关联方可参加债券持有人会议并提出临时议案。临时提案人应不迟于债券持有人会议召开之前 10 日，将内容完整的临时提案提交召集人，召集人应在收到临时提案之日 5 日内发出债券持有人会议补充通知，并公告提出临时议案的债券持有人姓名或名称、持有债权的比例和临时提案内容，补充通知应在刊登会议通知的同一指定媒体上公告。

除上述规定外，召集人发出债券持有人会议通知后，不得修改会议通知中已列明的提案或增加新的提案。债券持有人会议通知（包括增加临时提案的补充通知）中未列明的提案，或不符合《债券持有人会议规则》内容要求的提案不得进行表决并作出决议。

债券持有人可以亲自出席债券持有人会议并表决，也可以委托代理人代为出席并表决。债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

债券持有人本人出席会议的，应出示本人身份证明文件和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，债券持有人法定代表人或负责人出席会议的，应出示本人身份证明文件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证明文件、被代理人（或其法定代表人、负责人）依法出具的授权委托书、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件。

债券持有人出具的委托他人出席债券持有人会议的授权代理委托书应当载明下列内容：

- （1）代理人的姓名、身份证号码；
- （2）代理人的权限，包括但不限于是否具有表决权；
- （3）分别对列入债券持有人会议议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；
- （4）授权代理委托书签发日期和有效期限；
- （5）委托人签字或盖章。

授权委托书应当注明，如果债券持有人不作具体指示，债券持有人代理人是否可以按自己的意思表决。授权委托书应在债券持有人会议召开 24 小时之前送交债券持有人会议召集人。

召集人和律师应依据证券登记结算机构提供的、在债权登记日交易结束时持有本次可转债的债券持有人名册共同对出席会议的债券持有人的资格和合法性进行验证，并登记出席债券持有人会议的债券持有人及其代理人的姓名或名称及其所持有表决权的本次可转债的张数。上述债券持有人名册应由公司从证券登记结算机构取得，并无偿提供给召集人。

（五）债券持有人会议的召开

债券持有人会议采取现场方式召开，也可以采取网络、通讯等其他方式召开。

债券持有人会议应由公司董事会或债券受托管理人委派出席会议的授权代表担任会议主席并主持。如公司董事会或债券受托管理人未能履行职责时，由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）以所代表的本次债券表决权过半数选举产生一名债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议；如在该次会议开始后1小时内未能按前述规定共同推举出会议主持，则应当由出席该次会议的持有本次未偿还债券表决权总数最多的债券持有人（或债券持有人代理人）担任会议主席并主持会议。

应单独或合并持有本次债券表决权总数10%以上的债券持有人的要求，公司应委派一名董事或高级管理人员出席债券持有人会议。除涉及公司商业秘密或受适用法律和上市公司信息披露规定的限制外，出席会议的公司董事或高级管理人员应当对债券持有人的质询和建议作出答复或说明。

下列机构和人员可以列席债券持有人会议：债券发行人（即公司）或其授权代表、公司董事和高级管理人员、债券托管人、质权代理人（如有）、债券担保人（如有）以及经会议主席同意的本次债券的其他重要相关方，上述人员或相关方有权在债券持有人会议上就相关事项进行说明。除该等人员或相关方因持有公司本次可转债而享有表决权的情况外，该等人员或相关方列席债券持有人会议时无表决权。

会议主席有权经会议同意后决定休会、复会及改变会议地点。经会议决议要求，会议主席应当按决议修改会议时间及改变会议地点。休会后复会的会议不得对原有会议议案范围外的事项做出决议。

（六）债券持有人会议的表决、决议及会议记录

向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有人会议的债券持有人或其正式委托的代理人投票表决。每一张未偿还的债券（面值为人民币100元）拥有一票表决权。

公告的会议通知载明的各项拟审议事项或同一拟审议事项内并列的各项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不能作出决议外，会议不得对会议通知载明的拟审议事项进行搁置或不予表决。会议对同一事项有不同提案的，应以提案提出的时间顺序进行表决，并作出决议。

债券持有人会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有人会议审议拟审议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。

债券持有人会议采取记名方式投票表决。债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

同一表决权只能选择现场、网络、通讯或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有人会议的出席张数：

- （1）债券持有人为持有公司 5%以上股份的公司股东；
- （2）上述公司股东、公司及担保人（如有）的关联方。

会议设计票人、监票人各一名，负责会议计票和监票。计票人、监票人由会议主席推荐并由出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）担任。与公司有关联关系的债券持有人及其代理人不得担任计票人、监票人。

每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有人（或债券持有人代理人）同一公司授权代表参加清点，并由清点人当场公布表决结果。律师负责见证表决过程。

会议主席根据表决结果确认债券持有人会议决议是否获得通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。

会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数进行重新点票；如果会议主席未提议重新点票，出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）对会议主席宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求重新点票，会议主席应当即时组织重新点票。

除《债券持有人会议规则》另有规定外，债券持有人会议作出的决议，须经出席（包括现场、网络、通讯等方式参加会议）本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持表决权超过二分之一同意方为有效。

债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、可转换公司债券募集说明书和《债券持有人会议规则》的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。

任何与本次可转债有关的决议如果导致变更公司与债券持有人之间的权利义务关系的，除法律、法规、部门规章和可转换公司债券募集说明书明确规定债券持有人作出的决议对公司有约束力外：

（1）如该决议是根据债券持有人的提议作出的，该决议经债券持有人会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力；

（2）如果该决议是根据公司的提议作出的，经债券持有人会议表决通过后，对公司和全体债券持有人具有法律约束力。

债券持有人会议召集人应在债券持有人会议作出决议之日后二个交易日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时间、地点、方式、召集人和主持人，出席会议的债券持有人和代理人人数，出席会议的债券持有人和代理人所代表表决权的本次可转债张数及占本次可转债总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容以及相关监管部门要求的内容。

债券持有人会议应有会议记录。会议记录记载以下内容：

（1）召开会议的时间、地点、议程和召集人名称或姓名；

（2）会议主持人以及出席或列席会议的人员姓名，以及会议见证律师、计票人、监票人和清点人的姓名；

（3）出席会议的债券持有人和代理人人数、所代表表决权的本次可转债张数及出席会议的债券持有人（或债券持有人代理人）所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总张数的比例；

（4）对每一拟审议事项的发言要点；

（5）每一表决事项的表决结果；

（6）债券持有人的质询意见、建议及公司董事、高级管理人员的答复或说明等内容；

（7）法律、行政法规、规范性文件以及债券持有人会议认为应当载入会议记录的其他内容。

会议召集人和主持人应当保证债券持有人会议记录内容真实、准确和完整。债券持有人会议记录由出席会议的会议主持人、召集人（或其委托的代表）、记录员和监票人签名。债券持有人会议记录、表决票、出席会议人员的签名册、授权委托书、律师出具的法律意见书等会议文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年。

召集人应保证债券持有人会议连续进行，直至形成最终决议。因不可抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不能正常召开或不能作出决议的，应采取必要的措施尽快恢复召开会议或直接终止本次会议，并将上述情况及时公告。同时，召集人应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所报告。对于干扰会议、寻衅滋事和侵犯债券持有人合法权益的行为，应采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

公司董事会应严格执行债券持有人会议决议，代表债券持有人及时就有关决议内容与有关主体进行沟通，督促债券持有人会议决议的具体落实。